



微信公众号

官网: www.gpixel.com

邮箱: info@gpixel.com

长光辰芯(总部)

长春长光辰芯微电子股份有限公司

地址: 吉林省长春市经开区自由大路7691号光电信息产业园一期1号、5号办公楼

电话: 0431-85077785

长光辰芯(杭州子公司)

杭州长光辰芯微电子有限公司

地址: 浙江省杭州市滨江区建业路599号华业发展中心31层3101-3109室

电话: 0571-87718606-88

长光辰芯(大连子公司)

大连长光辰芯微电子有限公司

地址: 辽宁省大连市高新技术产业园区汇贤园7号11层#05D室

电话: 0411-39937666

GPIXEL EUROPE

Gpixel NV

地址: Copernicuslaan 60, 2018 Antwerpen, Belgium

电话: +32-33034442

GPIXEL JAPAN

Gpixel Japan Inc.

地址: TOC Osaki Building 18th Floor, 1-6-1 Osaki,

Shinagawa-ku, Tokyo, 141-0032 Japan

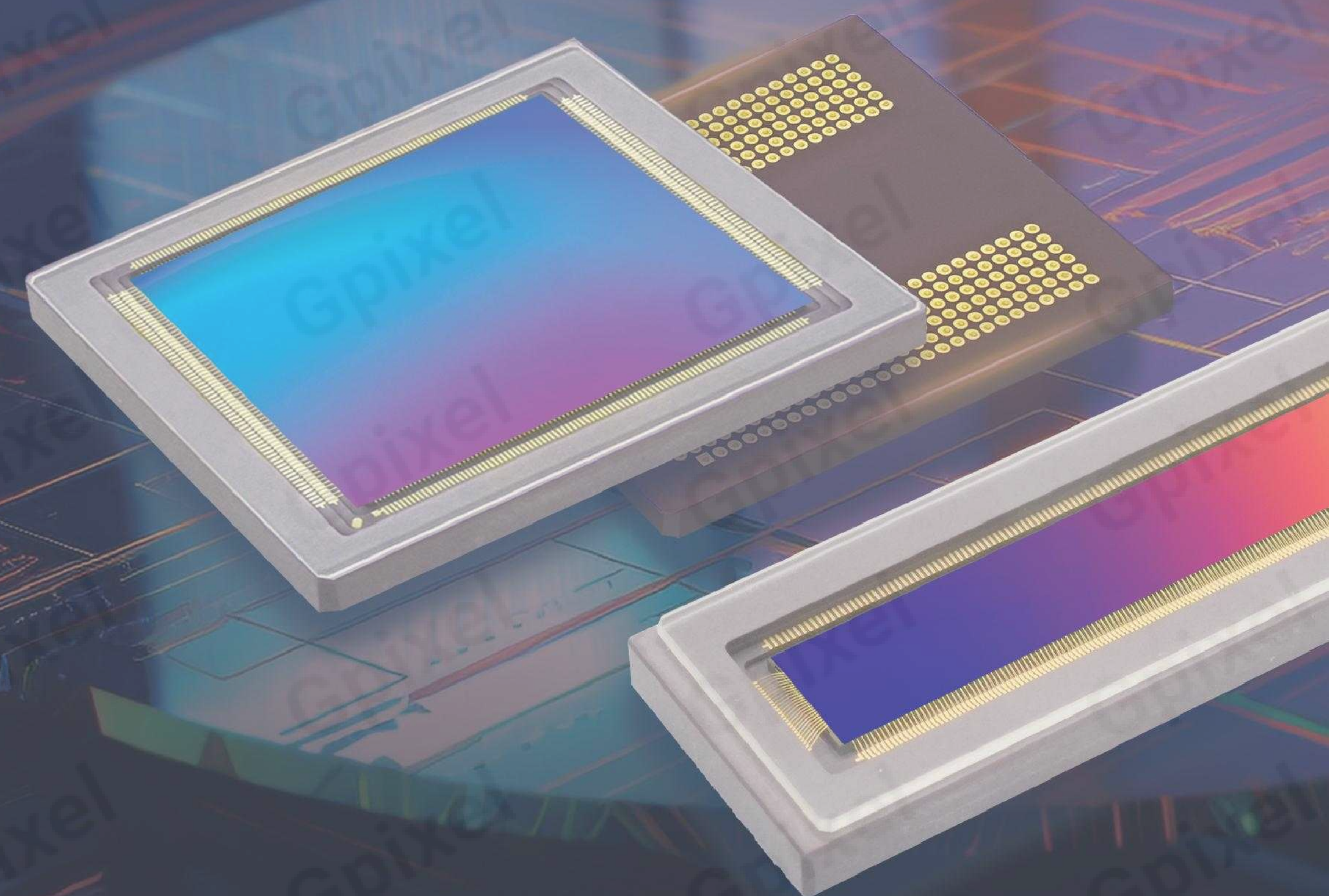
电话: +81-03-5962-1600

免责声明: 本画册所涉及的产品信息及图片仅供参考, 由于产品不断更新, 最终请以实物为准。长光辰芯保留本宣传册的最终解释、修订权利。
GP-250929-WYY-V1.0



先进的CMOS图像传感器

Advanced CMOS Image Sensors

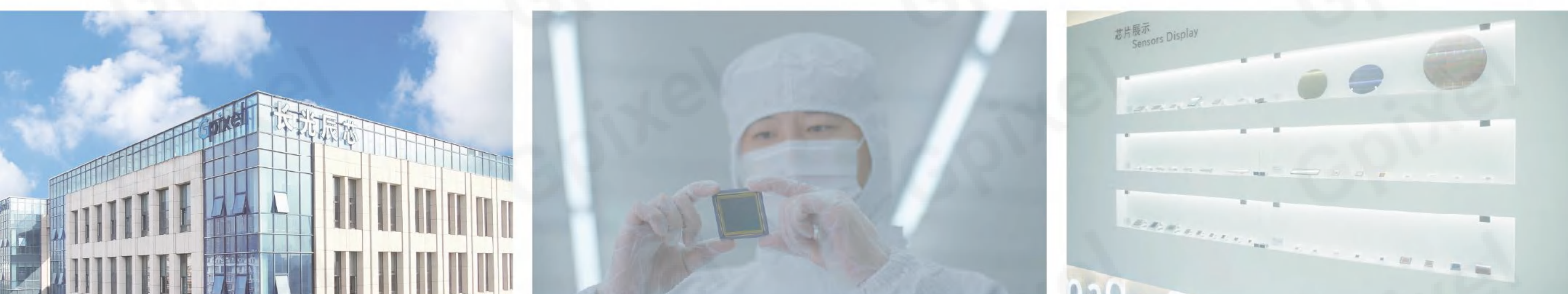


长光辰芯全系列产品手册

长春长光辰芯微电子股份有限公司
Gpixel Changchun Microelectronics Inc.

www.gpixel.com
info@gpixel.com

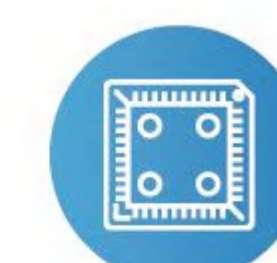
+ 关于我们



长春长光辰芯微电子股份有限公司成立于2012年，**是一家专注于高性能CMOS图像传感器研发、设计的国际化企业**。公司总部位于中国长春，同时在中国杭州、大连，比利时安特卫普和日本东京设有子公司，为全球合作伙伴提供先进的CMOS图像传感器产品和优质服务。



2012
公司成立于2012年



核心产品
高性能CMOS图像传感器



我们的使命
用芯成就·非凡世界

长光辰芯拥有海内外一流的半导体物理学专家和技术团队，**具备全局快门像素、高动态范围像素、高灵敏度像素、低噪声电路、高性能ADC、高速读出电路、TDI图像传感器、背照式图像传感器、三维成像图像传感器等多项具有自主知识产权的核心技术**。基于多年的研发投入和技术积累，长光辰芯已打造出九大系列的标准化产品，涵盖工业成像、科学成像、专业影像、医疗成像等应用领域，业务遍及全球30余个国家和地区。

长光辰芯秉持“专注图像技术，坚持科技创新，用芯成就非凡视界”的发展理念，采用先进的技术，开发更高性能、更具前瞻性的产品以满足不断增长的客户需求，为全球合作伙伴提供先进的CMOS图像传感器产品和优质服务，引领行业持续向前发展。





国际化的研发团队

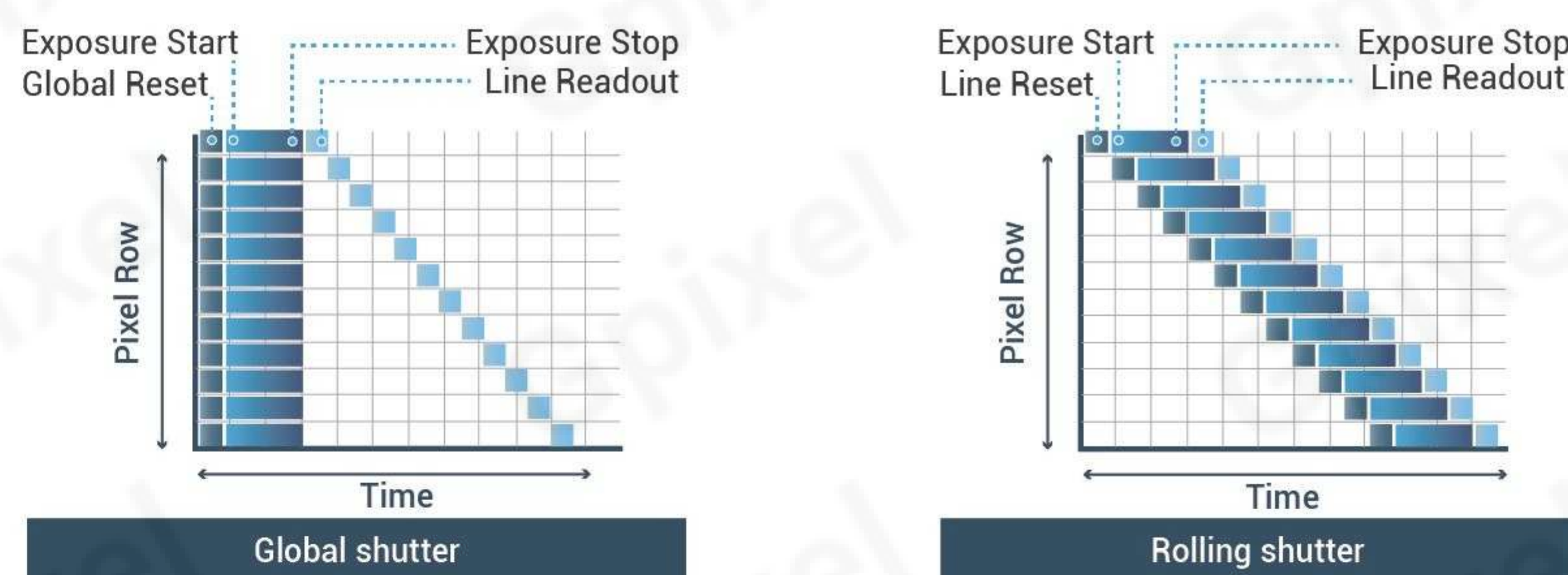
全球研发中心, 团队紧密沟通、高效协作



核心技术

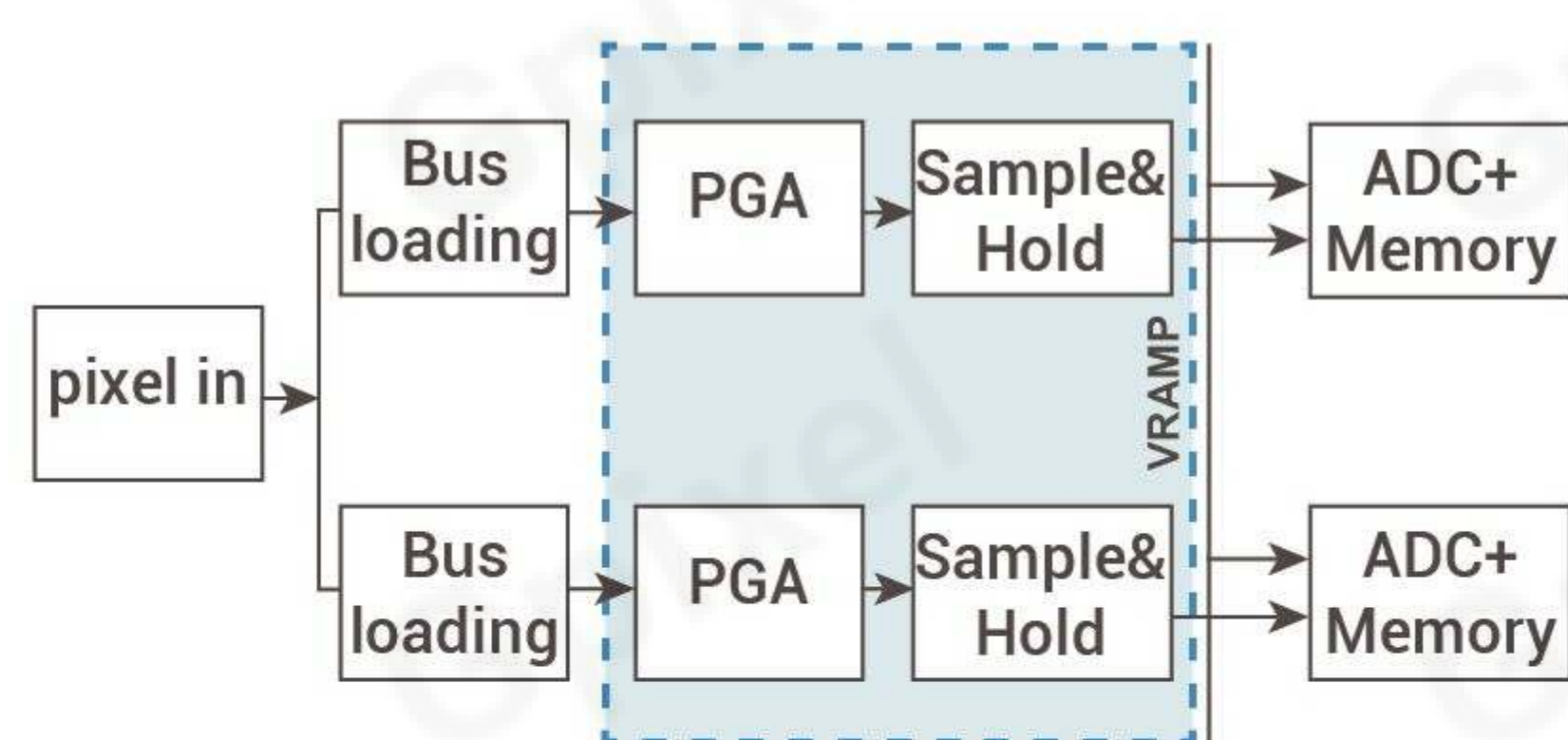
G 全局快门像素

- 实现整个像素面阵同时开始曝光、同时结束曝光。
- 电荷域全局快门像素新结构,实现单电子级读出噪声。
- 双微透镜阵列设计,有效优化快门效率。



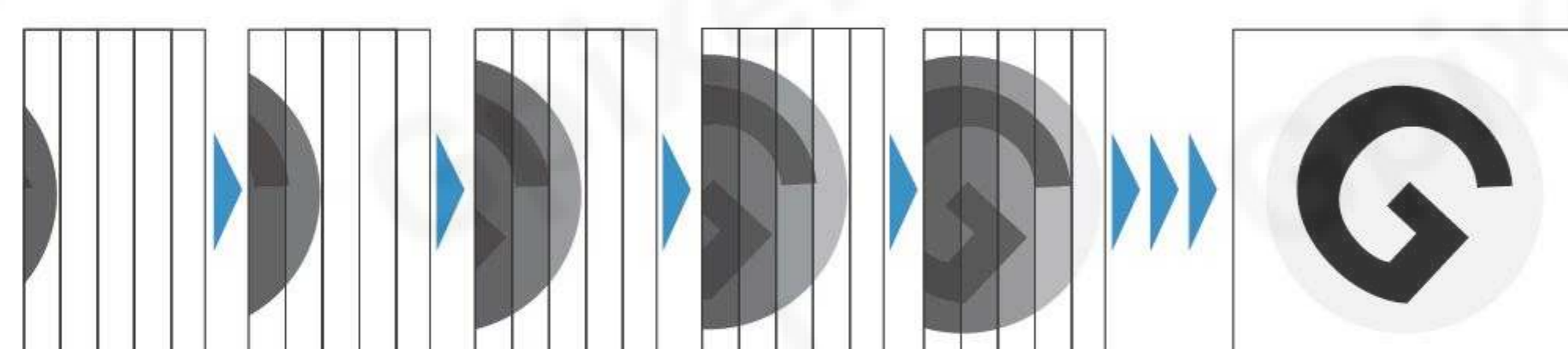
G 低噪声、高速、HDR技术

- 采用CMS技术,实现单电子读出噪声。
- 掌握高速电路设计方法,大幅提升芯片传输速率,最大数据率可达1 Tbps。
- 采用双增益电路设计,实现单幅>100 dB的动态范围。



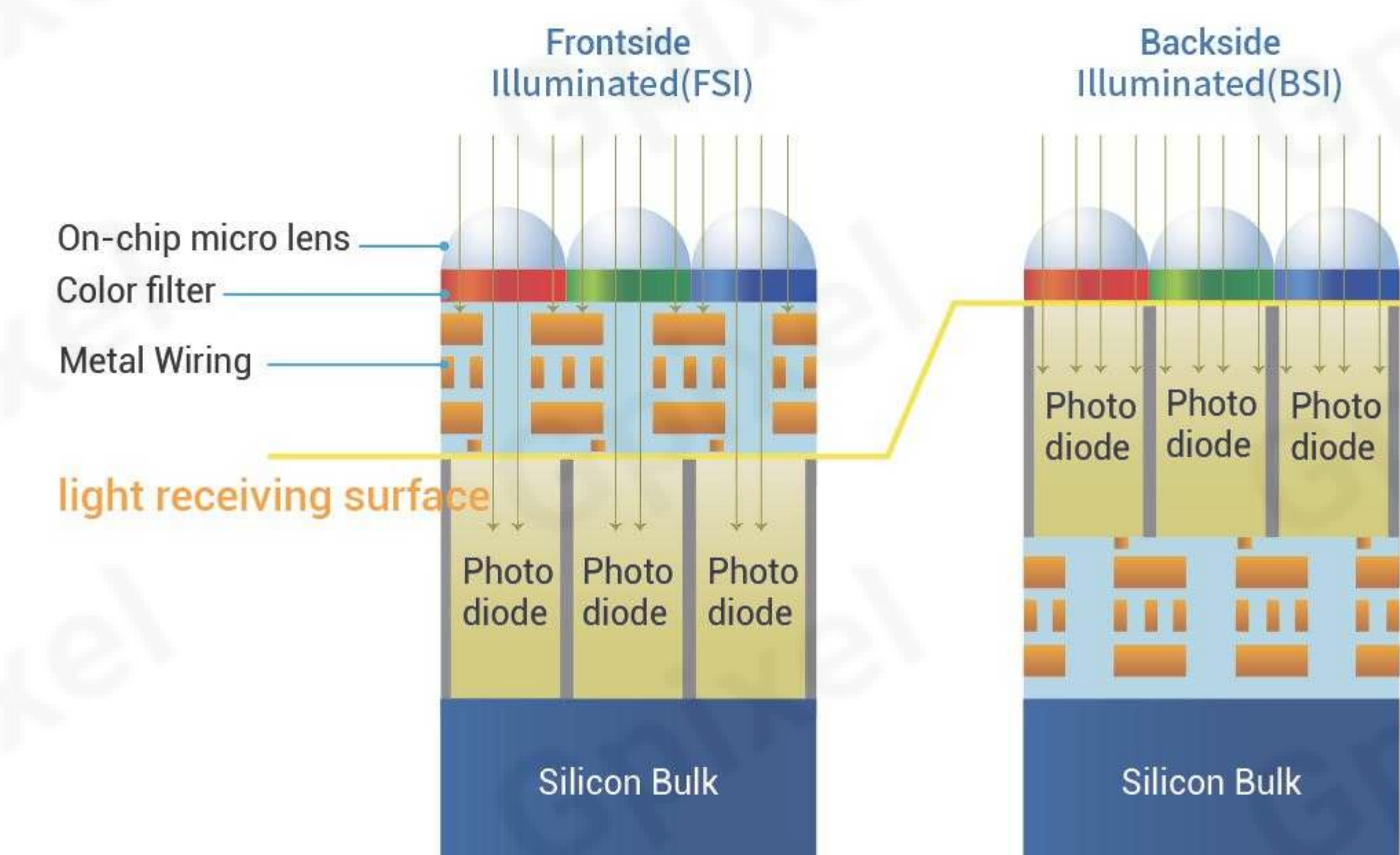
G TDI图像传感器设计技术

- 在弱光环境下,可实现高速扫描,并获取高的图像质量,系统检测效率更高。
- 相同检测速度下,相较于普通线阵传感器,可使用更低的照明亮度,系统能耗更低。
- 多用于半导体量测,PCB、显示屏检测和高通量基因测序等行业。



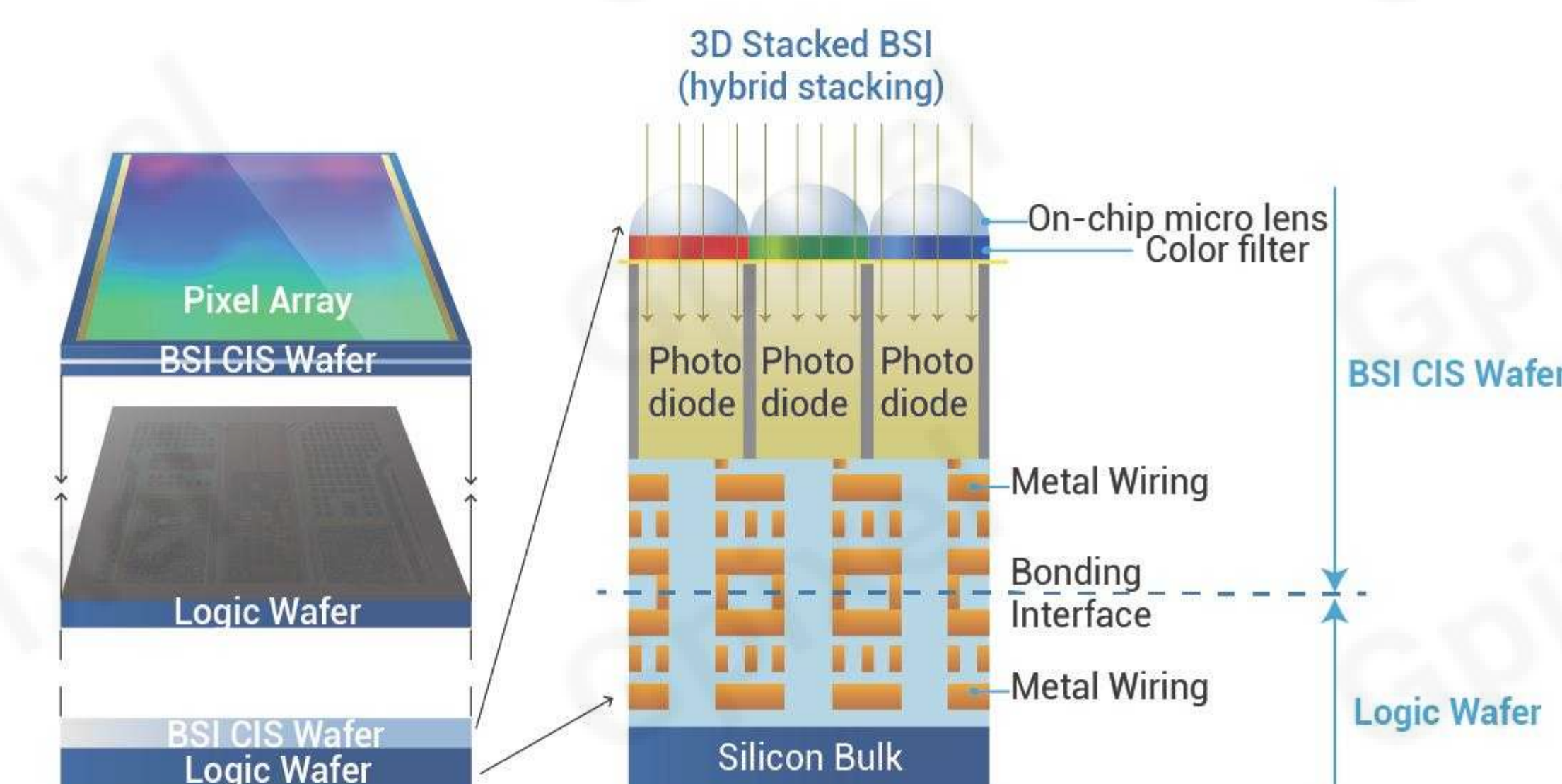
G 背照式工艺

- 自主开发的背照式图像传感器技术,峰值量子效率可达95%以上。
- 谱段范围可拓宽至——软X射线、紫外到近红外。
- 具备低读出噪声和高灵敏度。



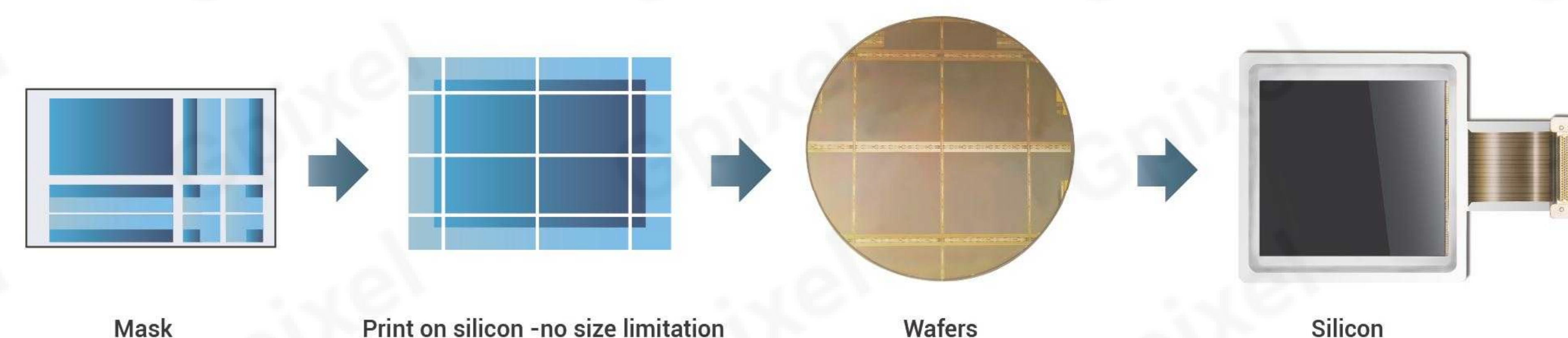
G 堆栈式芯片设计

- 对像素和电路进行独立设计,通过铜互联工艺将像素晶圆和电路晶圆绑定,实现堆栈式芯片研制。
- 继承了背照式芯片的全部优势,还具有尺寸小、读出速率快、集成度高等特点。
- 基于堆栈式结构设计,实现高性能专业影像级和TOF图像传感器研制。

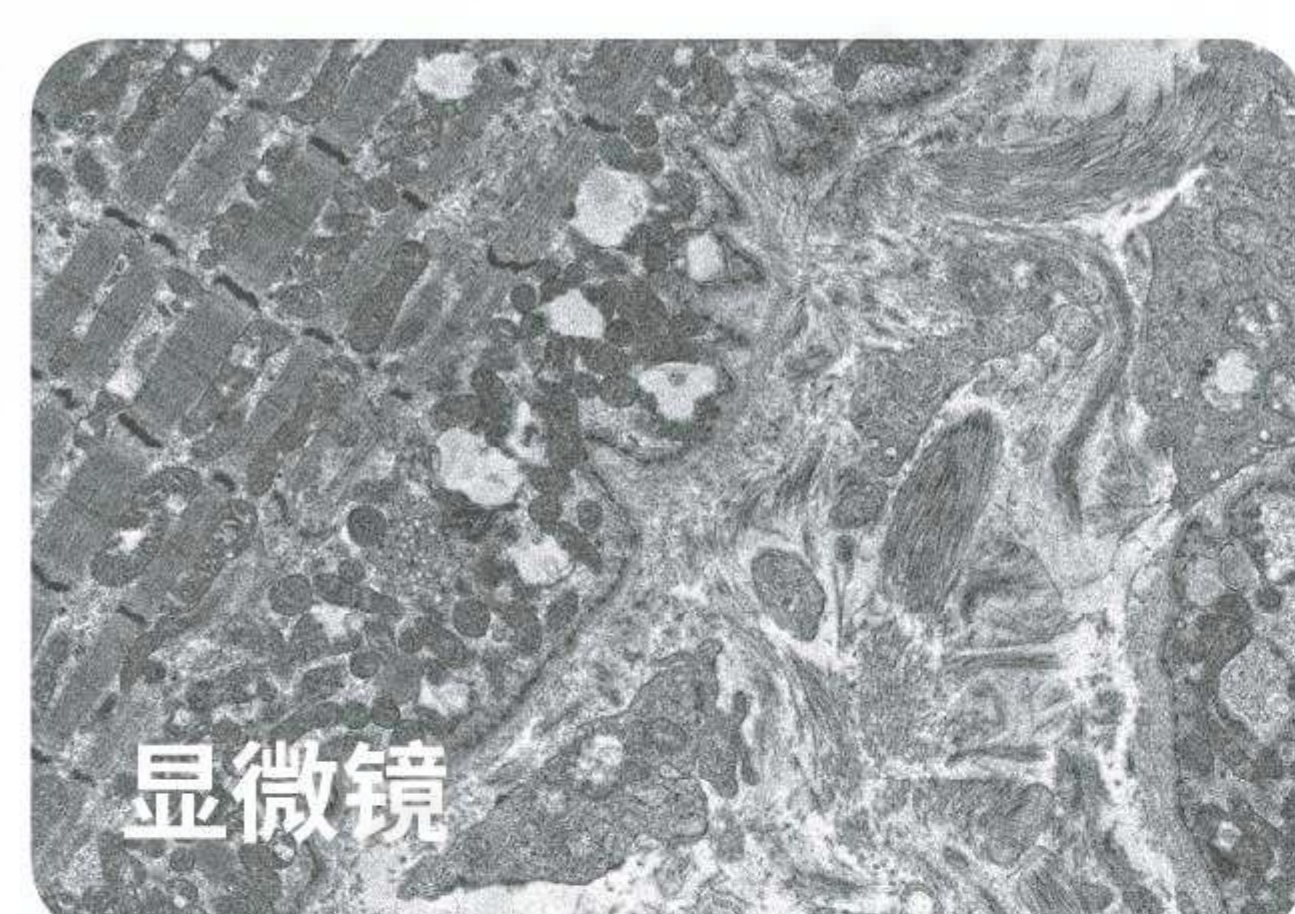
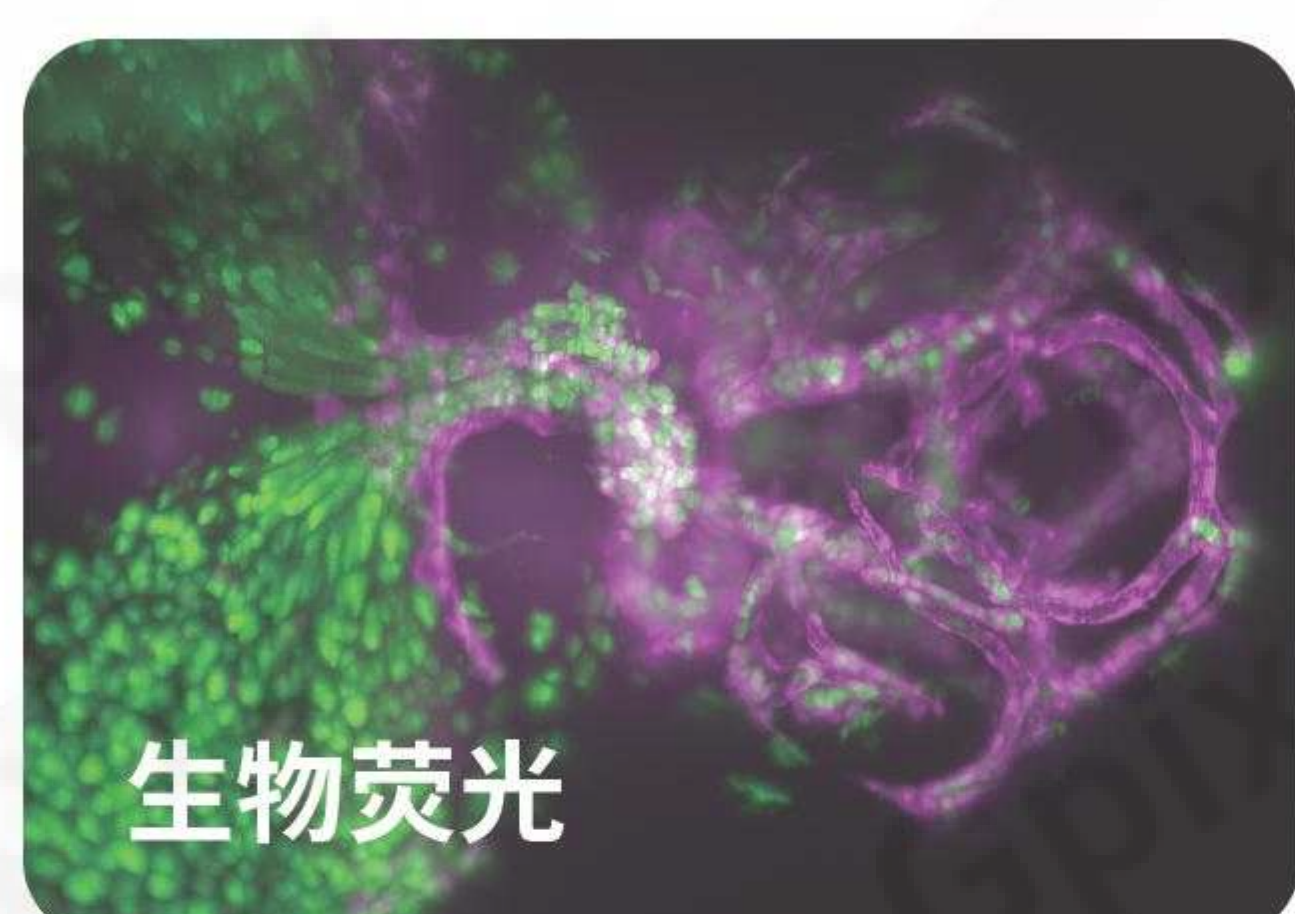
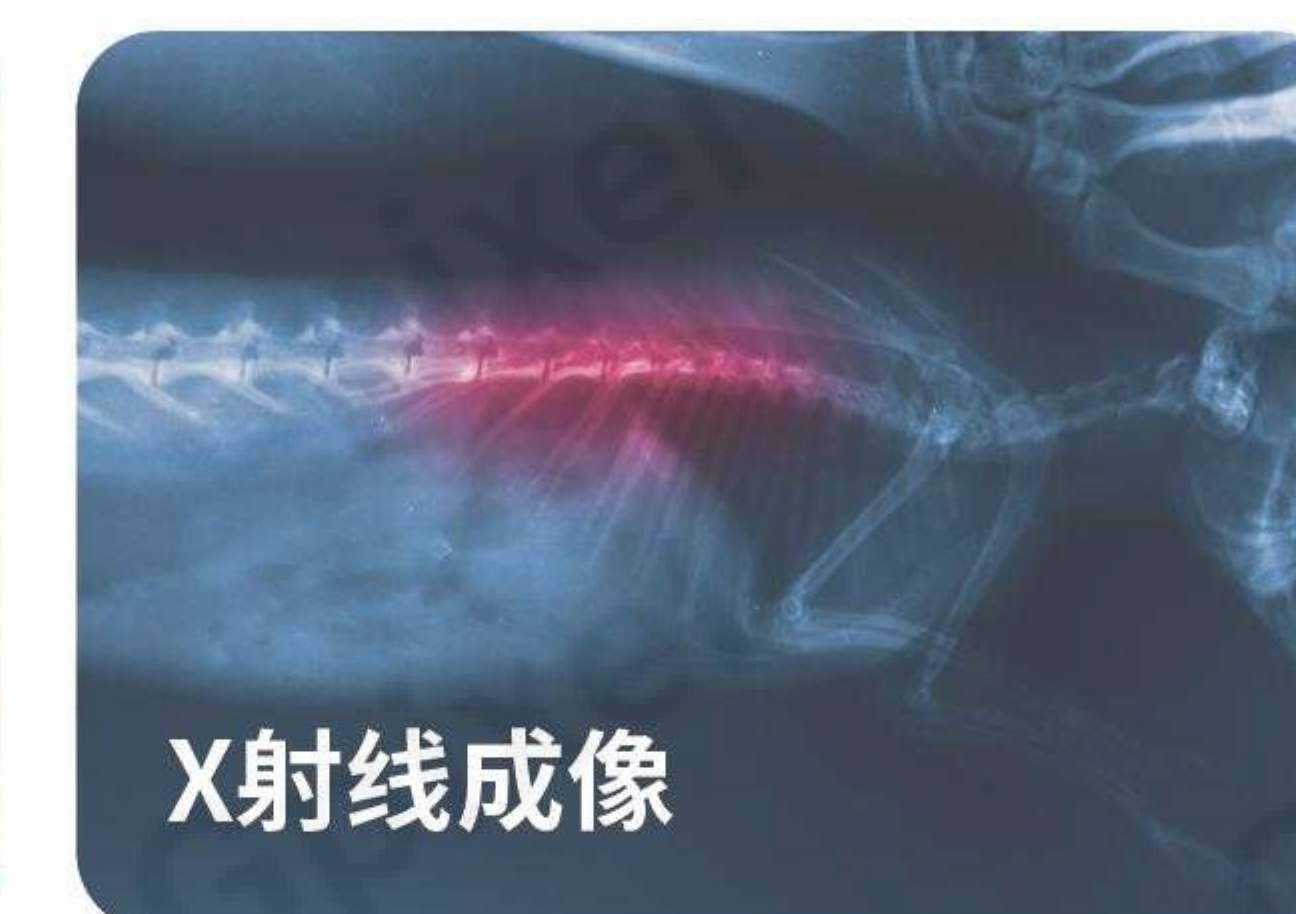
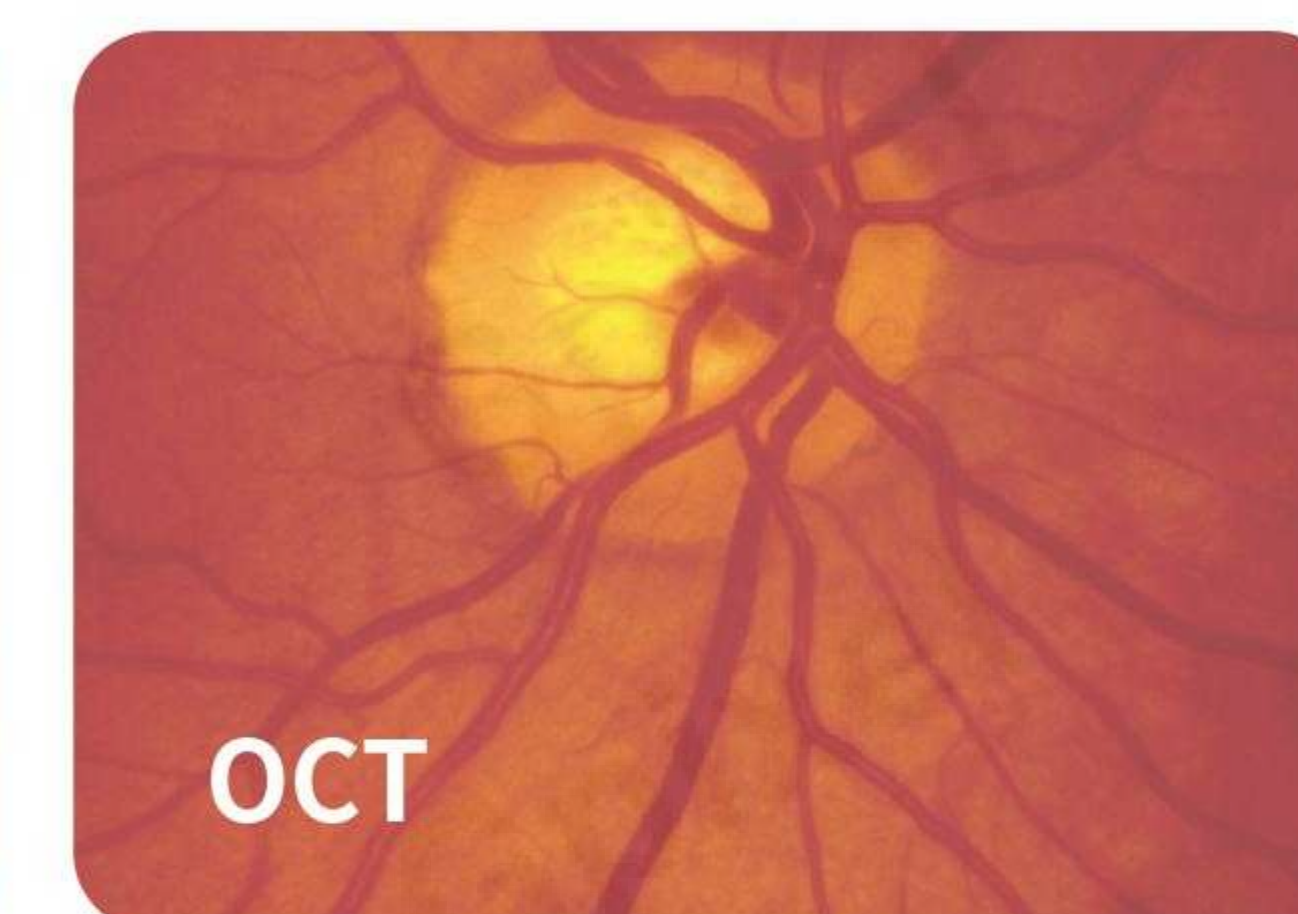
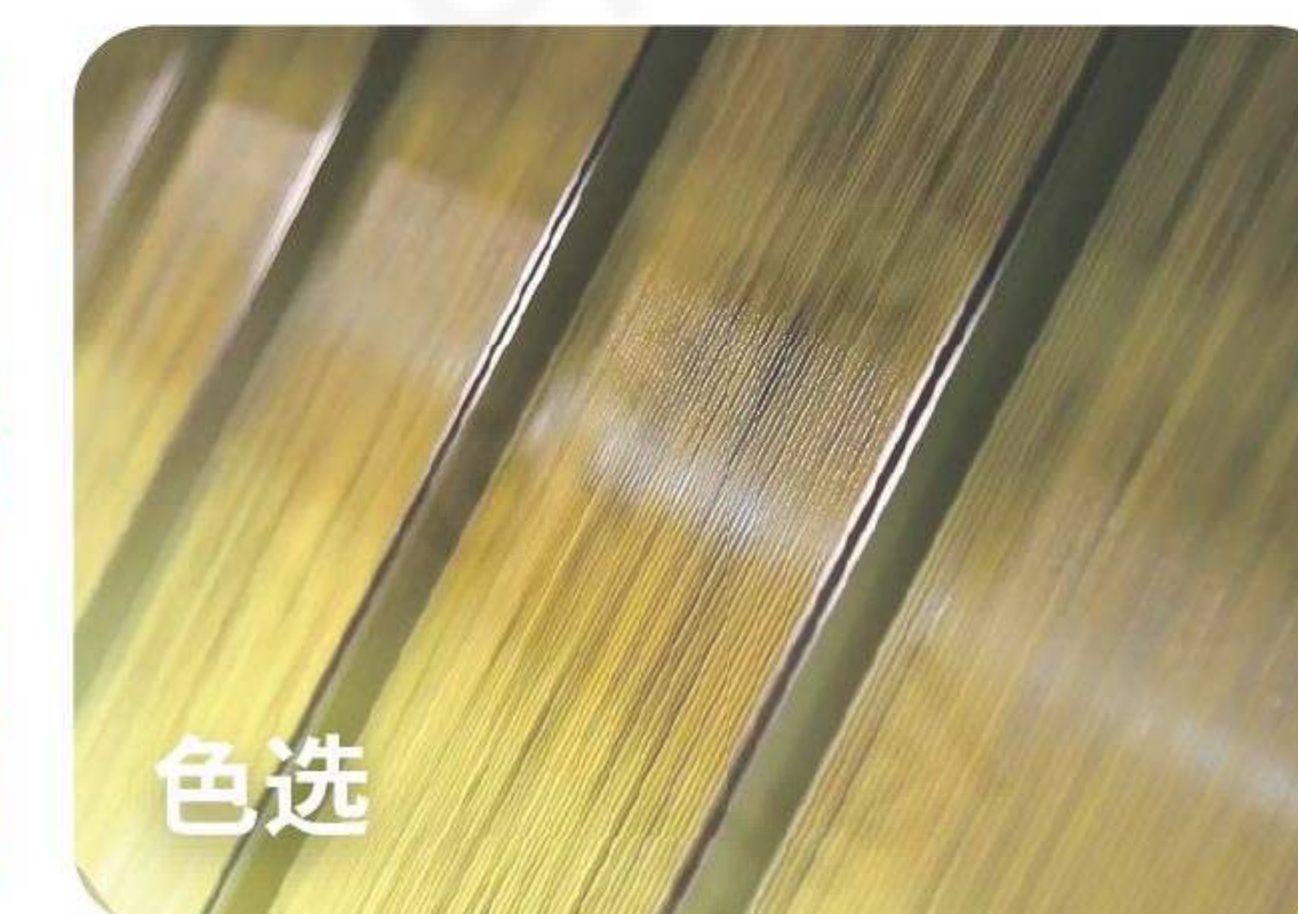


G 大靶面、超高分辨率

- 根据大靶面芯片特点进行整体模块化设计,突破单次24 mm×32 mm的光刻极限。
- 针对超高分辨率图像传感器靶面大的特点,突破二维无缝拼接设计,实现大靶面、超高分辨率CMOS图像传感器的研制。



应用领域



产品目录



GMAX系列

- GMAX4002

GMAX2505

GMAX3809

GMAX3413

GMAX2518

GMAX4651

GMAX32103

GMAX32152
- GMAX3405

GMAX2509

GMAX3412

GMAX4416

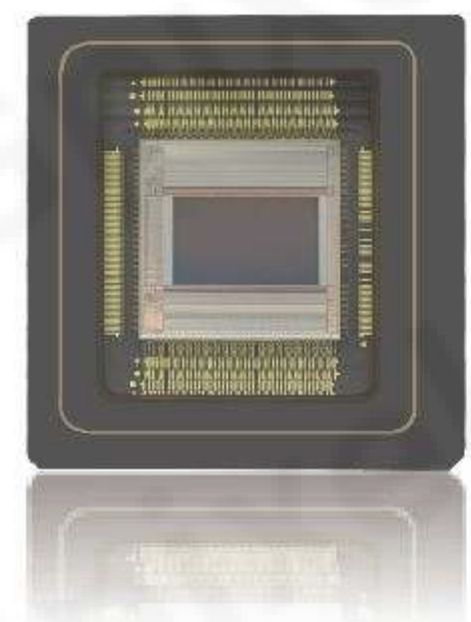
GMAX0505

GMAX3265

GMAX64104

GMAX15271BSI

11-28



GSPRINT系列

- GSPRINT6502BSI

GSPRINT4502

GSPRINT4510

GSPRINT5514BSI

GSPRINT4521

29-36



GSENSE系列

- GSENSE2020BSI

GSENSE4040

GSENSE6060

GSENSE3243BSI

GSENSE1081BSI

GSENSE400BSI
- GSENSE6504BSI

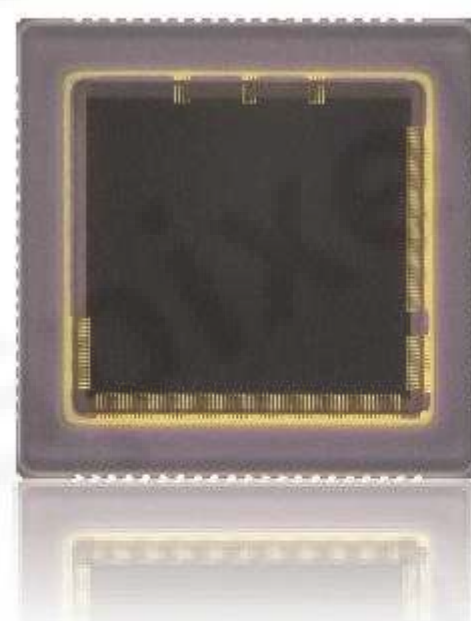
GSENSE4040BSI

GSENSE6060BSI

GSENSE6510BSI

GSENSE1517BSI

37-50



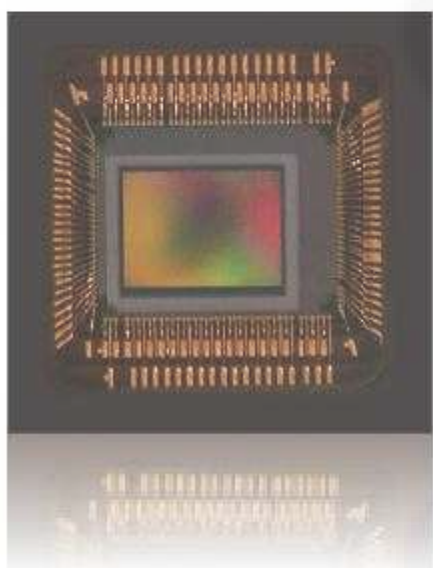
GLUX系列

- GLUX9701BSI

GLUX1605BSI

51-54

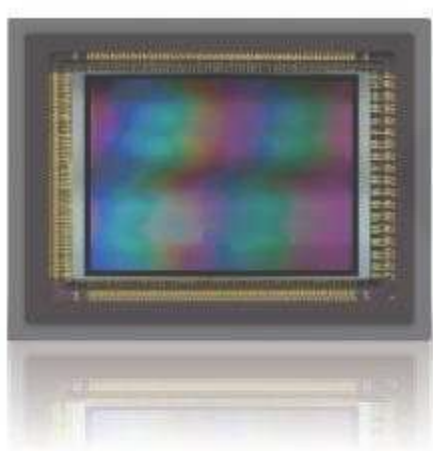
九大系列
标准化产品
满足多行业需求



GTOF系列

- GTOF0503

55-58



GCINE系列

- GCINE3243

GCINE4349

59-62



GL系列

- GLR1205BSI-S

GLT1402

GL0402

GL0816

GLT5008BSI

GL7008
- GLR1402BSI-M

GL3504

GL7004

GLT5009BSI

GLT5016BSI

GL3516

63-76



GXS系列

- GXS1508/GXSM1508

77-80



GIR系列

- GIR1201

GIR2505

81-84



定制化产品

- 全定制化产品

半定制化产品

85-86

→	GMAX
	GSPRINT
	GSENSE
	GLUX
	GTOF
	GCINE
	GL
	GXS
	GIR

面阵CMOS图像传感器

GMAX 系列

GMAX系列是长光辰芯面向机器视觉、工业检测等领域推出的系列化全局快门图像传感器,该系列产品具有高分辨率、高帧率等优势,可充分利用高速工业相机接口赋能自动化检测、智能交通、屏幕检测等多种应用场景。GMAX系列产品像素平台涵盖从1.5 μm到6.4 μm,分辨率从2.4MP到271MP。在2.5 μm的像素平台下开发的四款产品,采用了管脚兼容的设计,便于相机集成和开发。

GMAX4002	GMAX3405	GMAX2505	GMAX2509
GMAX3809	GMAX3412	GMAX3413	GMAX4416
GMAX2518	GMAX0505	GMAX4651	GMAX3265
GMAX32103	GMAX64104	GMAX32152	GMAX15271BSI

GMAX系列特点

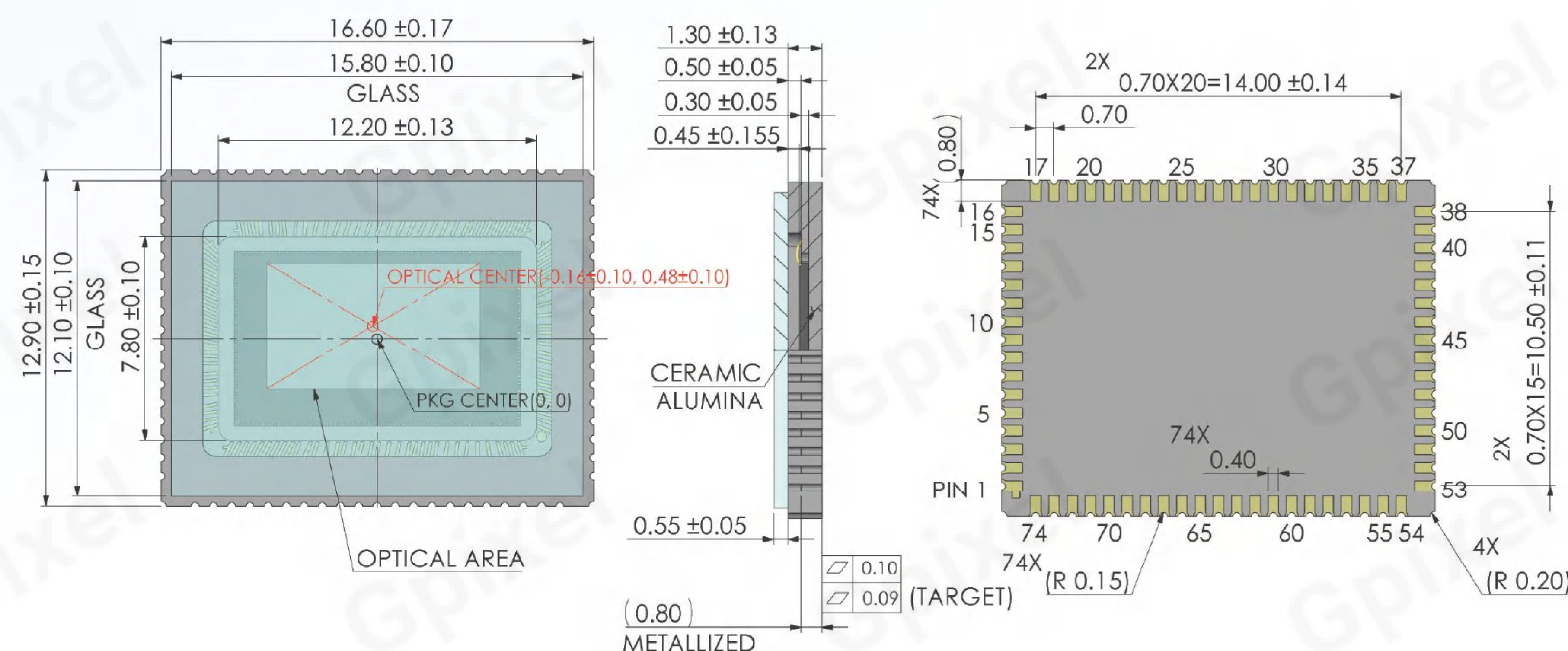
全局快门	1/1.7”至中画幅
2.4MP-271MP分辨率	高帧频

主要应用

机器视觉、工业检测、智能交通、运动捕捉



封装图示



封装图示

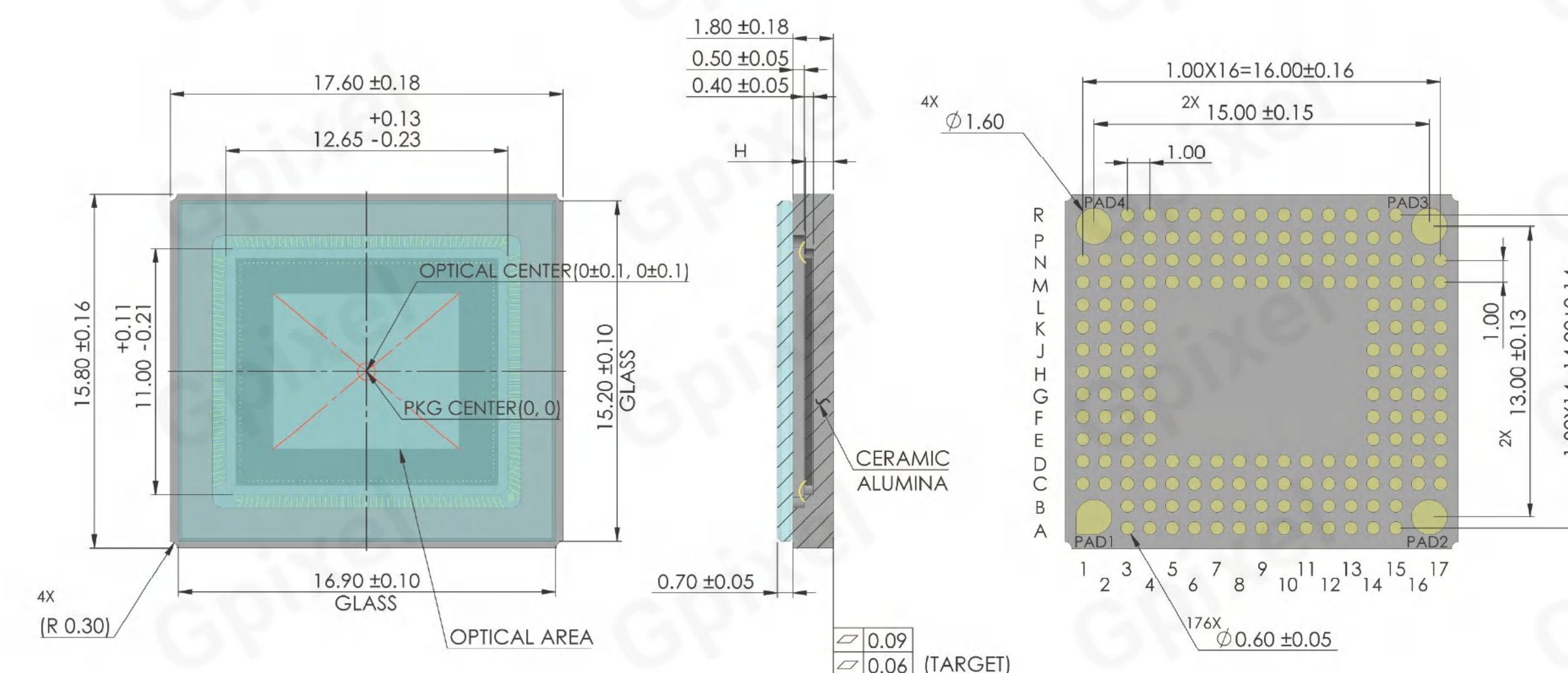
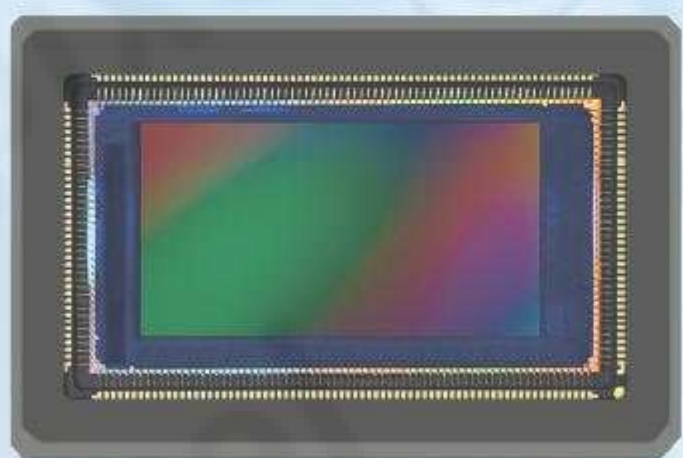


Figure 1 shows the dimensions of the ceramic alumina substrate. The top view displays a square substrate with a central square area labeled "OPTICAL AREA". The side view shows the thickness of the substrate, labeled "CERAMIC ALUMINA". The bottom view shows a grid of 16x16 holes, labeled "226x 0.60±0.05" and "4x 0.10±0.01". Dimensions are provided in millimeters with tolerances and standard deviations.

GMAX3809

9MP 全局快门 CMOS图像传感器



GMAX3809是针对智能交通行业而设计的一款900万像素分辨率、1.1"光学尺寸的全局快门CMOS图像传感器。GMAX3809采用了12 bit ADC,支持片上色彩偏移校正、LED闪烁抑制、多区域HDR等功能,结合先进的近红外增强技术,使其更适合在智能交通系统中应用。GMAX3809的最高帧频可达54 fps,可以满足系统对车牌及人脸的快速抓拍和识别。

产品特性

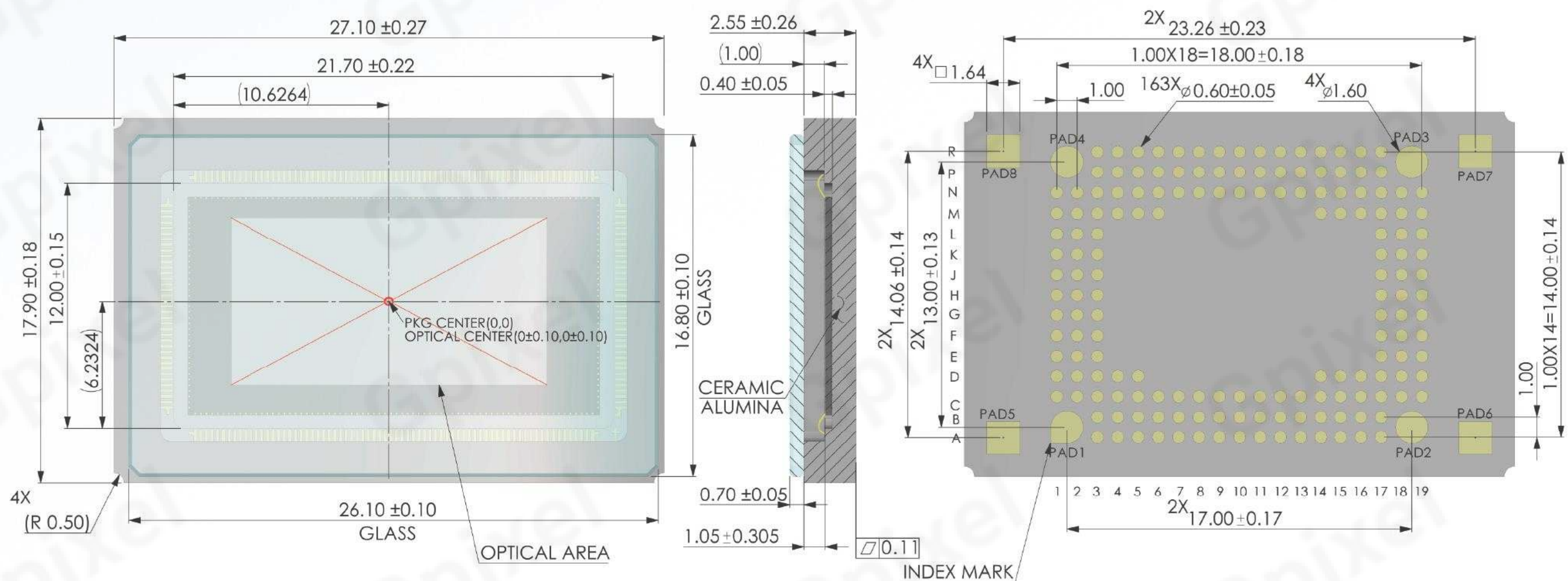
- 3.8 μm全局快门像素
- 片上彩色偏移校正
- 近红外增强
- 优异的快门效率和角度响应特性
- 多区域HDR、LED闪烁抑制
- 低噪声

应用领域

智能交通、机器视觉

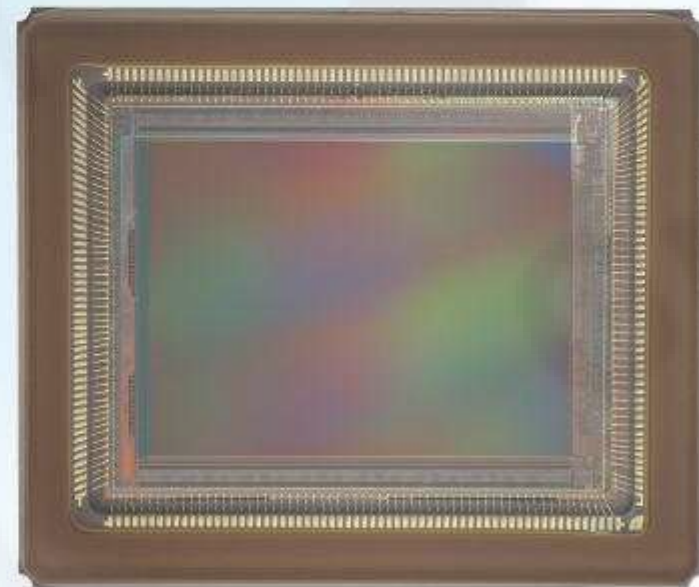
产品指标			
有效分辨率	4096(H) x 2160(V)	光学尺寸	1.1"
像素尺寸	3.8 μm x 3.8 μm	感光面积	15.6 mm x 8.2 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	61.7% (540 nm)
满阱容量	11.2 ke ⁻	寄生光灵敏度	-92 dB
读出噪声	3.3 e ⁻ (Analog gain 1.0x)	角度响应	>15° (80% Response)
暗电流	31.5 e ⁻ /pixel/s (41°C)	最大信噪比	40.5 dB
动态范围	70.7 dB	最高帧频	54 fps
输出接口	8对Sub-LVDS	通道合并	8/4
ADC位数	12 bit	最大数据率	7.68 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	<1.0 W
供电电压	3.3 V/3.6 V(模拟)、1.8 V-3.3 V(IO)、1.2 V(数字)	封装信息	163 pins LGA、27.1 mm x 17.9 mm

封装图示



GMAX3412

12MP 全局快门 CMOS图像传感器



GMAX3412是一款12MP面阵全局快门CMOS图像传感器,具备高灵敏度、低噪声、高快门效率、高帧频等优异性能,同时还集成了多斜率HDR功能,为工业检测、工业扫码、智能交通等应用带来更加精准高效的视觉识别能力。

GMAX3412的像素尺寸为3.4 μm,凭借先进的电荷域全局快门设计和生产工艺,满阱可达到9 ke⁻,在最高增益下,噪声可降至1.8 e⁻,其单幅动态范围可达67.9 dB。得益于Red Fox技术的加持,峰值QE可达75% (540 nm),在850 nm处的QE为33%。结合优于 -88 dB的快门效率和15° (80% Response) 的角度响应,可高效、稳定的为高速工业检测等应用提供更多选择。

GMAX3412 和 GMAX3405均采用 176 pins陶瓷 LGA 封装,且管脚兼容,更易于提升用户开发效率。

产品特性

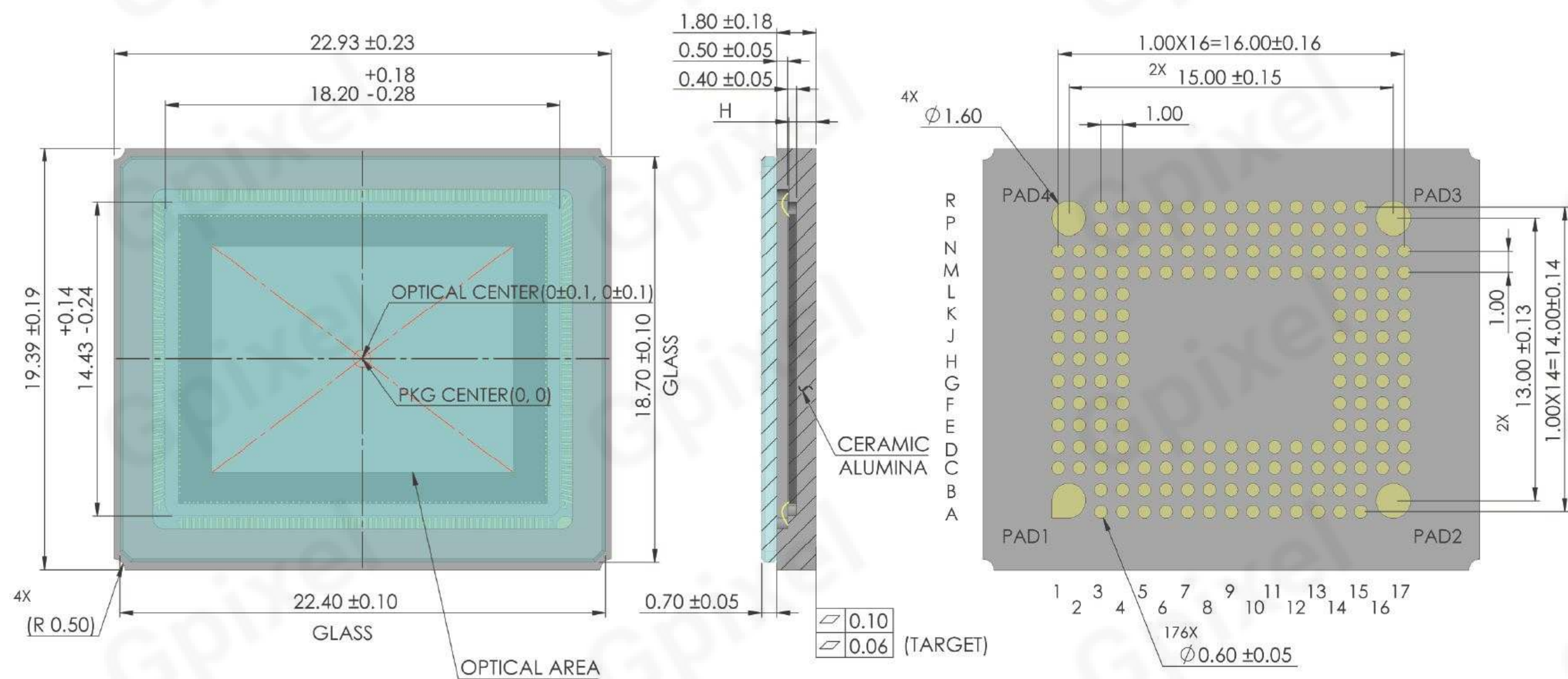
- 3.4 μm 电荷域全局快门像素
- MIPI、LVDS接口
- 1200万像素分辨率
- 优异的快门效率和角度响应特性
- 近红外增强

应用领域

工业检测、工业扫码、智能交通

产品指标			
有效分辨率	4096(H) x 3072(V)	光学尺寸	1.1"
像素尺寸	3.4 μm x 3.4 μm	感光面积	14.0 mm x 10.5 mm
快门类型	全局快门	寄生光灵敏度	-88 dB
满阱容量	9.0 ke ⁻ (12 bit, PGA gain 1.0x)、7.6 ke ⁻ (10 bit, PGA gain 1.0x)	峰值量子效率	75% (540 nm)
读出噪声	1.8 e ⁻ (12 bit, PGA gain 12.19x)、7.8 e ⁻ (10 bit, PGA gain 1.0x)	角度响应	>15° (80% Response)
暗电流	6.5 e ⁻ /pixel/s (35°C)	最大信噪比	39.5 dB
动态范围	67.9 dB	最高帧频	150 fps
输出接口	16对Sub-LVDS、4 lanes MIPI	通道合并	16/14/12/10/8/6/4/2/1 (Sub-LVDS)、4 (MIPI)
ADC位数	10/12 bit	最大数据率	20.48 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	1.7 W
供电电压	3.6 V(像素)、3.3 V(模拟)、1.8 V - 3.3 V(IO)、1.2 V(数字)	封装信息	176 pins LGA、22.93 mm x 19.39 mm

封装图示



GMAX3413

12.7MP 全局快门近红外增强CMOS图像传感器



GMAX3413是一款宽视场、近红外增强全局快门CMOS图像传感器。该传感器依托GMAX产品系列多年的技术积累,集成了近红外增强、LED Flicker、多区域HDR等重要功能。GMAX3413采用了2.73:1的超宽视场设计,在相同的光学尺寸下可获得更多水平方向的图像信息,使其更适用于智能交通、工业扫码相关场景的应用。GMAX3413配备了先进的Red Fox技术,在850 nm处实现超过30%的QE,在940 nm处实现14%的QE。同时,凭借独特的光管技术和优化的像素设计使其具备优异的角度响应,可解决大视场角带来的灵敏度降低的问题。GMAX3413采用163 pins LGA封装形式,封装尺寸为32.7 mm x 17.9 mm,与GMAX3809 pin兼容。

产品特性

- 3.4 μm全局快门像素

· LED Flicker
- 超宽视场

· 垂直/水平图像翻转
- 近红外增强

· 出色的PLS和角度响应
- 多区域HDR

· 垂直开窗

应用领域

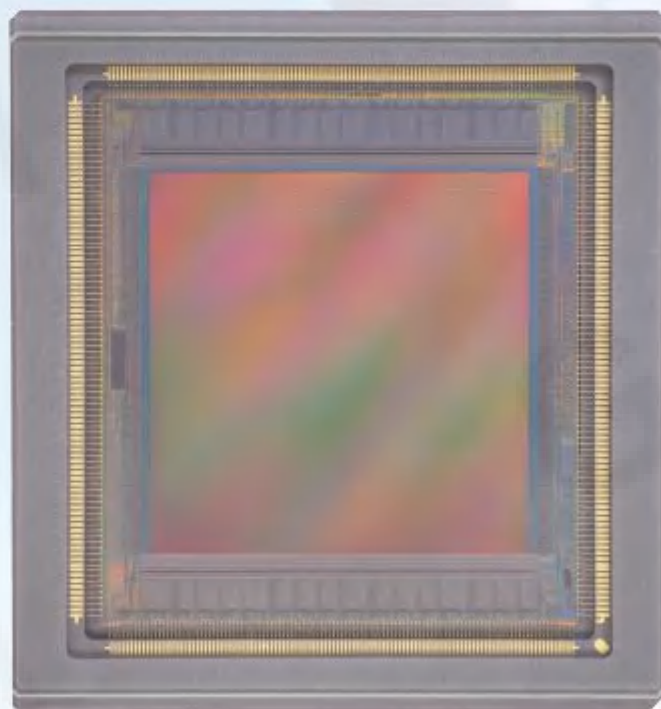
智能交通、工业扫码

产品指标			
有效分辨率	5900(H) x 2160(V)	光学尺寸	4/3"
像素尺寸	3.4 μm x 3.4 μm	感光面积	20.1 mm x 7.3 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	62.7% (540 nm)
满阱容量	8.6 ke ⁻	寄生光灵敏度	-92.0 dB
读出噪声	2.3 e ⁻	角度响应	>15° (80% Response)
暗电流	81 e ⁻ /pixel/s (35°C)	最大信噪比	39.3 dB
动态范围	71.4 dB	最高帧频	32 fps
输出接口	8对LVDS	通道合并	8/4
ADC位数	12 bit	最大数据率	7.68 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	<1.2 W
供电电压	3.3 V/3.6 V(模拟)、1.8 V - 3.3 V(IO)、1.3 V(数字)	封装信息	163 pins LGA、32.7 mm x 17.9 mm

封装图示			

GMAX4416

16MP 全局快门CMOS图像传感器



GMAX4416采用4.4 μm的电荷域全局快门像素设计,有效分辨率为4096 (H) x 4096 (V), 对角线尺寸为25.4 mm,最大满阱为15 ke⁻, 读出噪声仅为2.6 e⁻,在双增益HDR模式下动态范围最高可达74.9 dB。由于采用了近红外优化工艺,该芯片在530 nm和850 nm处的量子效率分别为71.1和30%。GMAX4416支持三种输出模式,STD模式,HDR模式,以及片上Binning HDR模式。STD模式,芯片以全分辨率输出,其最高帧率可达到80 fps;HDR模式,在保证全分辨率输出的同时,可以获得最优的动态范围;Binning HDR模式,其满阱可以提升4倍,达到60.7 ke⁻,动态范围进一步提升至79.9 dB,在保持80 fps帧率不变的条件下,进行了功耗优化。基于以上特性,GMAX4416主要适用于航空测绘、运动捕捉、AOI检测等领域。

产品特性

- 4.4 μm 电荷域全局快门像素

· Binning HDR模式
- 1600万像素分辨率

· 近红外增强
- 1:1长宽比

· 最高帧频:80 fps

应用领域

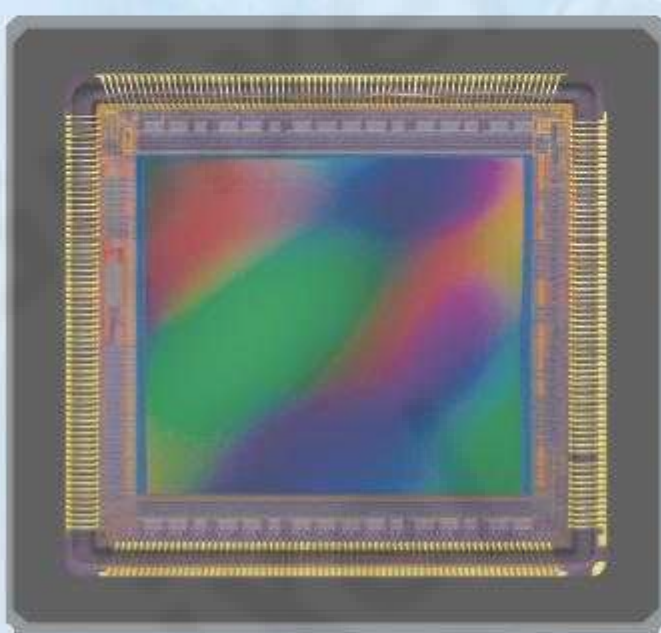
航空测绘、AOI检测、运动捕捉

产品指标			
有效分辨率	4096(H) x 4096(V)	光学尺寸	1.6"
像素尺寸	4.4 μm x 4.4 μm	感光面积	18 mm x 18 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	71.1% (530 nm)
满阱容量	15 ke ⁻	寄生光灵敏度	<-91 dB
读出噪声	<3.0 e ⁻	角度响应	>15° (80% Response)
暗电流	< 5 e ⁻ /pixel/s (28°C)	最大信噪比	41.6 dB
动态范围	68.1 dB (STD)、74.9 dB (HDR)、79.9 dB (Binning-HDR)	最高帧频	80 fps (STD mode)、42 fps (HDR mode) 80 fps (Binning-HDR mode)
输出接口	32对Sub-LVDS	通道合并	32/16/14/12/10/8/6/4/2/1
ADC位数	12 bit	最大数据率	19.2 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	<1.5 W
供电电压	3.3 V(模拟)/1.8 V - 3.3 V(IO)/1.2 V(数字)	封装信息	152 pins μPGA、31.70 mm x 34.00 mm

封装图示			

GMAX2518

18MP 全局快门CMOS图像传感器



GMAX2518是一款1800万像素分辨率、1"光学尺寸的全局快门CMOS图像传感器。凭借独特的光管技术,使芯片具备优异的快门效率和角度响应。GMAX2518最高帧率可达139 fps,可大幅提高工业检测效率。GMAX2518采用226 pins LGA陶瓷封装,且与GMAX2505、GMAX2509和GMAX0505管脚兼容。

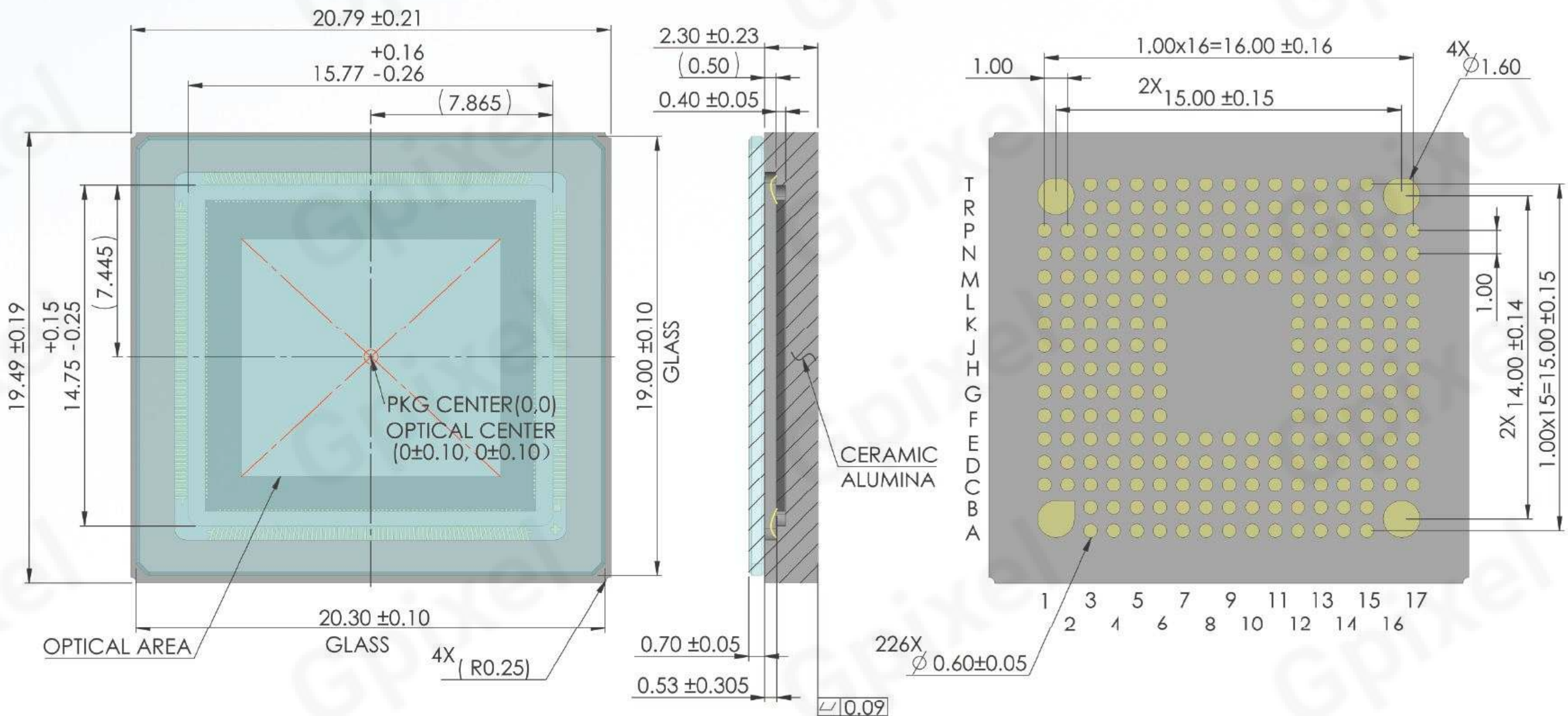
产品特性

- 2.5 μm全局快门像素
- 1800万像素分辨率
- 最高帧率:139 fps
- 优异的快门效率和角度响应特性

应用领域

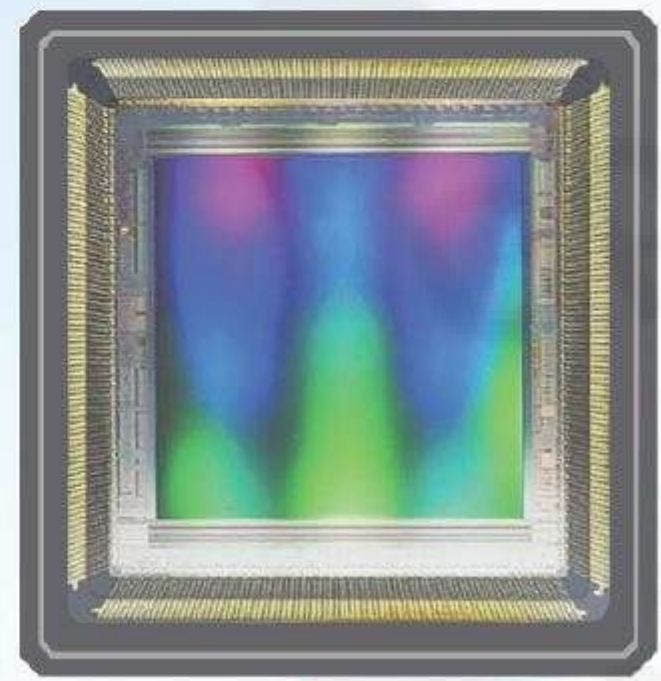
机器视觉、高分辨率工业检测

产品指标			
有效分辨率	4508(H) x 4096(V)	光学尺寸	1"
像素尺寸	2.5 μm x 2.5 μm	感光面积	11.3 mm x 10.2 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	64.0% (520 nm)
满阱容量	8.0 ke ⁻ (PGA gain 1.0x)	寄生光灵敏度	<-80 dB
读出噪声	1.7 e ⁻ (12 bit,PGA gain 4x)、4.7 e ⁻ (10 bit,PGA gain 1.75x)	角度响应	>12° (80% Response)
暗电流	6.5 e ⁻ /pixel/s (45°C)	最大信噪比	39.0 dB (PGA gain 1.0x)
动态范围	66.9 dB (12 bit,PGA gain 1.75x)、61.9 dB (10 bit,PGA gain 1.75x)	最高帧频	139 fps (10 bit)、64 fps (12 bit)
输出接口	32对Sub-LVDS	通道合并	32/16/12/8/4/2
ADC位数	10/12 bit	最大数据率	30.72 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	<1.2 W
供电电压	3.3 V/1.3 V(模拟)、1.8 V-3.3 V(IO)、1.3 V(数字)	封装信息	226 pins LGA、20.8 mm x 19.5 mm
封装图示			



GMAX0505

26MP 全局快门 CMOS图像传感器



GMAX0505是一款2600万像素分辨率、1.1"光学尺寸的全局快门CMOS图像传感器。凭借独特的光管技术,使芯片具备优异的快门效率和角度响应。芯片支持10 bit和12 bit ADC输出,全分辨率下最高帧率可达150 fps。GMAX0505片上集成时序发生器,同时在片上可以实现隔行采样和图像反转等功能。芯片采用高可靠性、便于相机集成的LGA封装,可提供近红外增强版本和普通版本。GMAX2505、GMAX2509、GMAX2518、GMAX0505 四款产品管脚兼容,且均在片上集成时序发生器,进一步降低了用户开发成本。

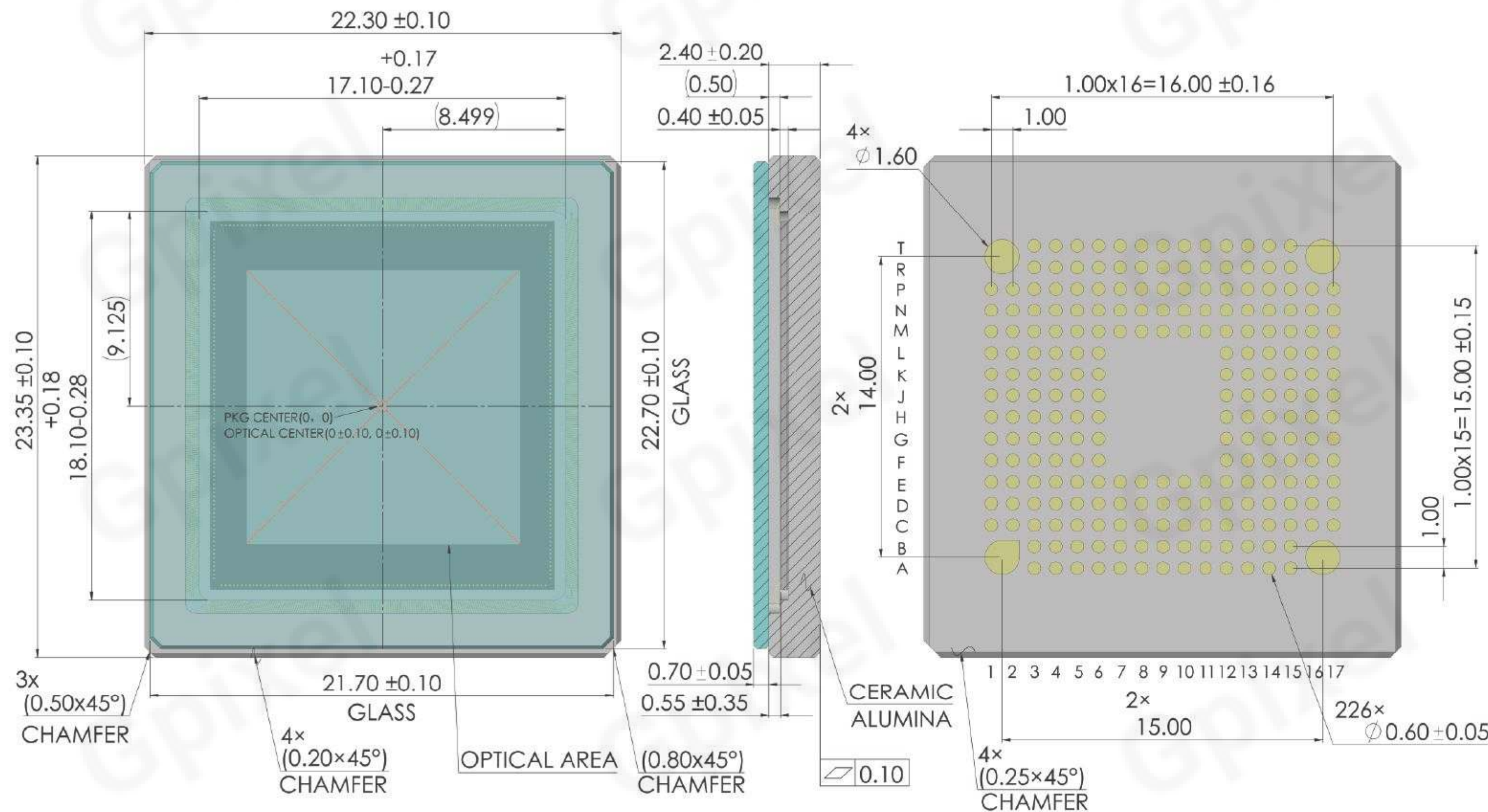
产品特性

- 2.5 μm全局快门像素
- 2600万像素分辨率
- 优异的快门效率和角度响应
- 近红外增强
- 最高帧率:150 fps

应用领域

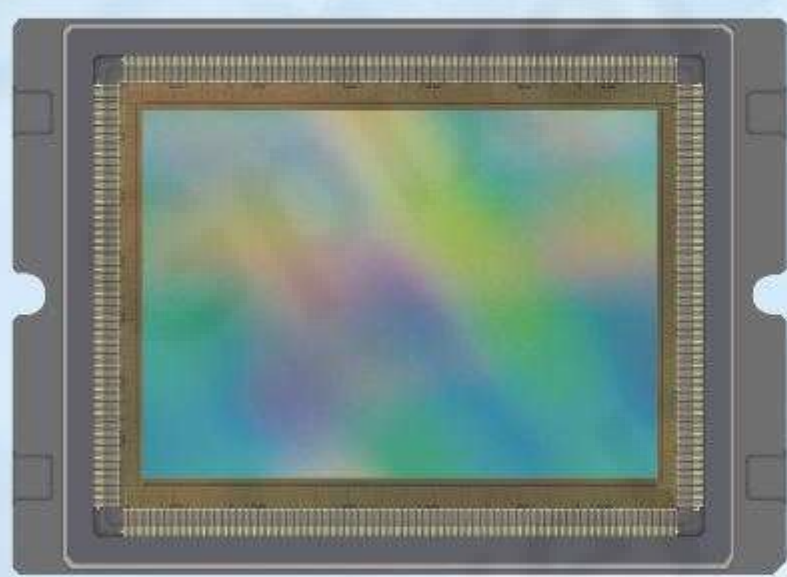
机器视觉、工业检测、运动捕捉

产品指标			
有效分辨率	5120(H) x 5120(V)	光学尺寸	1.1"
像素尺寸	2.5 μm x 2.5 μm	感光面积	12.8 mm x 12.8 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	65.5% (500 nm)
满阱容量	6.5 ke ⁻ (PGA gain 1.0x)	寄生光灵敏度	<-80 dB
读出噪声	1.6 e ⁻ (12 bit,PGA gain 5x)、3.4 e ⁻ (10 bit,PGA gain 2.5x)	角度响应	>13° (80% Response)
暗电流	1.0 e ⁻ /pixel/s (30°C)	最大信噪比	38.1 dB (PGA gain 1.0x)
动态范围	65.8 dB (12 bit,PGA gain 2.5x)、61.4 dB (10 bit PGA gain 2.5x)	最高帧频	150 fps (10 bit)、42 fps (12 bit)
输出接口	48对Sub-LVDS	通道合并	48/24/16/12/8/6/4/2
ADC位数	10/12 bit	最大数据率	46.08 Gbps
色彩	黑白&彩色&近红外增强	功耗	<1.1 W (12 bit)、<1.5 W (10 bit)
供电电压	3.3 V/1.3 V(模拟)、1.8 V-3.3 V(IO)、1.3 V(数字)	封装信息	226 pins LGA、22.3 mm x 23.4 mm
封装图示			



GMAX4651

51MP 全局快门CMOS图像传感器



GMAX4651是一款5100万像素分辨率、全画幅全局快门CMOS图像传感器。凭借独特的光管技术,使芯片具备优异的快门效率和角度响应。GMAX4651全分辨率下最高帧率可达30 fps,同时可通过开窗实现更高帧率。芯片采用高可靠性、良好散热性的PGA陶瓷封装,且光学中心与机械中心重合。

- 产品特性
- 4.6 μm全局快门像素

· 5100万像素高分辨率

· 全画幅

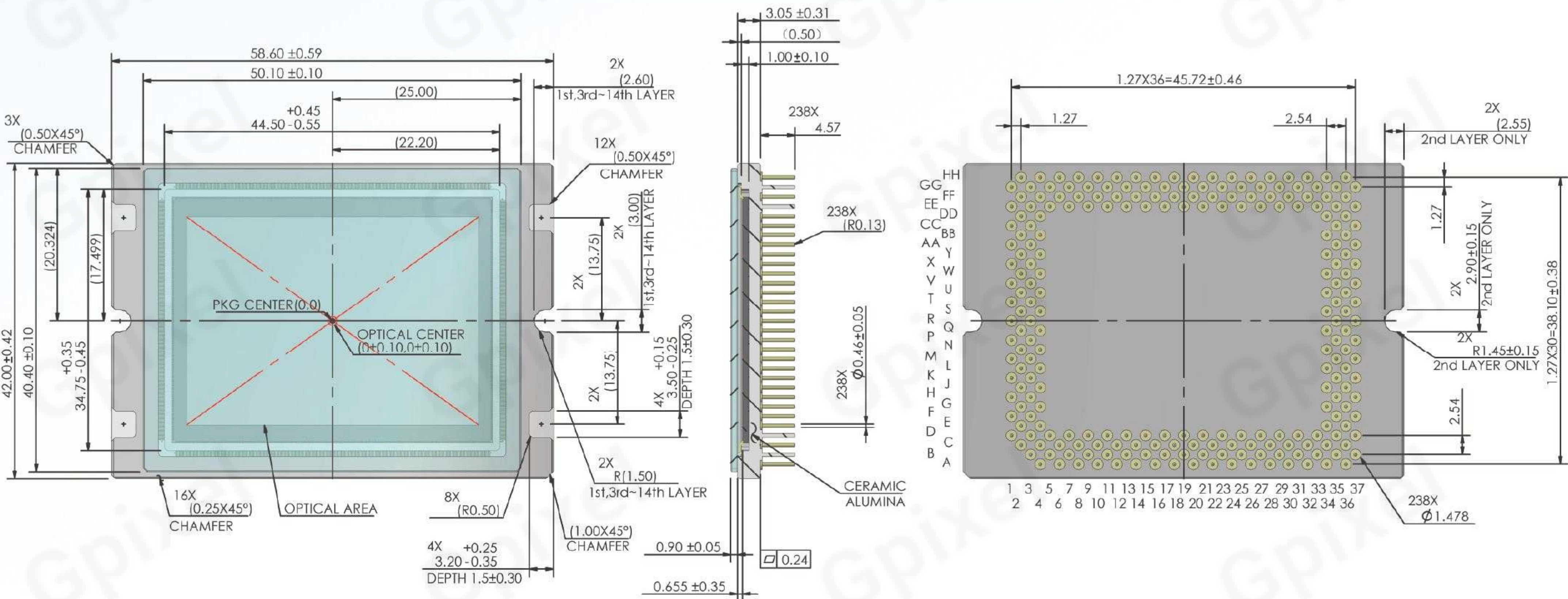
· 优异的快门效率和角度响应

应用领域

机器视觉、高分辨率工业检测

产品指标			
有效分辨率	8424(H) x 6032(V)	光学尺寸	35 mm 全画幅
像素尺寸	4.6 μm x 4.6 μm	感光面积	38.8 mm x 27.8 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	67.1% (510 nm)
满阱容量	18 ke ⁻ (PGA gain 3.5x)	寄生光灵敏度	<-92 dB
读出噪声	7.6 e ⁻ (PGA gain 5x)	角度响应	>15° (80% Response)
暗电流	6 e ⁻ /pixel/s (45°C)	最大信噪比	42.5 dB (PGA gain 3.5x)
动态范围	65.5 dB (PGA gain 3.5x)	最高帧频	30 fps
输出接口	24对Sub-LVDS	通道合并	24/14/8/6/4
ADC位数	12 bit	最大数据率	20.74 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	<2.8 W
供电电压	3.3 V/1.3 V(模拟)、1.8 V - 3.3 V(IO)、1.3 V(数字)	封装信息	238 pins PGA、58.6 mm x 42.0 mm

封装图示



GMAX3265

65MP 全局快门 CMOS图像传感器



GMAX3265是一款6500万像素分辨率、2.3"光学尺寸的全局快门CMOS图像传感器。芯片采用了电荷域相关双采样(CDS)技术,读出噪声仅为1.9 e⁻。凭借独特的光管技术,使芯片具备优异的快门效率和角度响应。芯片采用高可靠性、良好散热性的μPGA陶瓷封装,片上集成了时序发生器和SPI,使相机设计和系统集成更加简单。GMAX3265提供高速和普速版,高速版最高帧频可达71 fps。

- 产品特性
- 3.2 μm全局快门像素

· 最高帧率:71 fps

· 6500万像素高分辨率

· 优异的快门效率和角度响应

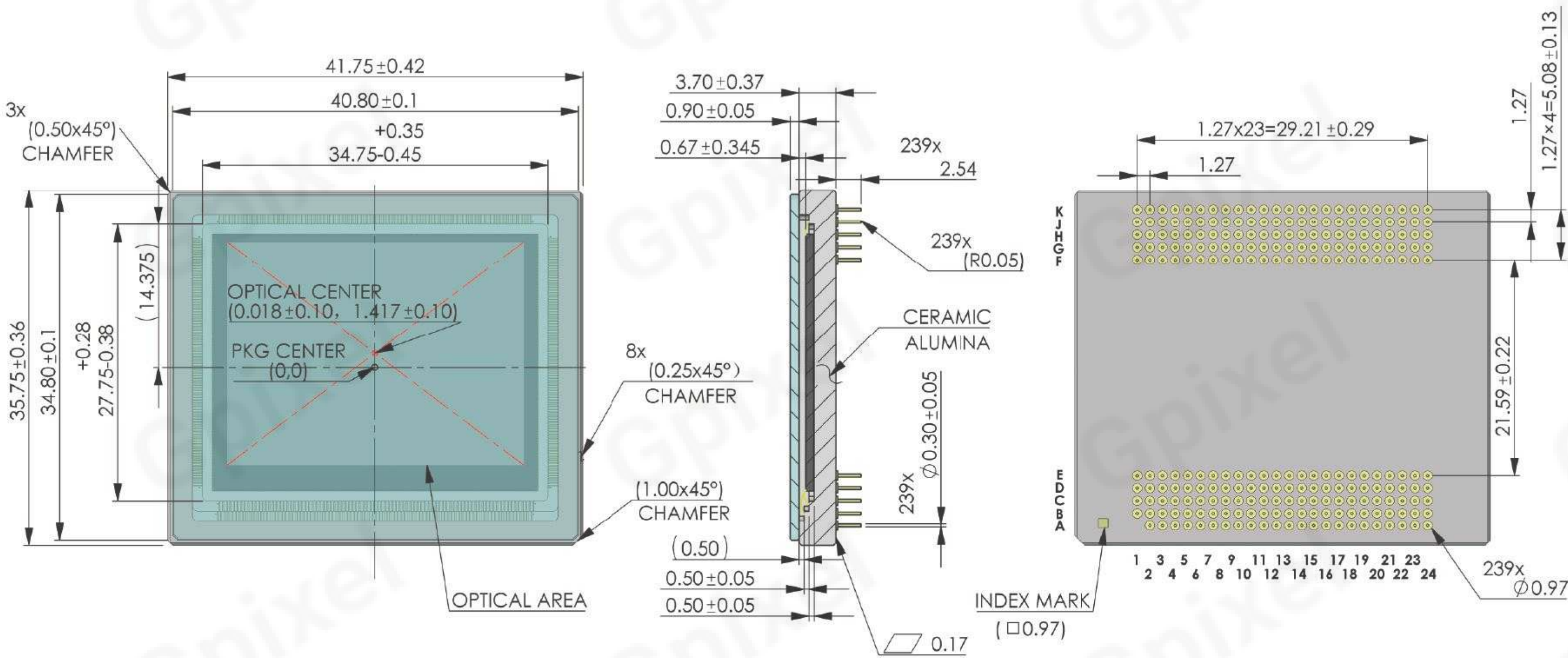
· 低噪声

应用领域

高分辨率工业检测

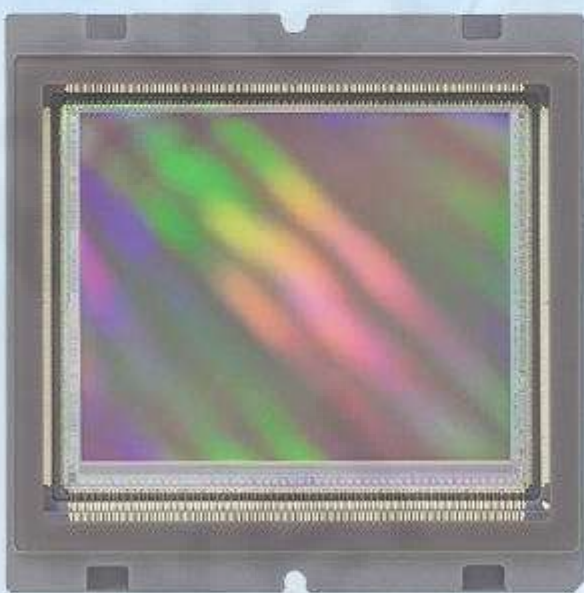
产品指标			
有效分辨率	9344(H) x 7000(V)	光学尺寸	2.3"
像素尺寸	3.2 μm x 3.2 μm	感光面积	29.9 mm x 22.4 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	65.3% (500 nm)
满阱容量	10.6 ke ⁻ (PGA gain 0.75x)	寄生光灵敏度	<-83.5 dB
读出噪声	1.9 e ⁻ (12 bit,PGA gain 6x)、7.5 e ⁻ (10 bit,PGA gain 1.25x)	角度响应	>15° (80% Response)
暗电流	5.3 e ⁻ /pixel/s (40°C)	最大信噪比	40.2 dB (PGA gain 1.0x)
动态范围	66.0 dB (12 bit,PGA gain 1.25x)、62.3 dB (10 bit,PGA gain 1.25x)	最高帧频	71 fps (10 bit)、31 fps (12 bit)
输出接口	56对Sub-LVDS	通道合并	56/28/14/8/7/4/2/1
ADC位数	10/12 bit	最大数据率	50.40 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	<2.1 W (12 bit)、<2.3 W (10 bit)
供电电压	3.3 V/1.3 V(模拟)、1.8 V - 3.3 V(IO)、1.3 V(数字)	封装信息	239 pins μPGA、41.8 mm x 35.8 mm

封装图示



GMAX32103

103MP 全局快门CMOS图像传感器



GMAX32103是一款1.03亿超高分辨率、2.9"光学尺寸的全局快门CMOS图像传感器。芯片采用了电荷域相关双采样(CDS)技术,使其具备低读出噪声、高动态范围的特性。凭借独特的光管技术,使芯片具备优异的快门效率和角度响应。GMAX32103最高帧率可达24 fps,结合1.03亿超高分辨率,可大幅提升检测精度和效率。GMAX32103采用209 pins μPGA陶瓷封装,充分考虑了小型化和散热性,同时芯片封装增加了定位孔,方便用户进行安装。

产品特性

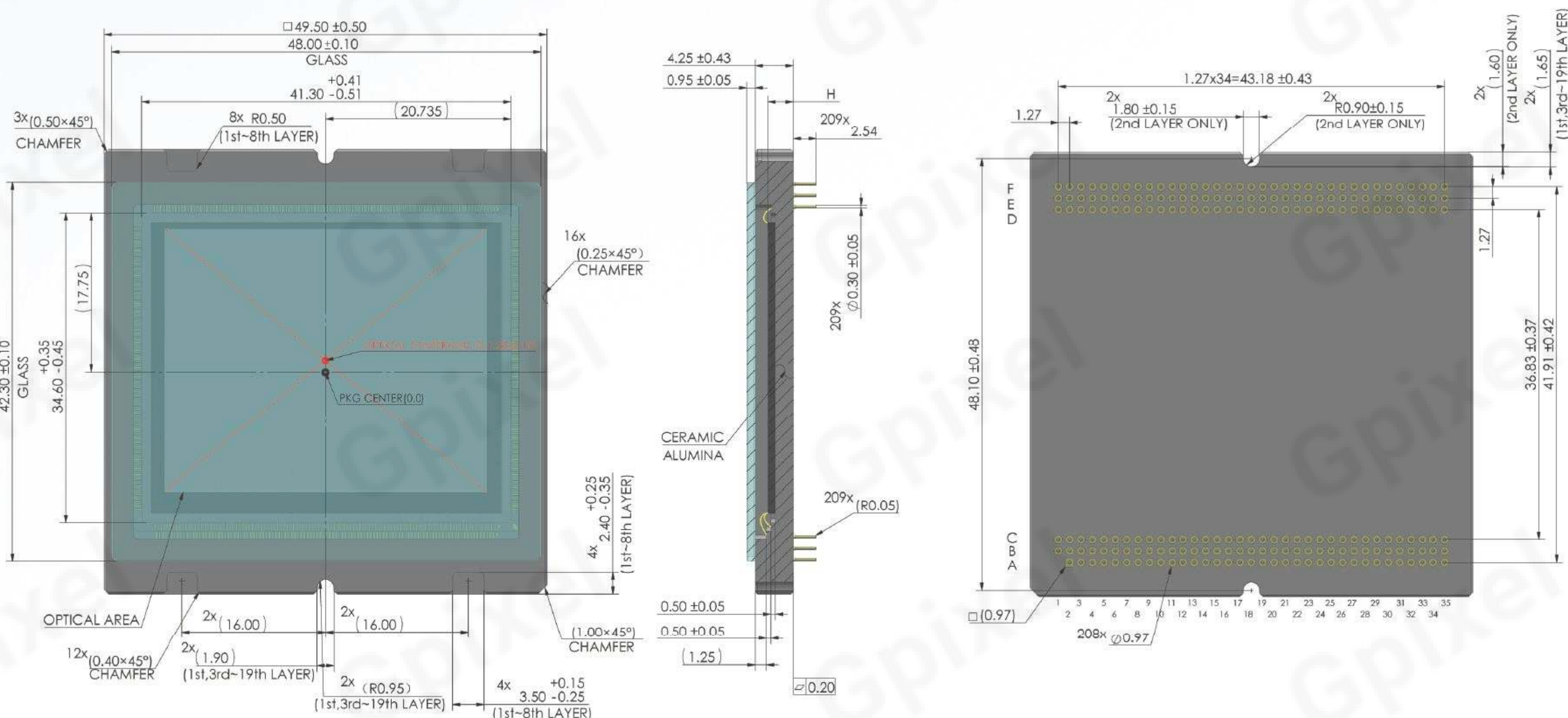
- 3.2 μm全局快门像素
- 大靶面、1.03亿超高分辨率
- 最高帧率:24 fps
- 优异的快门效率和角度响应

应用领域

高分辨率工业检测

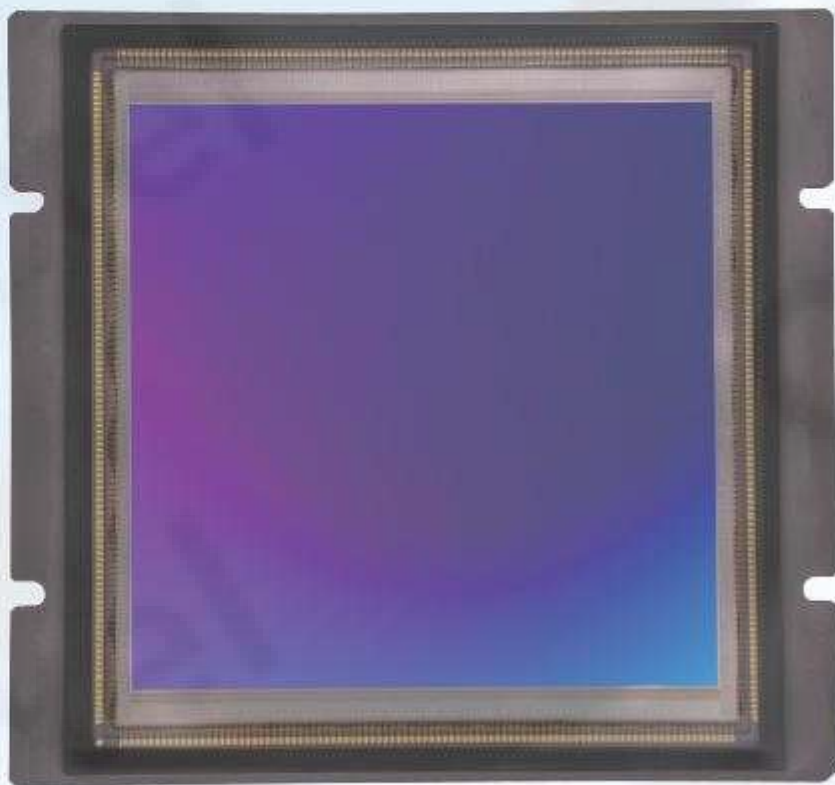
产品指标			
有效分辨率	11276(H) x 9200(V)	光学尺寸	2.9" (中画幅)
像素尺寸	3.2 μm x 3.2 μm	感光面积	36.1 mm x 29.4 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	66.9% (500 nm)
满阱容量	9 ke ⁻ (PGA gain 1.4x)	寄生光灵敏度	<-83.5 dB
读出噪声	4.3 e ⁻ (PGA gain 1.4x)	角度响应	>15° (80% Response)
暗电流	1.4 e ⁻ /pixel/s (30°C)	最大信噪比	39.5 dB (PGA gain 1.4x)
动态范围	66.4 dB (PGA gain 1.4x)	最高帧频	24 fps
输出接口	52对Sub-LVDS	通道合并	52/26/18/14/10/8/6
ADC位数	12 bit	最大数据率	49.92 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	<2.5 W
供电电压	3.3 V/1.3 V(模拟)、1.8 V - 3.3 V(IO)、1.2 V(数字)	封装信息	209 pins μPGA、49.5 mm x 42.3 mm

封装图示



GMAX64104

104MP全局快门CMOS图像传感器



GMAX64104采用6.4 μm的全局快门像素设计,像素分辨率为10240 x 10240, 65.536 mm x 65.536 mm的超大感光面积,可满足航空成像、天文观测等大视场、高精度的应用需求。该产品同时具备低噪声、高灵敏度、高动态范围等优异特性,也可广泛应用于显微成像、生命科学等前沿领域。GMAX64104同时兼容卷帘快门和全局快门。在全局快门下,芯片支持低噪声CDS以及高满阱DDS两种工作模式。GMAX64104采用327 pins PGA陶瓷封装,封装尺寸为93 mm x 87 mm,同时其封装背部留有较大空白空间,以方便相机进行散热设计。

产品特性

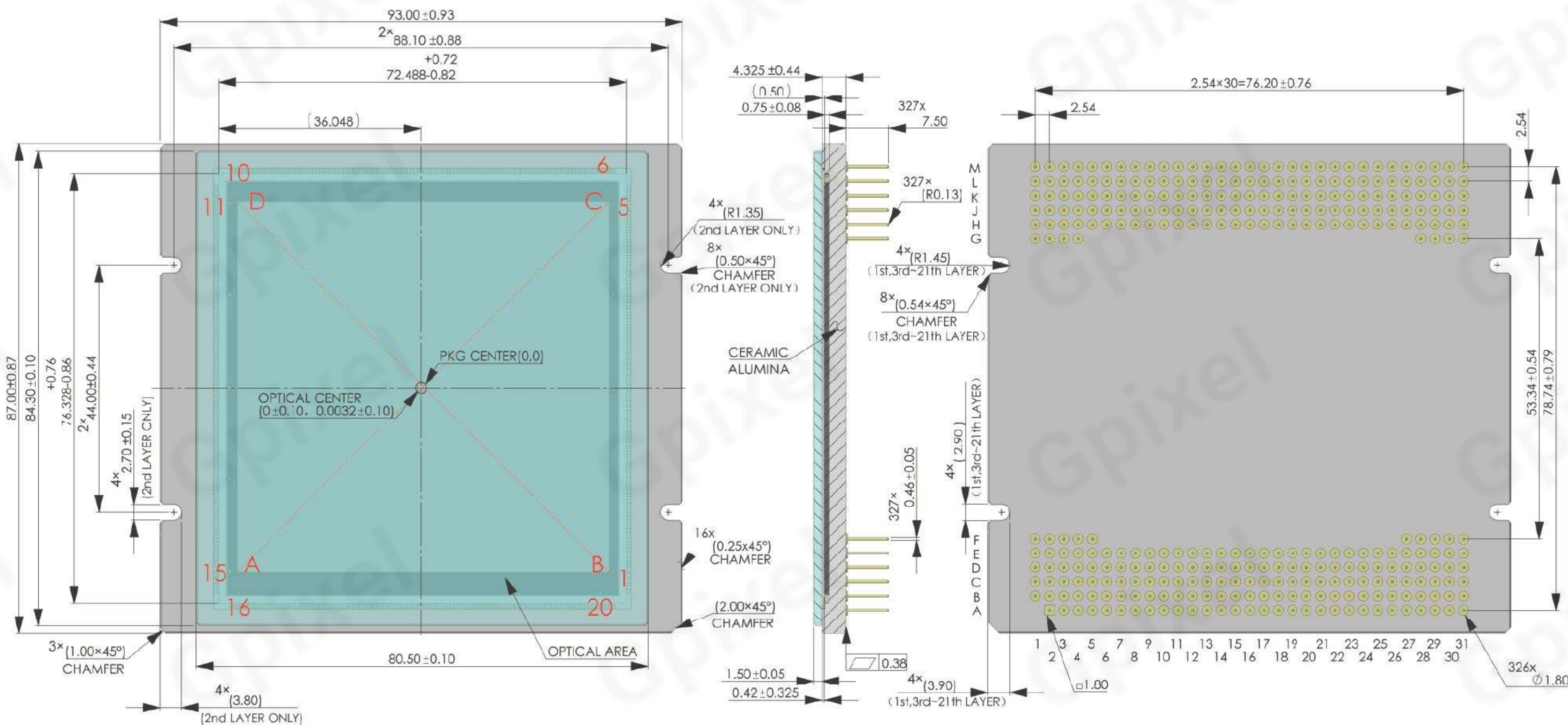
- 全局和卷帘快门兼容
- 大靶面、1亿超高分辨率
- 高灵敏度、高动态范围
- 最高帧频:13.5 fps

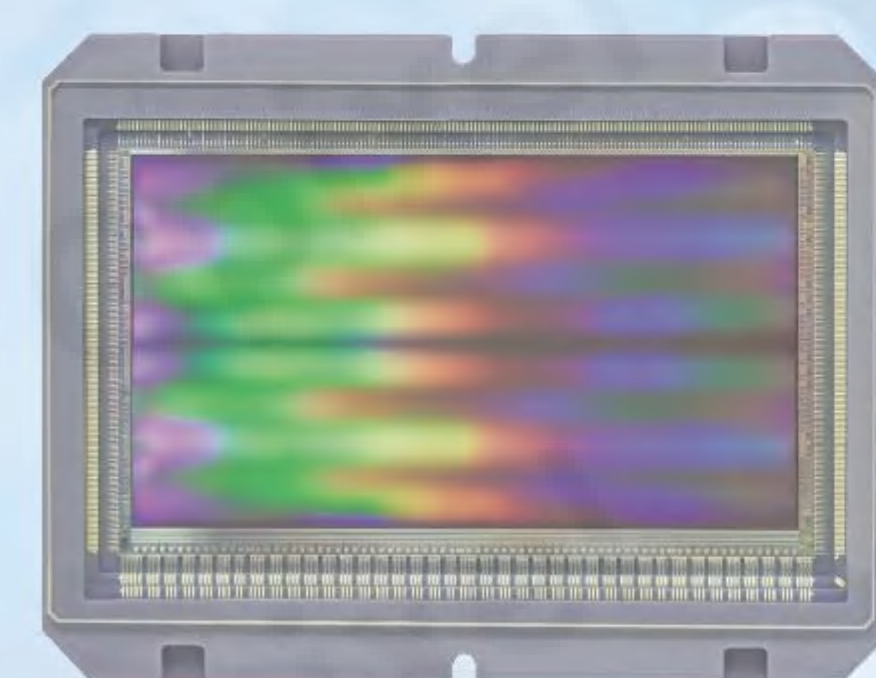
应用领域

航空成像、天文观测、显微成像、生命科学

产品指标			
有效分辨率	10240(H) x 10240(V)	感光面积	65.536 mm x 65.536 mm
像素尺寸	6.4 μm x 6.4 μm	峰值量子效率	≥65%
快门类型	全局快门 & 卷帘快门	寄生光灵敏度	<1:50000
满阱容量	20 ke ⁻ (RS HDR & GS CDS)、65 ke ⁻ (GS DDS)	角度响应	>20° (80% Response)
读出噪声	2.7 e ⁻ (RS HDR)、12.2 e ⁻ (GS CDS)、47 e ⁻ (GS DDS)	最大信噪比	48.1 dB
最高帧频	12 fps (GS)、12 fps (GS DDS)、4.8 fps (RS HDR)	暗电流	≤10 e ⁻ /pixel/s (25°C,GS)
动态范围	77.3 dB (RS HDR)、63 dB (GS)	最大数据率	22.14 Gbps (GS)、44.28 Gbps (RS HDR)
输出接口	41对LVDS (GS)、82对LVDS (RS HDR)	功耗	≤5 W
ADC位数	12 bit	色彩	黑白
供电电压	3.6 V (模拟)/1.2 V (数字)/1.2 V-3.3 V (I/O)	封装信息	327 pins PGA、93.0 mm x 87.0 mm

封装图示

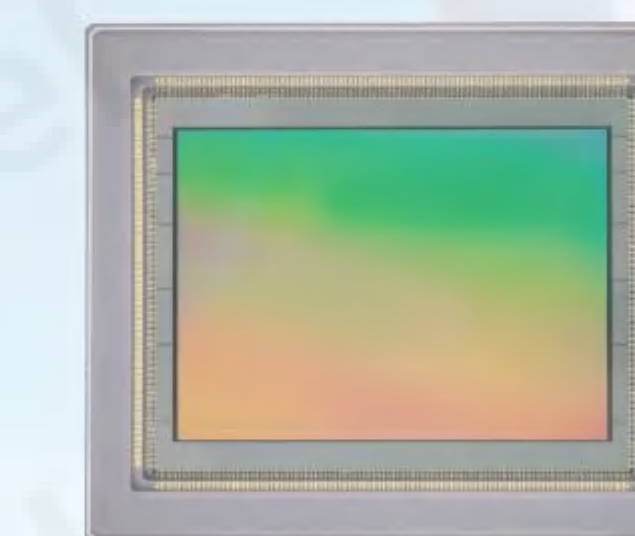
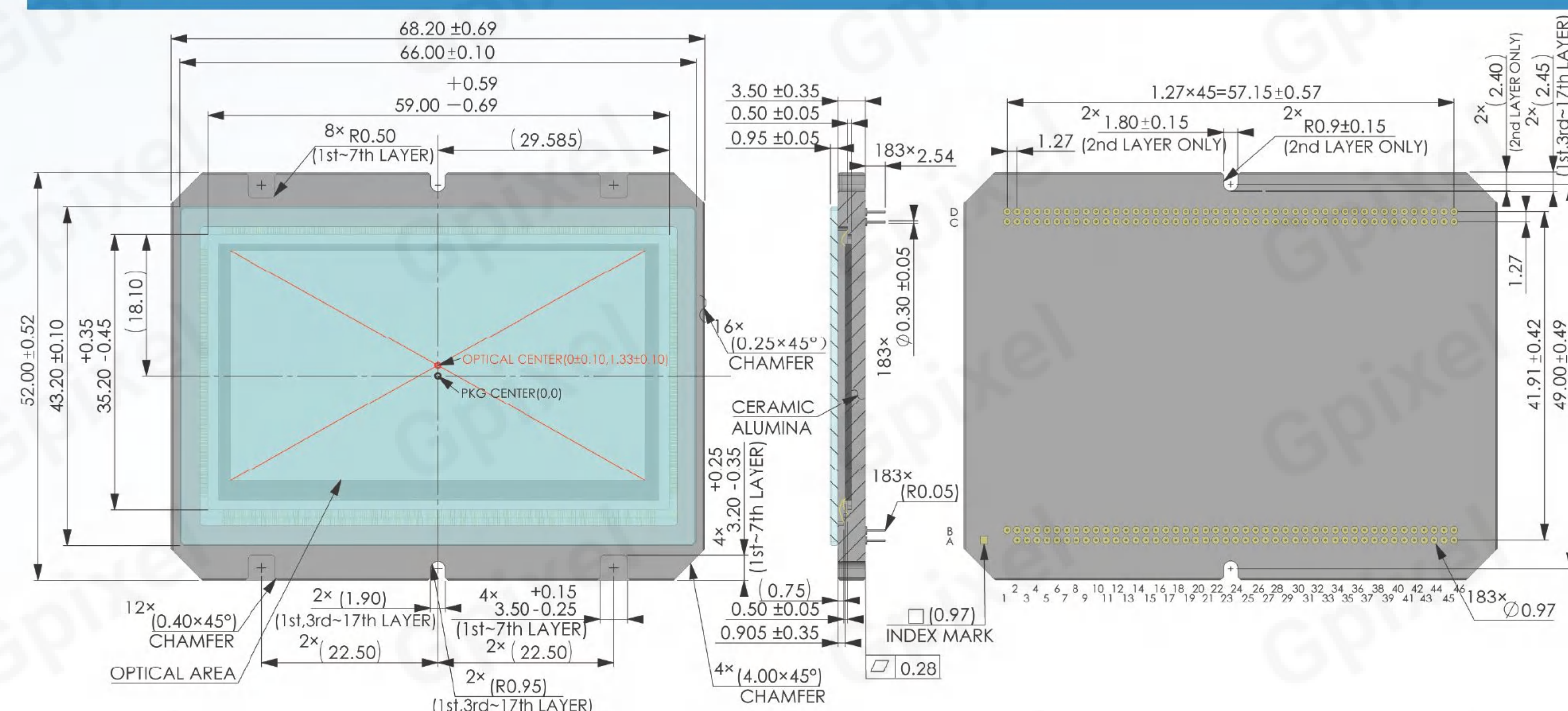




高分辨率工业检测

产品指标			
有效分辨率	16556(H) x 9200(V)	光学尺寸	3.7" (中画幅)
像素尺寸	3.2 μm x 3.2 μm	感光面积	53.0 mm x 29.4 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	66.9% (500 nm)
满阱容量	9.3 ke ⁻ (PGA gain 1.4x)	寄生光灵敏度	<-83.5 dB
读出噪声	4.0 e ⁻ (PGA gain 1.4x)	角度响应	>15° (80% Response)
暗电流	1.4 e ⁻ /pixel/s (30°C)	最大信噪比	39.6 dB (PGA gain 1.4x)
动态范围	67.3 dB (PGA gain 1.4x)	最高帧频	16 fps
输出接口	38对Sub-LVDS	通道合并	38/20/14/11/8/5
ADC位数	12 bit	最大数据率	36.48 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	<2.8 W
供电电压	3.3 V/1.3 V(模拟) 、2.5 V - 3.3 V(IO) 、1.2 V(数字)	封装信息	183 pins μPGA、68.2 mm x 52.0 mm

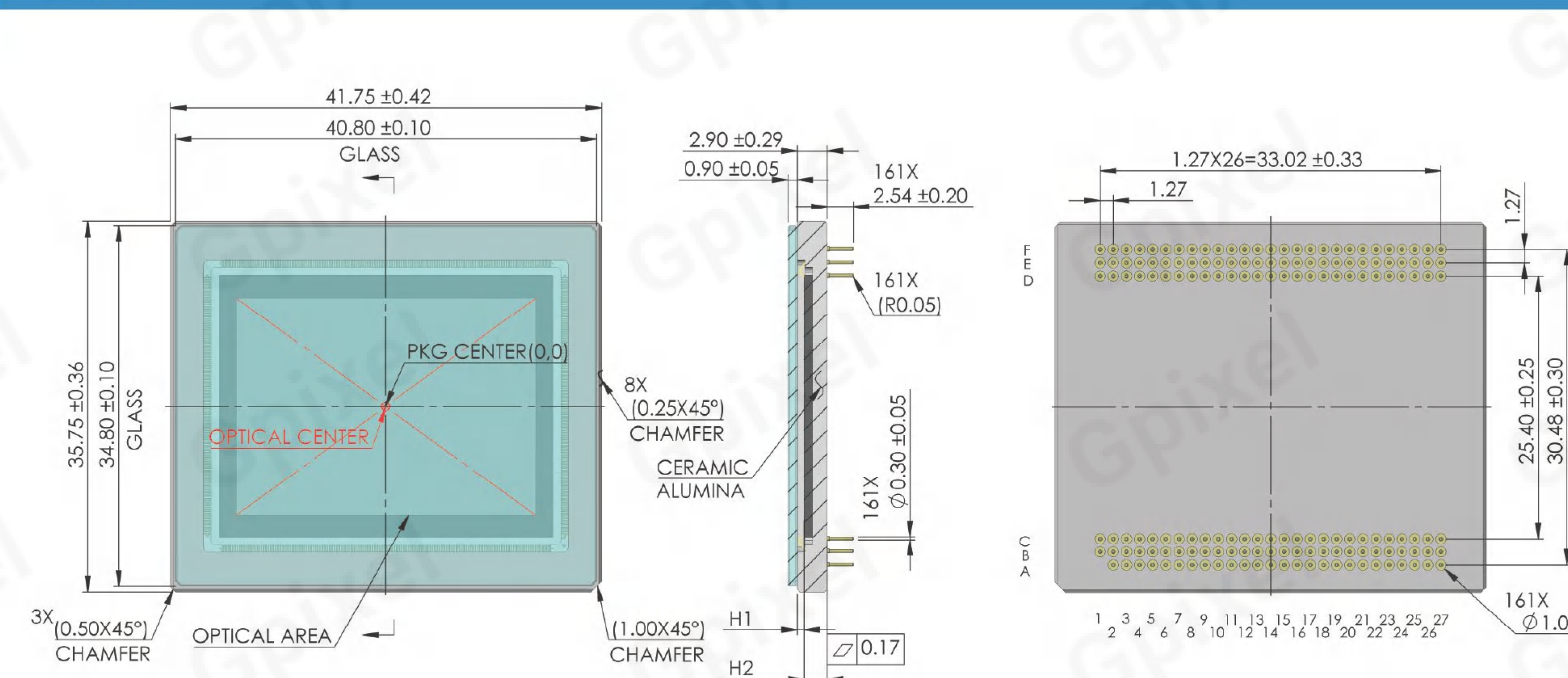
封装图示



高端工业检测、显示屏幕检测、生物显微、基因测序

产品指标			
有效分辨率	19376(H) x 14000(V)	光学尺寸	2.24"
像素尺寸	1.5 μm x 1.5 μm	感光面积	29.1 mm x 21.0 mm
快门类型	卷帘快门(支持全局复位)	峰值量子效率	76.7% (520 nm)
满阱容量	5.4k e ⁻ (14 bit,PGA gain 1.0x)、5.1 ke ⁻ (12 bit,PGA gain 1.0x)	寄生光灵敏度	-
读出噪声	1.1 e ⁻ (14 bit,PGA gain 4.1x)、1.7 e ⁻ (12 bit,PGA gain 4.1x)	角度响应	>17° (80% Response)
最大信噪比	37.3 dB (14 bit,PGA gain 1.0x)、37.0 dB (12 bit,PGA gain 1.0x)	暗电流	2.5 e ⁻ /pixel/s (42 °C)
动态范围	73.8 dB (14 bit,PGA gain 1.0x)、69.5 dB (12 bit,PGA gain 1.0x)	ADC	12/14 bit
输出接口	32对Sub-LVDS数据输出接口、2对Sub-LVDS时钟输出接口	通道合并	32/16/8/4 (Sub-LVDS)
最高帧频	4.8 fps (14 bit,1.2G Sub-LVDS)、8.5 fps (12 bit,1.2G Sub-LVDS)	色彩	黑白 & 彩色
最大数据率	19.2 Gbps (14 bit,Sub-LVDS)、38.4 Gbps (12 bit,Sub-LVDS)	功耗	< 2.6 W (14 bit)、< 3.0 W (12 bit)
供电电压	4.5 V 和 -2.0 V (像素),3.3 V (模拟),1.8 V – 3.3 V (IO),1.2 V (数字)	封装信息	161 pins μPGA、41.75 mm x 35.75 mm

封装图示





GMAX
GSPRINT
GSENSE
GLUX
GTOF
GCINE
GL
GXS
GIR

面阵CMOS图像传感器

GSPRINT 系列

GSPRINT系列是长光辰芯推出的面向高速成像领域的高速、全局快门产品。该系列以其高帧频、低噪声以及高动态范围等特性,为4K高速摄影、工业自动光学检测(AOI)、运动捕捉等多种应用提供了理想的解决方案。GSPRINT系列产品可根据需求快速开发不同分辨率、不同靶面的产品,为用户提供多样化、一站式选择方案。

GSPRINT6502BSI	GSPRINT4502	GSPRINT4510
GSPRINT5514BSI	GSPRINT4521	

GSPRINT 系列特点

全局快门	2MP-21MP的分辨率
超高速	低噪声

主要应用

工业检测、激光测量、运动捕捉、高速摄影



GSPRINT6502BSI

2MP高速全局快门背照式CMOS图像传感器



GSPRINT6502BSI是一款背照式、全局快门产品，具备高速、高量子效率、大角度响应等优异特性，专为激光三维轮廓仪相关应用而设计。GSPRINT6502BSI采用6.5 μm背照式全局快门像素设计，有效分辨率为2048(H) x 1152(V)，光学尺寸为1英寸。该产品采用了32对Sub-LVDS进行数据传输，其最高帧频可达1500 fps。GSPRINT6502BSI还支持片上1 x 2 像素合并，其帧频可以提升2倍。

GSPRINT6502BSI采用了背照式加工工艺，产品不仅具有更高的量子效率，同时也可以获得更优异的角度响应特性，其峰值量子效率大于85%，同时在405 nm波段，其量子效率大于70%。另外，即使在极大沙姆角的情况下，芯片仍能保持较高的灵敏度，进而提升激光线的提取精度。GSPRINT6502BSI片上集成多斜率HDR功能，在该模式下，其动态范围 可以达到90 dB以上,能够满足高反射物体的检测需求。

- 产品特性
- 背照式

· 多斜率HDR

· 高速
- 高量子效率

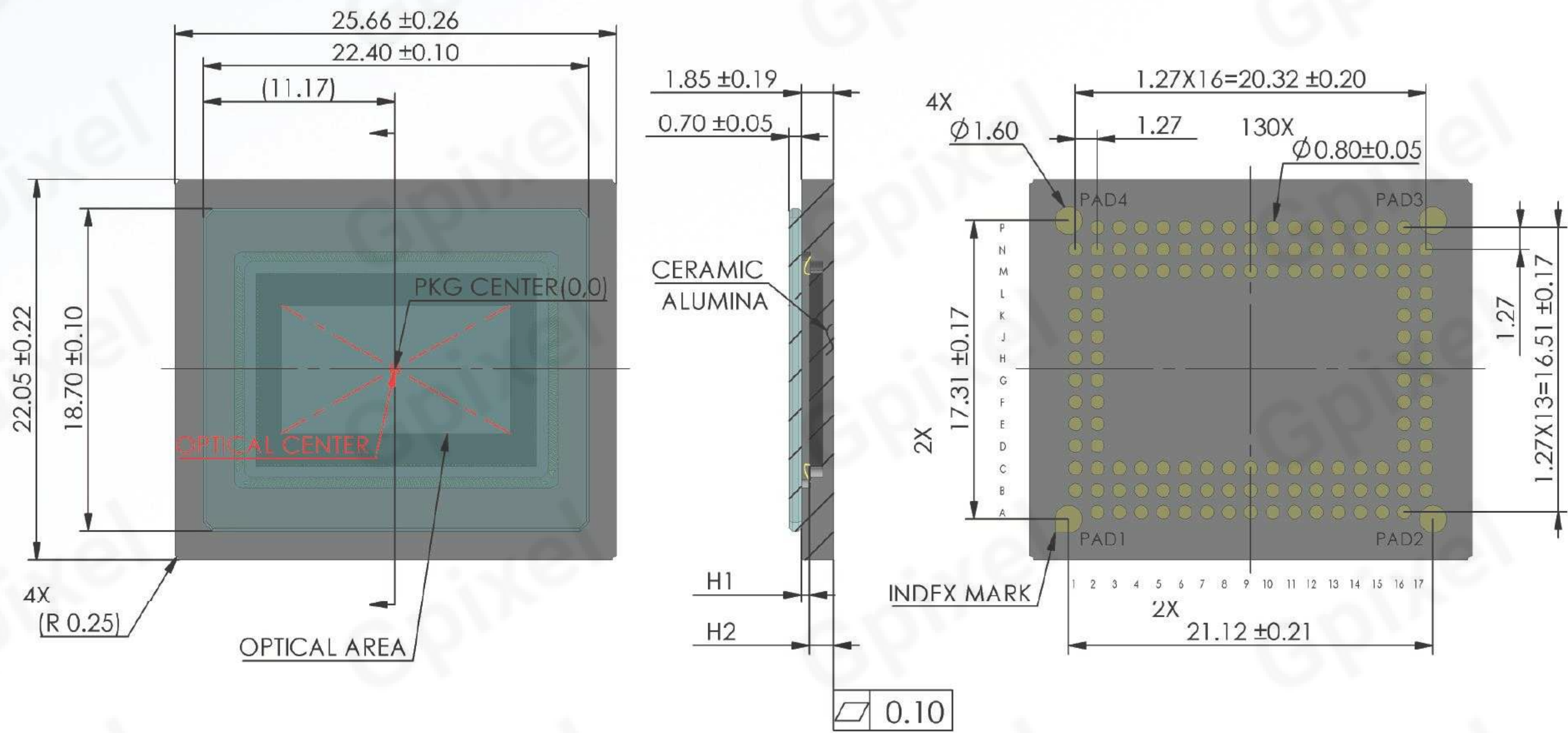
· 大角度响应

应用领域

激光三维轮廓仪

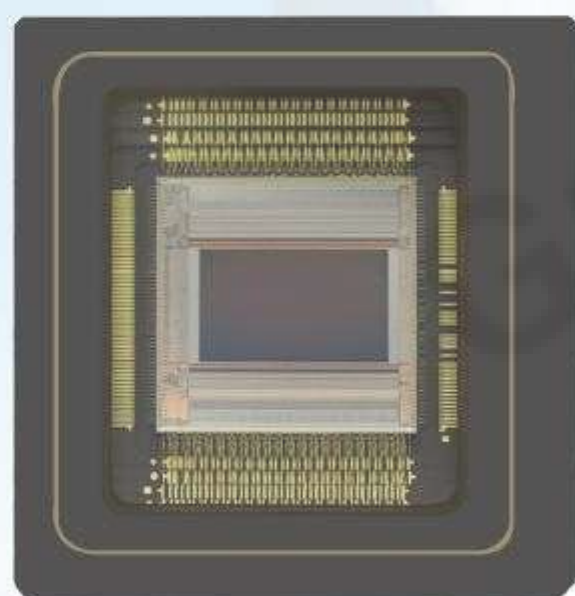
产品指标			
有效分辨率	2048 (H) x 1152 (V)	光学尺寸	1"
像素尺寸	6.5 μm x 6.5 μm	感光面积	13.3 mm x 7.5 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	86% (440 nm)
满阱容量	10.1 ke ⁻ (10 bit, PGA gain x1.0)	角度响应	35 ° (80% Response)
读出噪声	21.4 e ⁻ (10 bit,PGA gain 1.0x)	最大信噪比	40.0 dB
动态范围	53.4 dB (10 bit, PGA gain x1.0)	输出接口	32对Sub-LVDS
最高帧频	1498 fps (10 bit)、2941 fps (10 bit,1x2 Binning)	通道合并	支持 (以2通道为步进)
ADC	10 bit	最大数据率	38.4 Gbps
色彩	黑白	功耗	1.5 W
供电电压	3.6 V/3.3 V (模拟)、1.8 V/3.3 V (IO)、1.5 V (数字)	封装信息	130 pins LGA、25.66 mm x 22.05 mm

封装图示



GSPRINT4502

2.5MP 高速全局快门 CMOS图像传感器



GSPRINT4502是一款250万像素分辨率、2/3"光学尺寸的高速全局快门CMOS图像传感器。凭借独特的光管技术，使芯片具备优异的快门效率和角度响应。GSPRINT4502具备超高速性能，全分辨率下最高帧率可达3462 fps，结合2 x 2像素合并模式，可将最高帧率提升至11669 fps。

- 产品特性
- 4.5 μm全局快门像素

· 读出噪声<3.8 e⁻

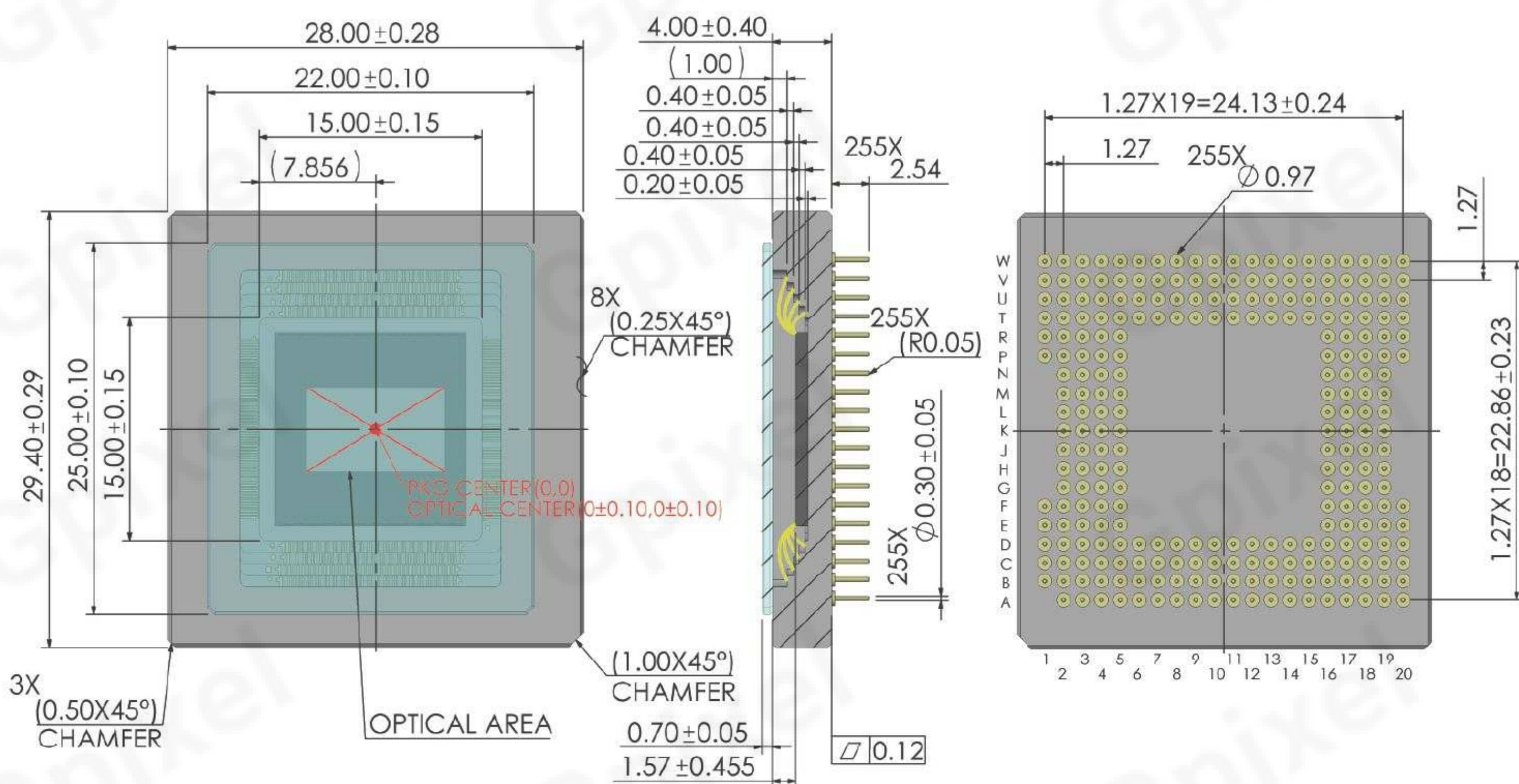
· 最高帧率:3462 fps
- 支持纵向开窗，帧率按比例提高

应用领域

工业检测、激光测量、运动捕捉、高速摄影

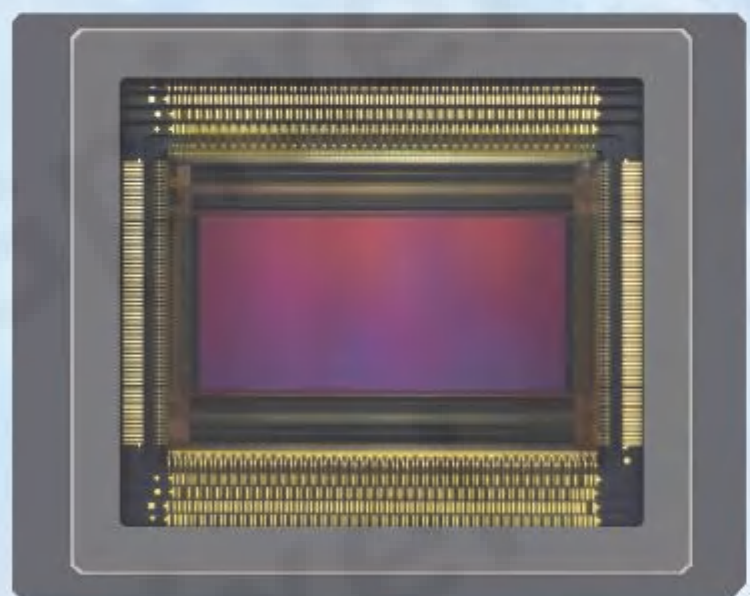
产品指标			
有效分辨率	2048(H) x 1216(V)	光学尺寸	2/3"
像素尺寸	4.5 μm x 4.5 μm	感光面积	9.21 mm x 5.47 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	65.7% (515 nm)
满阱容量	>30 ke ⁻	寄生光灵敏度	-84.6 dB
读出噪声	3.8 e ⁻	角度响应	20° (80% Response)
暗电流	21 e ⁻ /pixel/s (60°C)	最大信噪比	44.8 dB
最高帧频	3462 fps (8 bit)、1782 fps (10 bit)、852 fps (12 bit)	动态范围	68.2 dB (12 bit)
输出接口	64对Sub-LVDS	通道合并	支持 (以4通道为步进)
ADC	8/10/12 bit	最大数据率	76.8 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	2.5 W
供电电压	3.3 V(模拟) 、1.8 V(IO) 、1.2 V(数字)	封装信息	255 pins μPGA、28 mm x 29.4 mm

封装图示



GSPRINT4510

10MP 高速全局快门 CMOS图像传感器



GSPRINT4510是一款1000万像素分辨率、4/3"光学尺寸的高速全局快门CMOS图像传感器。凭借独特的光管技术,使芯片具备优异的快门效率和角度响应。GSPRINT4510采用144对Sub-LVDS通道进行数据输出,全分辨率下最高帧率可高达1920 fps,结合片上2 x 2像素合并模式,可将最高帧率提升4倍左右。GSPRINT4510可提供针对超大入射角度激光测量的ulens shift版本。

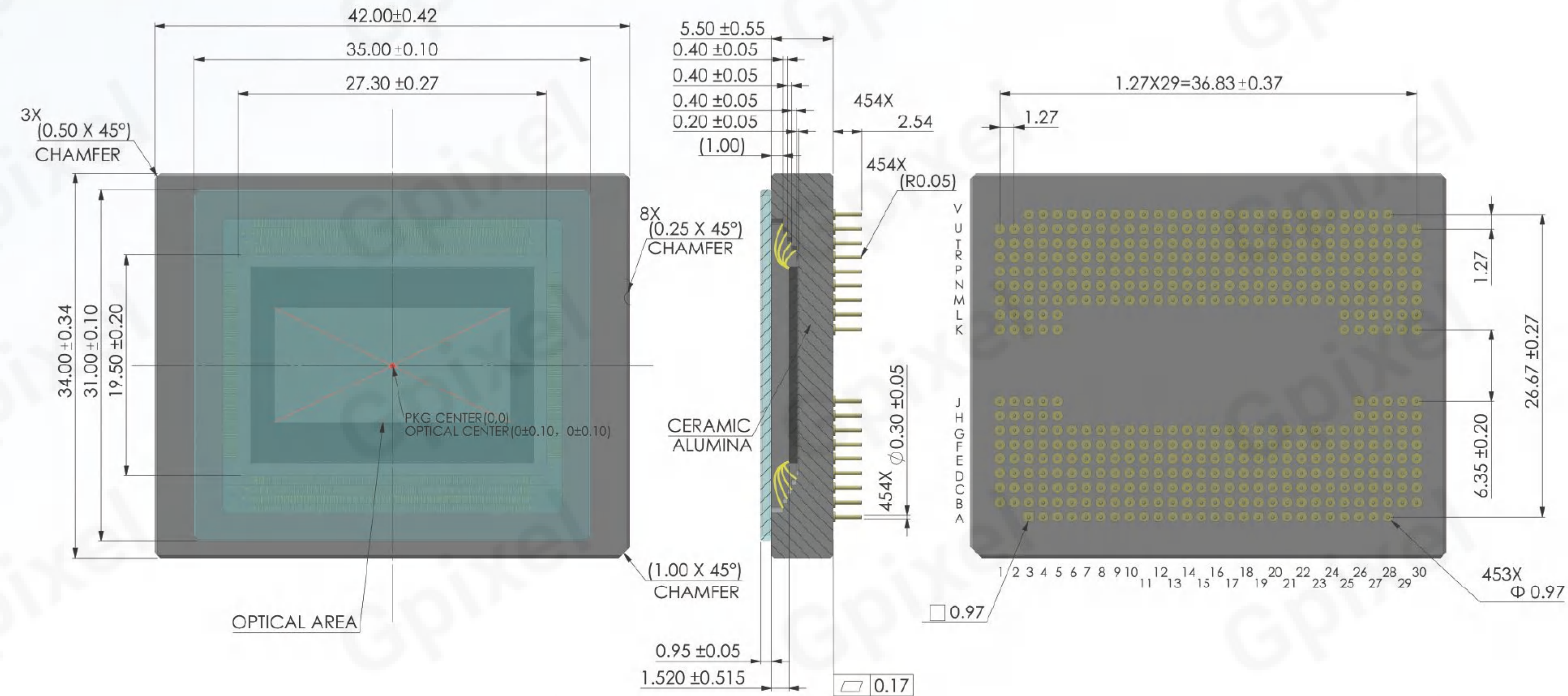
- 产品特性
- 4.5 μm全局快门像素
 - 读出噪声< 4 e⁻
 - 最高帧率:1920 fps
 - 支持纵向开窗,帧率按比例提高

应用领域

工业检测、激光测量、运动捕捉、高速摄影

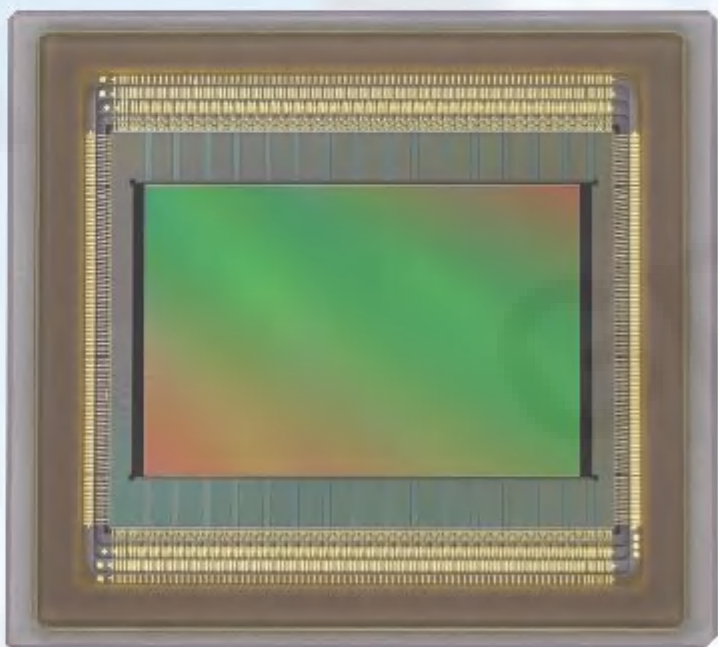
产品指标			
有效分辨率	4608(H) x 2176(V)	光学尺寸	4/3"
像素尺寸	4.5 μm x 4.5 μm	感光面积	20.74 mm x 9.79 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	> 67% (550 nm)
满阱容量	>30 ke ⁻	寄生光灵敏度	<-86 dB
读出噪声	<4 e ⁻	角度响应	20° (80% Response)
暗电流	11.4 e ⁻ /pixel/s (50°C)	最大信噪比	44.7 dB
最高帧频	1920 fps (8 bit)、1000 fps (10 bit)、480 fps (12 bit)	动态范围	68 dB (12 bit)
输出接口	144对Sub-LVDS	通道合并	支持 (以4通道为步进)
ADC	8/10/12 bit	最大数据率	172.8 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	2.5 W
供电电压	3.3 V(模拟)、1.8 V(IO)、1.2 V(数字)	封装信息	454 pins μPGA、42 mm x 34 mm

封装图示



GSPRINT5514BSI

14MP 高速背照式全局快门 CMOS图像传感器



GSPRINT5514BSI继承了GSPRINT系列高帧频、高动态的特性。该产品支持12 bit和10 bit ADC输出,其帧频分别为350 fps和670 fps,最高数据率达到94.84 Gbps,完美匹配目前市场上最先进的100GiE相机接口。同时,为解决某些行业面临的高反射物体成像的问题,GSPRINT5514BSI支持双增益HDR (Dual Gain HDR),其动态范围最高可达78.2 dB。GSPRINT5514BSI的以上特性,也使得其成为3D AOI、SPI等结构光工业方案,以及高速摄影领域的理想选择。GSPRINT5514BSI兼顾了芯片在紫外以及近红外的响应。芯片区分带有微透镜和不带微透镜的两个版本,不带微透镜的版本芯片,其在200-300 nm之间,平均量子效率达到20%。对于带微透镜的芯片,兼顾了可见光和近红外的应用,在800 nm波长下,量子效率达到40%以上。GSPRINT5514BSI采用454 pins 陶瓷μPGA封装,封装尺寸为42.00 mm x 38.00 mm,且管脚与GSPRINT4510、GSPRINT4521兼容,更加方便老用户的开发集成。芯片提供黑白和彩色两个版本。

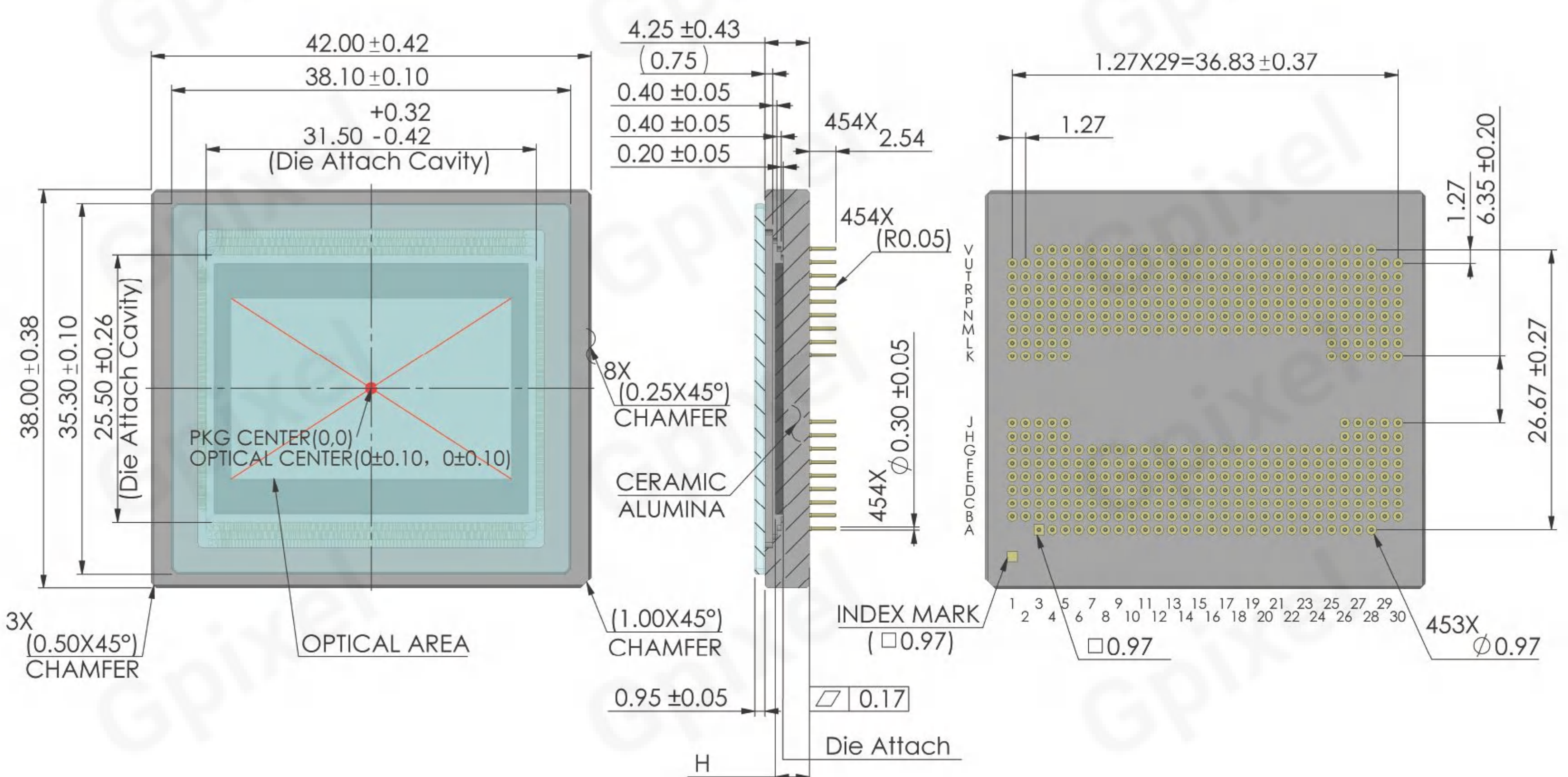
- 产品特性
- 背照式
 - 高帧频
 - 低噪声
 - 峰值量子效率83%
 - 高灵敏度

应用领域

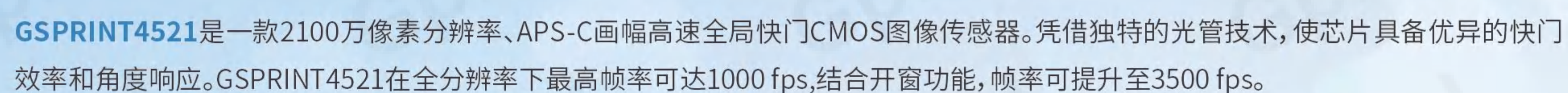
工业检测、激光测量、运动捕捉、高速摄影

产品指标			
有效分辨率	4608 (H) x 3072 (V)	光学尺寸	APS-C
像素尺寸	5.5 μm x 5.5 μm	感光面积	25.34 mm x 16.90 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	83%
满阱容量	15 ke ⁻	寄生光灵敏度	<-80 dB
读出噪声	<1.84 e ⁻ (12 bit,双增益HDR & 12 bit,gain 4)	角度响应	30° (80% Response)
暗电流	54.2 e ⁻ /pixel/s (60°C)	最大信噪比	41.79 dB (12 bit, gain 0)
最高帧频	670 fps (10 bit)、350 fps (12 bit)、80 fps (12 bit,双增益HDR)	输出接口	84对 Sub-LVDS
动态范围	78.2 dB (Dual 12 bit)、66.4 dB (12 bit)、61.9 dB (10 bit)	通道合并	支持 (以4通道为步进)
ADC	10/12 bit	最大数据率	94.84 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	最大3.4 W (待机模式)、最大4.94 W (连续出图)
供电电压	3.3 V(模拟)、1.8 V(IO)、1.2 V(数字)	封装信息	454 pins μPGA、42 mm x 38 mm

封装图示



21MP 高速全局快门 CMOS图像传感器



- 4.5 μm 全局快门像素
- 读出噪声 $<4\text{e}^-$
- 最高帧率:1000 fps
- 支持纵向开窗, 帧率按比例提高

工业检测、激光测量、运动捕捉、高速摄影

Figure 1: Mechanical drawing of the optical assembly. The drawing shows a top view and a side view. The top view includes dimensions for the optical area (39.70 ± 0.10, 29.85 ± 0.30), the ceramic alumina layer (42.00 ± 0.42), and the optical center (0,0). The side view shows the thickness of the ceramic alumina (1.520 ± 0.515) and the optical area (1.27). The drawing also includes a table of dimensions for the optical area and the ceramic alumina layer.



GMAX
GSPRINT
GSENSE
GLUX
GTOF
GCINE
GL
GXS
GIR

面阵CMOS图像传感器

GSENSE 系列

GSENSE系列产品是长光辰芯推出的世界领先的科学级CMOS芯片, 该系列产品具备低噪声、高动态高灵敏等特性, 通过先进的背照式工艺, 使其可获得高达97%的峰值量子效率。该系列产品面向高端科学成像应用而开发, 主要应用领域包括生命科学、医疗成像、光谱学、天文、高能物理和软X射线等领域。

GSENSE2020BSI	GSENSE6504BSI
GSENSE4040	GSENSE4040BSI
GSENSE6060	GSENSE6060BSI
GSENSE3243BSI	GSENSE6510BSI
GSENSE1081BSI	GSENSE1517BSI
GSENSE400BSI	

GSENSE系列特点

大靶面	背照式	高灵敏度
高动态	低噪声	

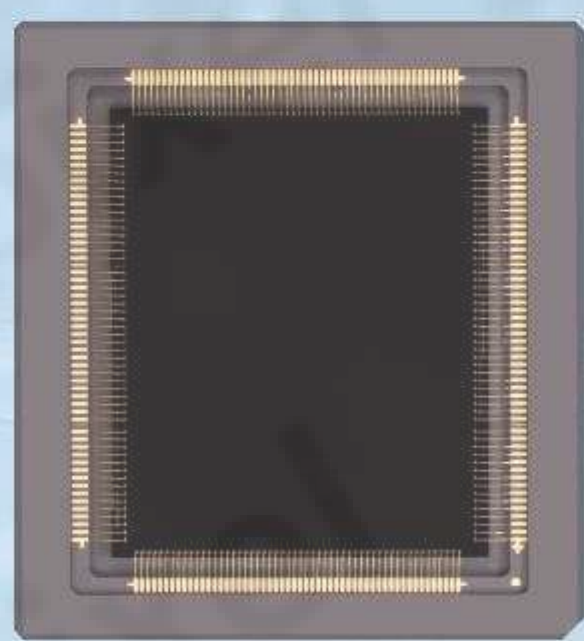
主要应用

生命科学、显微成像、医疗成像、多光谱分析、高能物理、天文成像



GSENSE2020BSI

4MP 科学级 背照式CMOS图像传感器



GSENSE2020BSI是一款400万像素分辨率、1.2"光学尺寸的科学级、背照式CMOS图像传感器。芯片采用了先进的背照式加工技术，峰值量子效率可达95%。通过相关多采样技术(CMS),读出噪声仅为1.2 e⁻,动态范围可达90.5 dB。GSENSE2020BSI支持全局复位卷帘曝光,具备高帧率特性,为高性能紫外工业检测、电晕检测、刑侦指纹等应用提出了全新的解决方案。

- 产品特性
- 像素尺寸:6.5 μm

· 峰值量子效率:95%

· 暗电流:0.07 e⁻/pixel/s (-30°C)

· 优异的近红外及紫外响应

· 读出噪声:1.2 e⁻ (CMS),1.6 e⁻ (HDR,HG)

· 片上温度传感器、SPI控制

· 高灵敏度

· 动态范围: 90.5 dB

应用领域

生命科学、显微成像、UV工业检测、天文成像、电晕检测

产品指标			
有效分辨率	2048(H) x 2048(V)	光学尺寸	1.2"
像素尺寸	6.5 μm x 6.5 μm	感光面积	13.3 mm x 13.3 mm
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	95% (560 nm)
满阱容量	55 ke ⁻ (HDR LG)	读出噪声	1.2 e ⁻ (CMS)、1.6 e ⁻ (HDR,LG)
暗电流	0.07 e ⁻ /pixel/s (-30°C)	动态范围	90.5 dB
最高帧频	43 fps (12 bit)、74 fps (11 bit)	输出接口	8对LVDS (12 bit)、16对LVDS (11 bit)
最大数据率	9.6 Gbps (11 bit)	ADC	11/12 bit
色彩	黑白	功耗	<1.2 W
供电电压	3.5 V(模拟)、2.0 V(数字)	封装信息	153 pins μPGA、26.1 mm x 29.5 mm
封装图示			

GSENSE6504BSI

4MP 科学级 背照式CMOS图像传感器



GSENSE6504BSI是一款2048×2048 (4.2 MP) 分辨率的背照式科学级CMOS图像传感器,像素尺寸6.5 μm x 6.5 μm,搭配卷帘快门设计。感光区对角线尺寸18.8毫米,峰值量子效率达95%。在双增益HDR模式下,芯片可支持最大帧频170 fps,0.9 e⁻ 噪声及84.4 dB 动态范围。芯片支持单增益高速模式,最快帧频300 fps,读出噪声0.8 e⁻。在片温-30°C下,暗电流仅0.004 e⁻/s/p。GSENSE6504BSI机械封装与GSENSE2020BSI完全兼容,可轻松集成至现有相机平台。

- 产品特性
- 背照式

· 峰值量子效率 95%

· 低读出噪声 0.9 e⁻

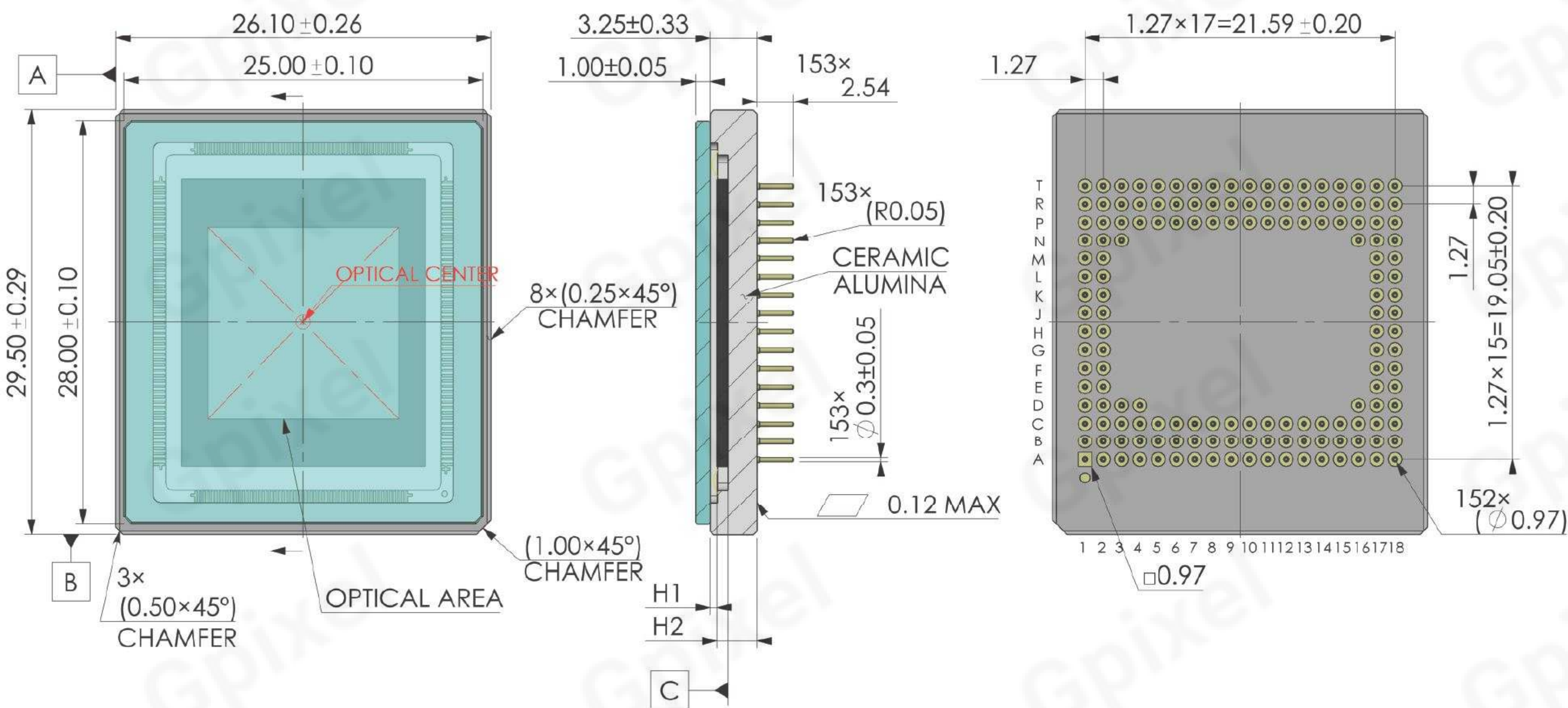
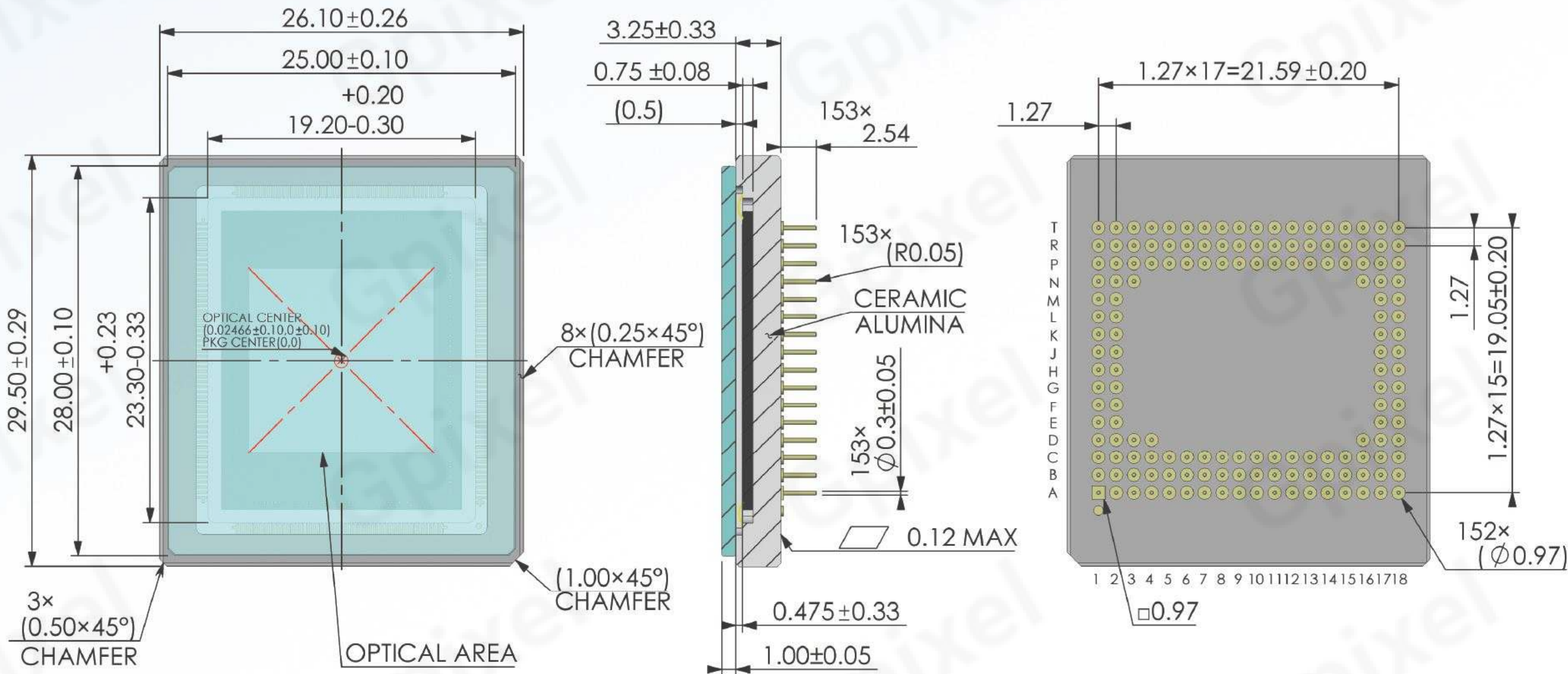
· 低暗电流 0.004 e⁻/s/p (-30°C)

· 高帧频 300 fps

应用领域

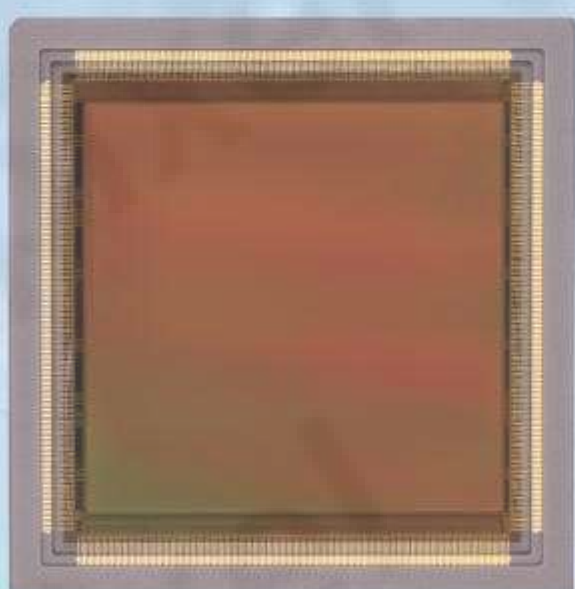
生命科学、显微成像、天文成像、半导体检测

产品指标			
有效分辨率	2048(H) x 2048(V)	光学尺寸	1.2 " / 18.8 mm
像素尺寸	6.5 μm x 6.5 μm	感光面积	13.3 mm x 13.3 mm
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	95% (450 nm)
满阱容量	13.4 ke ⁻	读出噪声	0.9 e ⁻ (rms) (HDR)
暗电流	0.004 e ⁻ /pixel/s (-30°C)	动态范围	84.4 dB(rms) (HDR)
最高帧频	170 fps (HDR)、300 fps (STD)	输出接口	16 x Sub-LVDS
最大数据率	19.2 Gbps	ADC	12 bit
色彩	黑白	功耗	2 W
供电电压	3.3 V (模拟)、1.5 V (数字)、1.8 V — 3.3 V (IO)	封装信息	153 pins μPGA、26.1 mm x 29.5 mm
封装图示			



GSENSE4040

16.8MP 科学级 CMOS图像传感器



GSENSE4040是一款1680万像素分辨率、3.3"光学尺寸的科学级CMOS图像传感器。该芯片采用5T-HDR像素结构、9 μm像素尺寸,在HDR模式下读出噪声仅为3.7 e⁻,动态范围高于86 dB。芯片在2 x 2像素合并模式下,最高帧率可提升至96 fps。GSENSE4040可提供无微透镜可拆卸玻璃盖和带微透镜密封玻璃盖两种版本,前者适用于X射线成像、带电粒子检测,后者适用于医疗成像和天文成像。

- 产品特性
- 像素尺寸:9 μm

· 最高帧率:24 fps

· 满阱容量:74.2 ke⁻

· 功耗 : <1.4 W

· 动态范围 :86 dB

· 读出噪声:3.7 e⁻

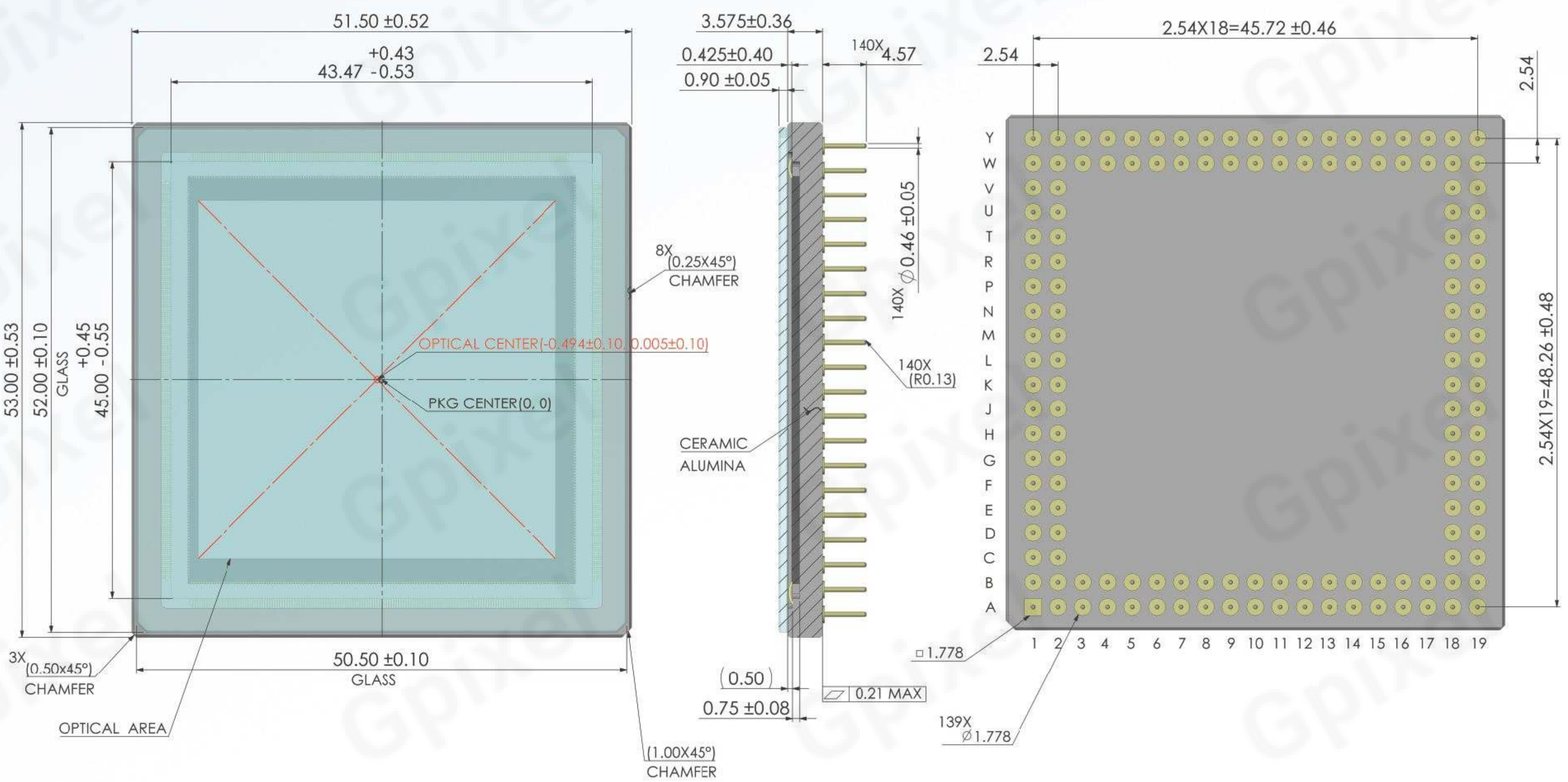
· 片上温度传感器、SPI控制、PLL

应用领域

生命科学、显微成像、医疗成像、天文成像

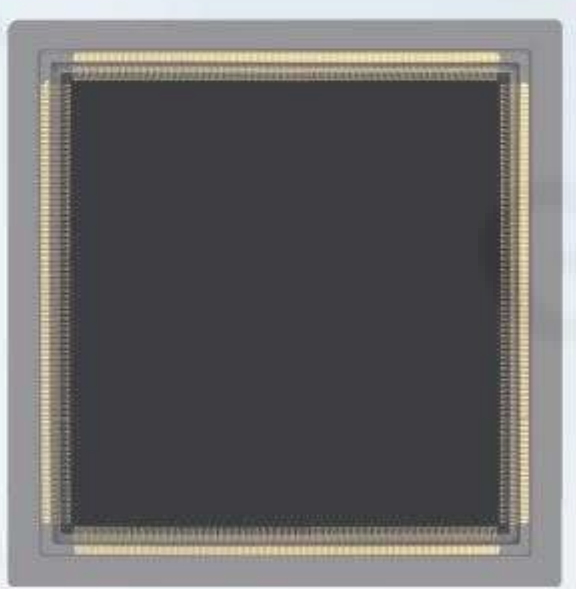
产品指标			
有效分辨率	4096(H) x 4096(V)	光学尺寸	3.3"
像素尺寸	9 μm x 9 μm	感光面积	36.864 mm x 36.864 mm
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	73.9% (600 nm)
满阱容量	74.2 ke ⁻	读出噪声	3.7 e ⁻
暗电流	12.2 e ⁻ /pixel/s (25°C)	动态范围	86 dB
最高帧频	24 fps	输出接口	18对LVDS
最大数据率	10.8 Gbps	ADC	12 bit
色彩	黑白	功耗	<1.4 W
供电电压	3.3 V(模拟)、1.8 V(数字)	封装信息	140 pins PGA、51.5 mm x 53 mm

封装图示



GSENSE4040BSI

16.8MP 科学级 背照式CMOS图像传感器



GSENSE4040BSI是一款1680万像素分辨率、3.3"光学尺寸的科学级、背照式CMOS图像传感器。芯片采用背照式加工工艺,峰值量子效率高达90%。GSENSE4040BSI支持双增益HDR,单幅动态范围可达84.6 dB,读出噪声仅为2.3 e⁻。其优异的光电性能,可满足微弱信号的探测需求。芯片采用18对LVDS通道进行数据输出,全分辨率下最高帧率可达24 fps。GSENSE4040BSI和GSENSE4040FSI管脚兼容,采用高可靠性的140 pins PGA 陶瓷封装,具有良好的散热能力。

- 产品特性
- 像素尺寸:9 μm

· 最高帧率:24 fps

· 满阱容量:39.2 ke⁻

· 动态范围 :84.6 dB

· 读出噪声:2.3 e⁻

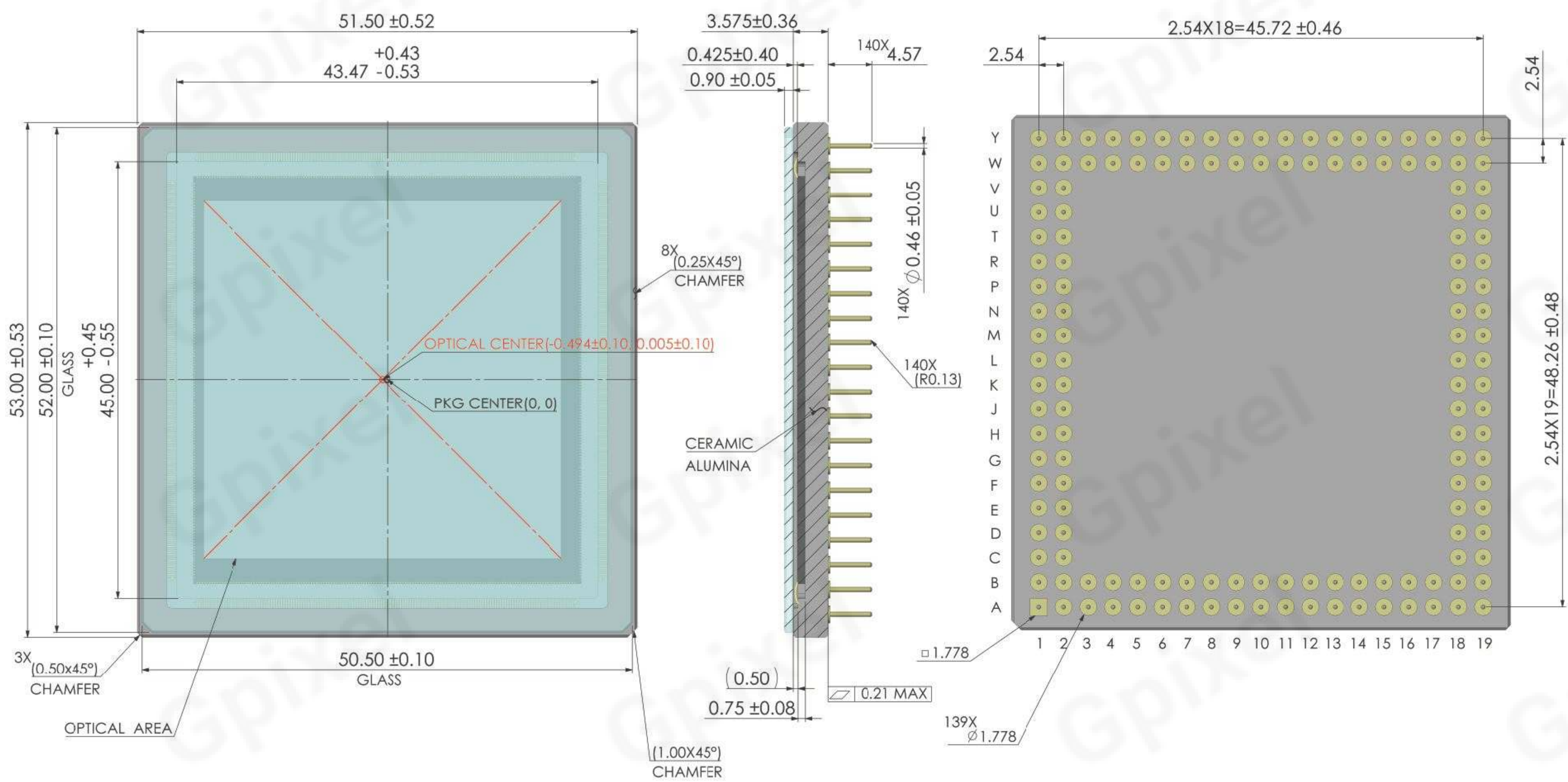
· 片上温度传感器、SPI控制、PLL

应用领域

医疗成像、天文成像、X射线成像

产品指标			
有效分辨率	4096(H) x 4096(V)	光学尺寸	3.3"
像素尺寸	9 μm x 9 μm	感光面积	36.864 mm x 36.864 mm
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	90% (600 nm)
满阱容量	39.2 ke ⁻	读出噪声	2.3 e ⁻
暗电流	0.04 e ⁻ /pixel/s (-40 °C)	动态范围	84.6 dB
最高帧频	24 fps	输出接口	18对LVDS
最大数据率	10.8 Gbps	ADC	12 bit
色彩	黑白	功耗	<1.4 W
供电电压	3.3 V(模拟)、1.8 V(数字)	封装信息	140 pins PGA、51.5 mm x 53 mm

封装图示



GSENSE6060

37MP 科学级 CMOS图像传感器



GSENSE6060是一款3700万像素分辨率、大靶面、科学级CMOS图像传感器。该芯片采用10 μm像素尺寸、像素矩阵可进行双面读出，最高帧频为44 fps。GSENSE6060采用CMS技术，其读出噪声仅为4.1 e⁻,在HDR模式下动态范围高达89 dB。GSENSE6060采用氮化铝(ALN)PGA 陶瓷封装，其导热系数是传统氧化铝陶瓷封装的10倍，在深度制冷时也可保证感光面的平整度。

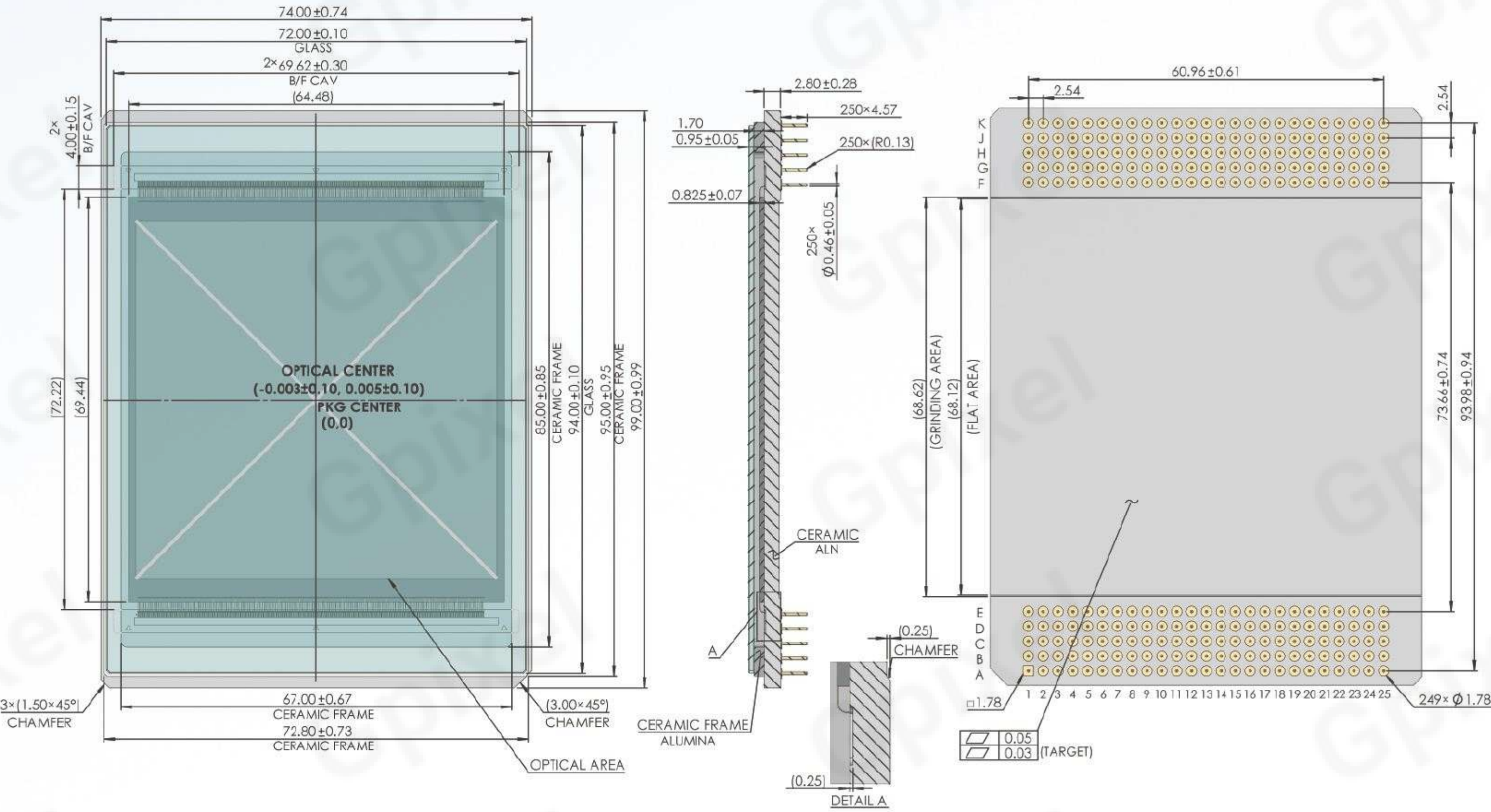
产品特性

- 大靶面
- 峰值量子效率:71.5%
- 动态范围:89 dB
- 片上12/14 bit ADC
- 片上温度传感器、SPI控制
- ALN封装

应用领域

医疗成像、天文成像、高端科学成像、X射线成像

产品指标			
有效分辨率	6144(H) x 6144(V)	光学尺寸	5.4"
像素尺寸	10 μm x 10 μm	感光面积	61.44 mm x 61.44 mm
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	71.5% (550 nm)
满阱容量	133 ke ⁻	读出噪声	4.1 e ⁻
暗电流	0.01 e ⁻ /pixel/s (-70°C)	动态范围	89 dB (12 bit,HDR)
最高帧频	44 fps (12 bit,STD)	输出接口	50对LVDS
最大数据率	31.5 Gbps	ADC	12/14 bit
色彩	黑白	功耗	5 W
供电电压	5 V(模拟)、1.85 V(数字)	封装信息	250 pins PGA、74 mm x 99 mm

封装图示			
			

GSENSE6060BSI

37MP 科学级 背照式CMOS图像传感器



GSENSE6060BSI是一款3700万像素分辨率、大靶面、科学级、背照式CMOS图像传感器。该芯片采用10 μm像素尺寸、像素矩阵可进行双面读出，最高帧频为26 fps。芯片采用背照式加工工艺，其峰值量子效率高达95%,且感光谱段可拓展X光和紫外谱段。芯片在HG模式下读出噪声仅为3 e⁻,在HDR模式下动态范围高达90 dB。芯片采用氮化铝(ALN)PGA 陶瓷封装，其导热系数是传统氧化铝陶瓷封装的10倍，在深度制冷时也可保证感光面的平整度。

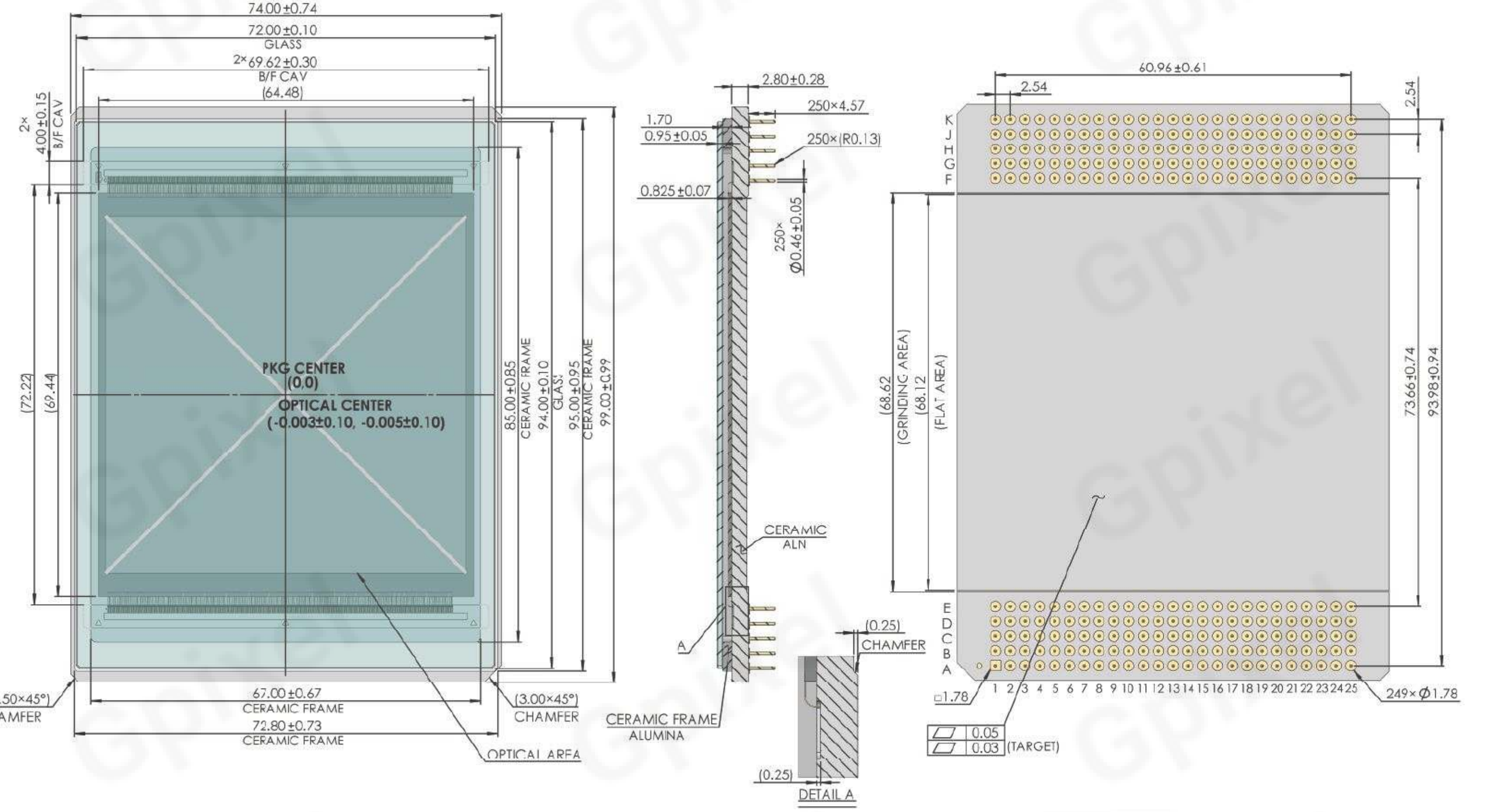
产品特性

- 大靶面
- 峰值量子效率:95%
- 动态范围:90 dB
- 片上12/14 bit ADC
- 片上温度传感器、SPI控制
- ALN封装

应用领域

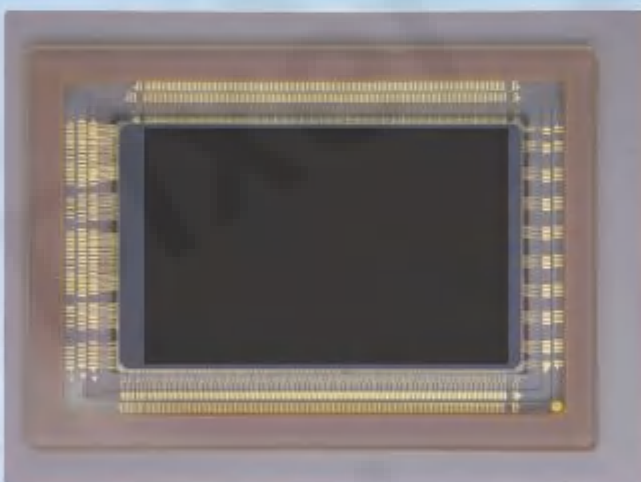
医疗成像、天文成像、高端科学成像、X射线成像

产品指标			
有效分辨率	6144(H) x 6144(V)	光学尺寸	5.4"
像素尺寸	10 μm x 10 μm	感光面积	61.44 mm x 61.44 mm
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	95% (580 nm)
满阱容量	95 ke ⁻	读出噪声	3 e ⁻ (HG)
暗电流	0.04 e ⁻ /pixel/s (-40°C)	动态范围	90 dB (12 bit,HDR)
最高帧频	26 fps (12 bit,STD)	输出接口	50对LVDS
最大数据率	21 Gbps	ADC	12/14 bit
色彩	黑白	功耗	< 4 W
供电电压	5 V(模拟)、1.85 V(数字)	封装信息	250 pins PGA、74 mm x 99 mm

封装图示			
			

GSENSE3243BSI

43MP 科学级 背照式CMOS图像传感器



GSENSE3243BSI是一款APS-C画幅、4300万像素分辨率的背照式堆栈的sCMOS图像传感器，是GSENSE产品系列中首个基于先进的65 nm堆栈工艺技术的sCMOS图像传感器。芯片底层读出电路采用了全帧存储模块设计，支持在顶层像素一次曝光下多次读出、采样、片上存储和求和运算。在4次像素读出模式下的满阱容量为85 ke⁻，通过2 x 2binning最高可实现192 ke⁻的满阱容量。GSENSE3243BSI继承了第一代GSENSE产品中广泛使用的双增益HDR模式，其动态范围可达83 dB。另外芯片还支持片上压缩HDR模式以及多斜率HDR模式，动态范围可进一步提升至104 dB，以满足更高的成像要求。得益于先进的背照式工艺，GSENSE3243BSI具有超过80%的峰值量子效率和良好的角度响应。芯片暗电流小于1 e⁻/pixel/s(0℃)，在长曝光条件下，可获得比传统sCMOS更加优质的成像效果。基于以上优异性能的加持，GSENSE3243BSI为生物显微、科学仪器等领域提供了全新的解决方案。

- 产品特性
- 堆栈、背照式

· 高灵敏度

· 高动态范围
- 低噪声

· 双增益HDR

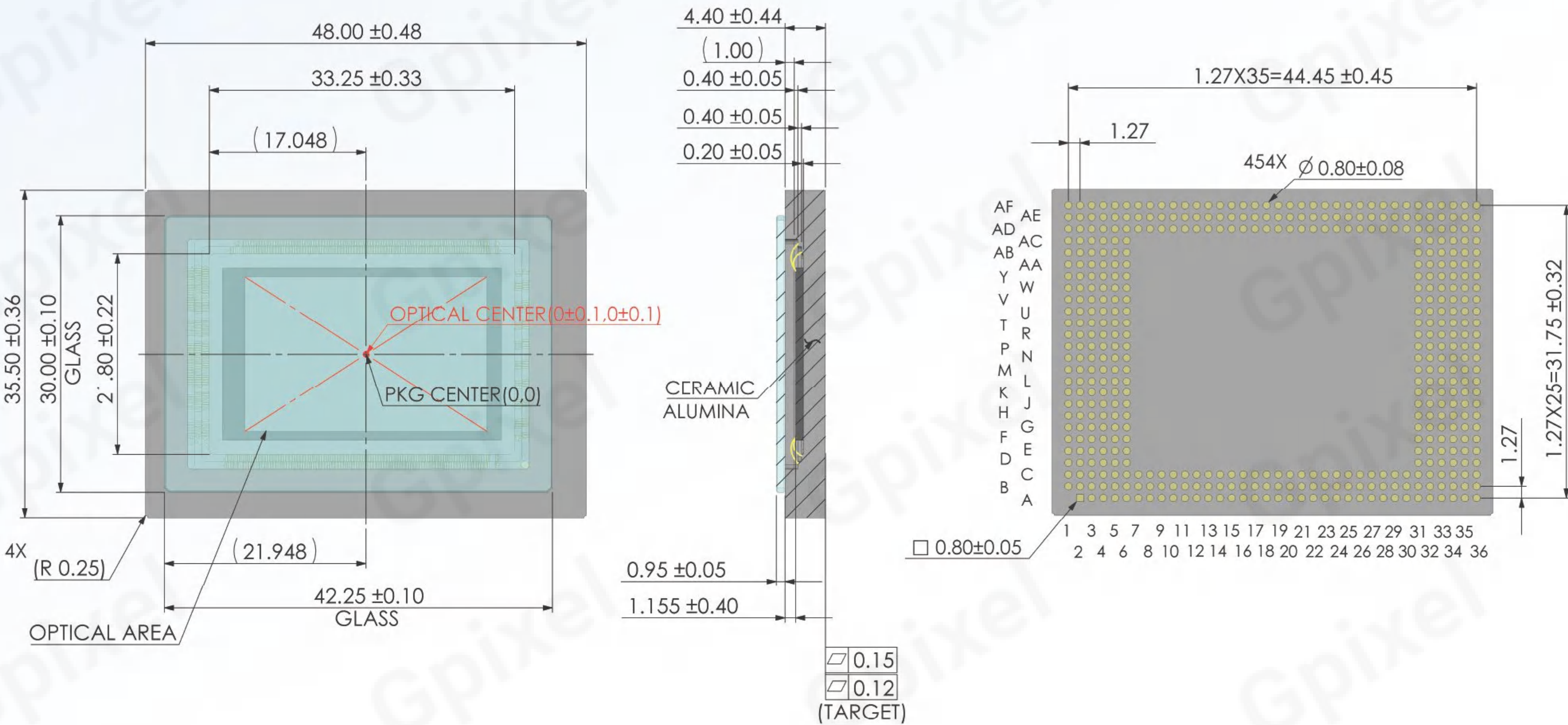
· 多斜率HDR

应用领域

光谱成像、生命科学、天文成像、显微成像

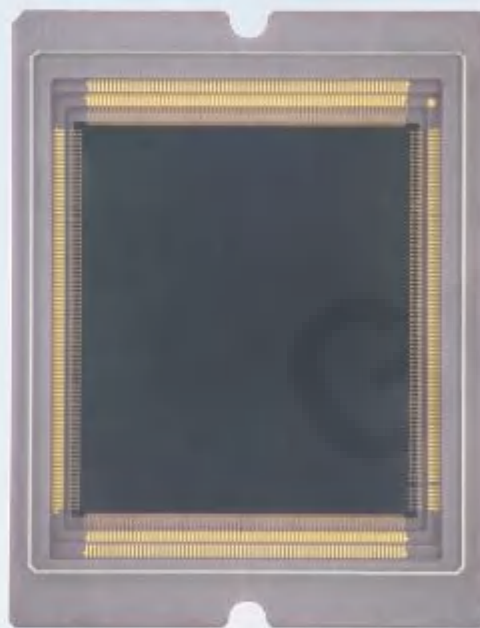
产品指标			
有效分辨率	8192 (H) x 5232 (V)	光学尺寸	APS-C
像素尺寸	3.2 μm × 3.2 μm	感光面积	26.2 mm (H) x 16.7 mm (V)
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	80% (550 nm, 黑白)
满阱容量	85 ke ⁻ (HDR multi-exp)	读出噪声	2.0 e ⁻ (Standard HG)、2.7 e ⁻ (HDR)
暗电流	7.8 e ⁻ /pixel/s (40 °C)	动态范围	83 dB (HDR multi-exp)
最高帧频	100 fps	输出接口	32对LVDS、16对GSI
最大数据率	84 Gbps	ADC	14 bit
色彩	黑白	功耗	2-4 W
供电电压	3.3 V、1.8 V、1.25 V、-2.2 V、4.5 V	封装信息	455 pins PGA、48 mm x 35.5 mm

封装图示



GSENSE6510BSI

10.2MP 科学级 CMOS图像传感器



GSENSE6510BSI是一款1000万像素分辨率的科学级背照式CMOS图像传感器，像素尺寸为6.5 μm x 6.5 μm，具有29.4 mm的超大对角线视角，可显著提高成像设备的通量，最大限度的提升单帧捕获的数据信息。得益于先进的背照式工艺，GSENSE6510BSI的峰值量子效率可达95% (610 nm)，在800 nm时，量子效率超过67%。GSENSE6510BSI支持相关多采样 (CMS) 技术，在12 bit STD 16-CMS模式下可实现0.7 e⁻的亚电子噪声，在极低光照条件下可实现卓越的信噪比。GSENSE6510BSI支持全局复位卷帘曝光，并支持用于长曝光时间的低暗电流模式。GSENSE6510BSI提供五种操作模式。在8 bit STD模式下，芯片通过72对LVDS全速输出，可实现500 fps的最高帧率以及69.12 Gbps的最大数据率，通过开窗功能，可实现更高帧率。

- 产品特性
- 背照式

· 高灵敏度

· 光学尺寸1.83"
- 峰值量子效率95%

· 500 fps (8 bit)

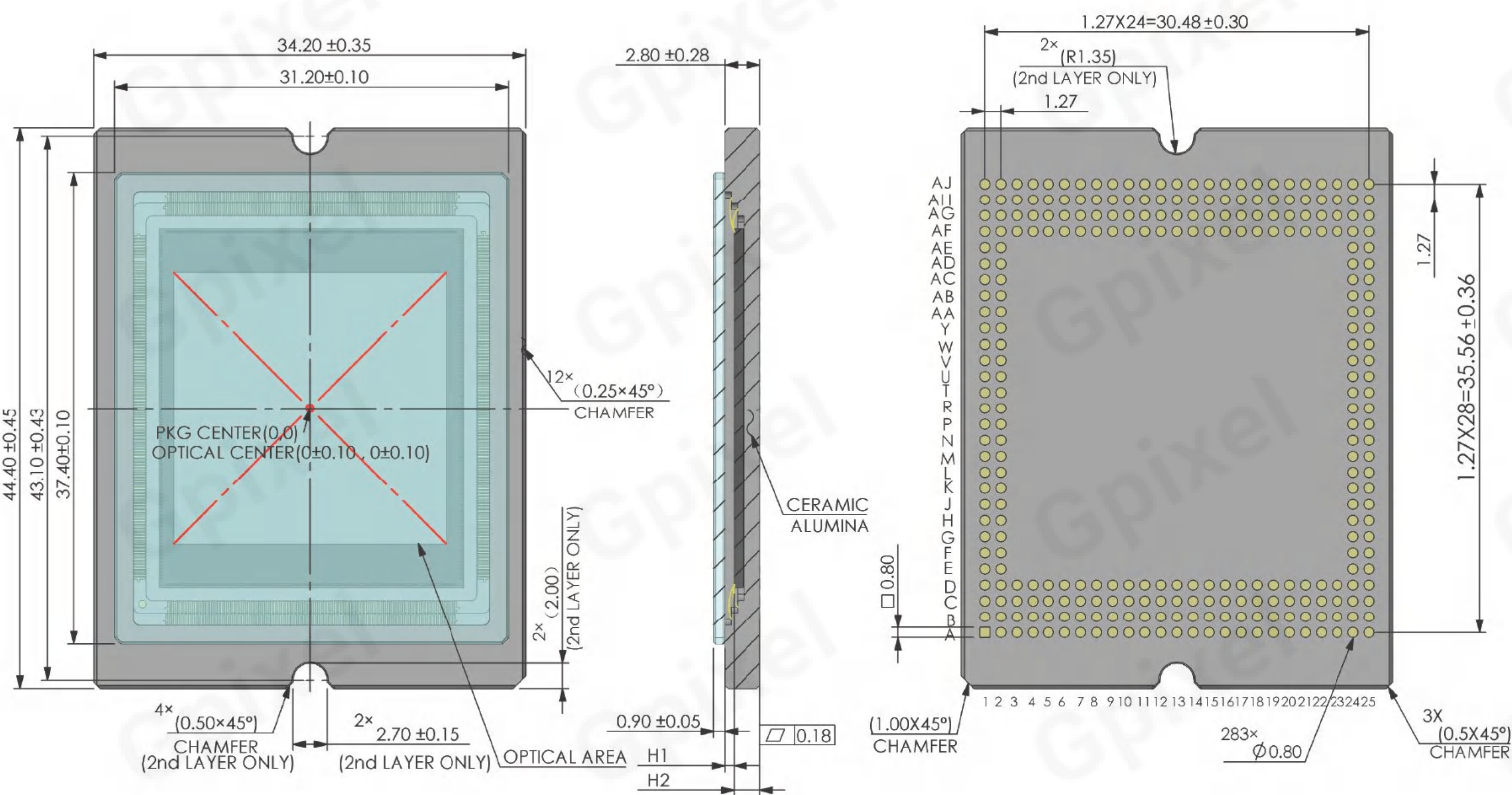
· 读出噪声0.7 e⁻ (12 bit, 16 x CMS)

应用领域

生命科学、显微成像

产品指标			
有效分辨率	3200 (H) x 3200 (V)	光学尺寸	1.9"
像素尺寸	6.5 μm x 6.5 μm	感光面积	20.8 mm x 20.8 mm
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	95% (610 nm)
满阱容量	21 ke ⁻	读出噪声	0.7 e ⁻ (12 bit, 16 x CMS)
暗电流	0.2 e ⁻ /pixel/s (-10℃)	动态范围	78.8 dB (11 bit HDR)
最高帧频	500 fps (8 bit)	输出接口	72对LVDS
最大数据率	69.12 Gbps (8 bit)	ADC	8/11/12 bit
色彩	黑白	功耗	<5 W (8 bit)、<2.7 W (12 bit)
供电电压	3.6 V(模拟)、2.0 V(数字)	封装信息	284 pins LGA、44.4 mm x 34.2 mm

封装图示



GSENSE1081BSI

81MP 科学级 背照式CMOS图像传感器



GSENSE1081BSI是针对天文成像而设计的一款8100万像素分辨率、超大靶面科学级、背照式CMOS图像传感器。芯片具备大于97%的峰值量子效率、84.5 dB的单幅动态范围。GSENSE1081BSI针对暗电流指标进行了优化,暗电流仅为0.00373 e⁻/pixel/s (-70°C)。同时采用了anti-glowing技术,在极端的温度条件下,超长曝光时间也可有效消除辉光现象。GSENSE1081BSI采用了表面平整度较高的碳化封装基底,使得芯片深度制冷至-50°C以下,也可保持极高的平整度。针对天文测光的特殊需求,GSENSE1081BSI在像素设计中采用针对性优化,降低了该芯片的像素内响应不均匀性。GSENSE1081BSI采用三面可拼接的碳化硅基底封装设计,通过柔性线缆进行片上数据传输,更适合大视场、多芯片拼接应用。

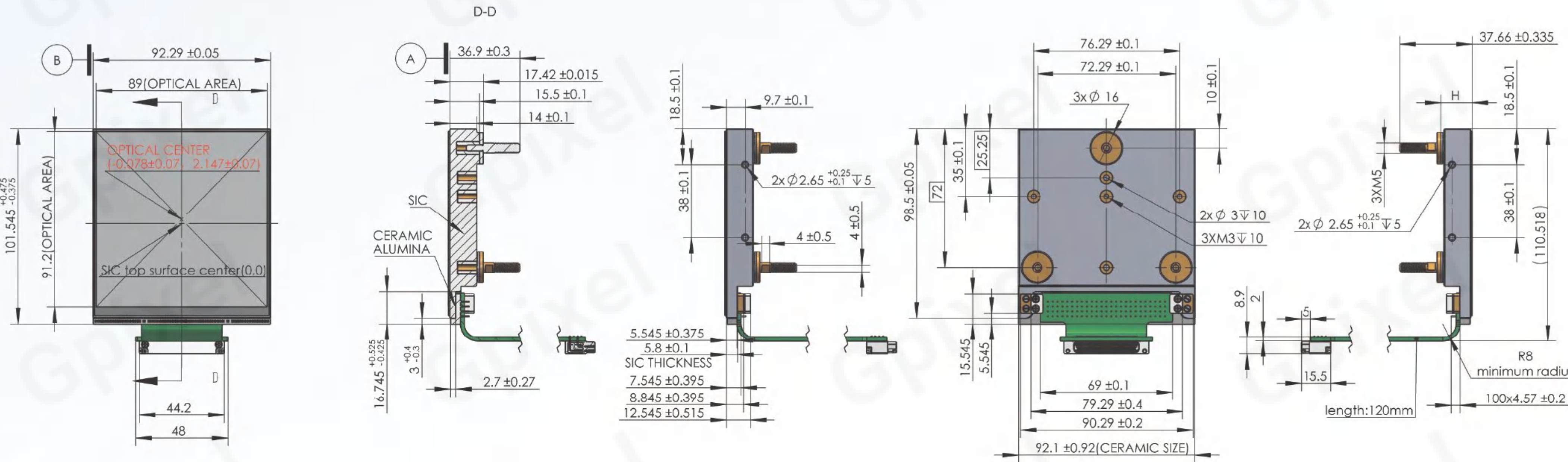
产品特性

- 峰值量子效率:97.11% (610nm)
- 抗辉光效应
- 暗电流 : 0.00373 e⁻/pixel/s (-70°C)
- 16 bit ADC
- 3面可拼接碳化硅柔性带封装

应用领域

天文成像

产品指标			
有效分辨率	8900(H) x 9120(V)	光学尺寸	7.96"
像素尺寸	10 μm x 10 μm	感光面积	89.00 mm x 91.20 mm
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	97.11% (610 nm)
满阱容量	90.68 ke ⁻	读出噪声	5.35 e ⁻
暗电流	0.00373 e ⁻ /pixel/s (-70°C)	动态范围	84.5 dB
最高帧频	0.34 fps (16 bit)、0.94 fps (15 bit)	输出接口	5对LVDS
最大数据率	500 Mbps (16 bit)、1.6 Gbps (15 bit)	ADC	15/16 bit
色彩	黑白	功耗	1.4 W
供电电压	5 V(模拟)、1.8 V(数字)	封装信息	100 pins 碳化硅封装、92.3 mm x 98.4 mm
封装图示			



GSENSE1517BSI

16.8 MP 科学级 背照式CMOS图像传感器



GSENSE1517BSI是针对天文成像而设计的一款1680万像素分辨率、超大靶面科学级、背照式CMOS图像传感器。采用15 μm大像素设计,具有高灵敏度和高动态范围的特性,峰值量子效率可以达到92%。芯片片上集成16 bit ADC,单幅动态范围可以达到81.5 dB,同时支持12 bit HDR模式,读出噪声可以达到1.2 e⁻,可以实现95.3 dB的动态范围。GSENSE1517BSI采用了anti-glowing技术,在极端的温度条件下,超长曝光时间也可有效消除辉光现象。芯片采用LVDS高速读出方式,最高帧频可以达到4 fps。GSENSE1517BSI采用了表面平整度较高的碳化硅封装基底,使得芯片深度制冷至-70°C,也可保持极高的平整度。GSENSE1517BSI采用三面可拼接的碳化硅基底封装设计,更适合大视场、多芯片拼接应用。

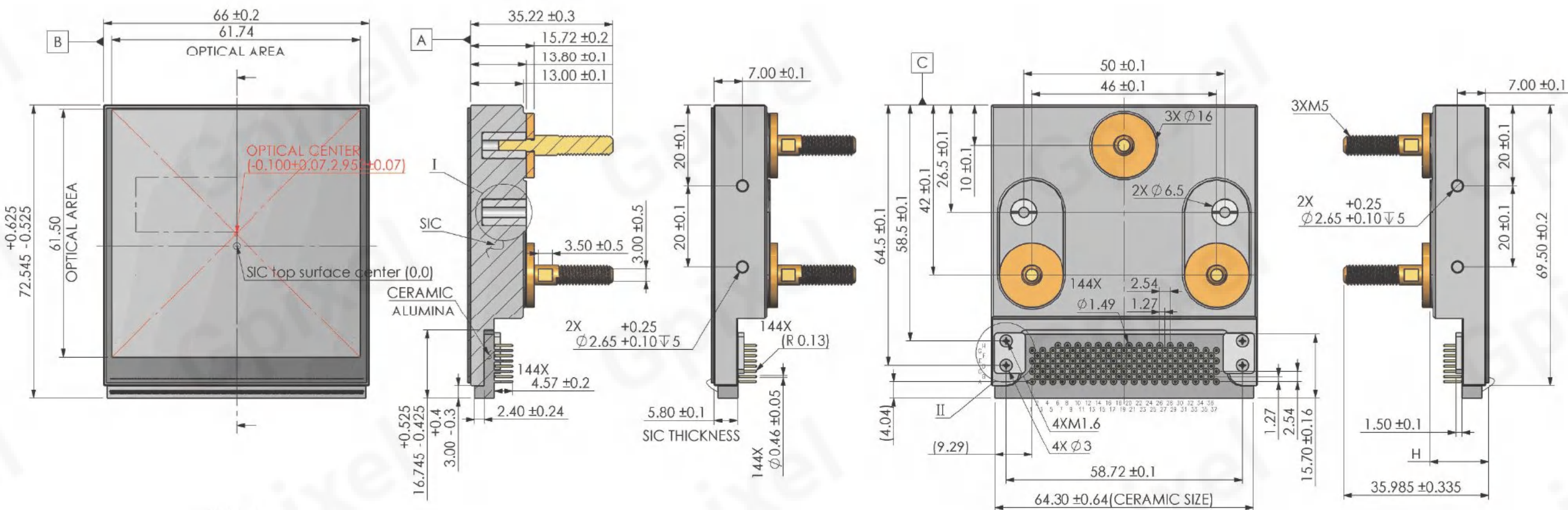
产品特性

- 峰值量子效率:92% (450 nm)
- 读出噪声:1.2 e⁻
- 原生16 bit ADC
- 暗电流:< 0.008 e⁻/pixel/s (-70°C)
- 抗辉光效应
- 3面可拼接碳化硅封装
- 最高帧频:4 fps

应用领域

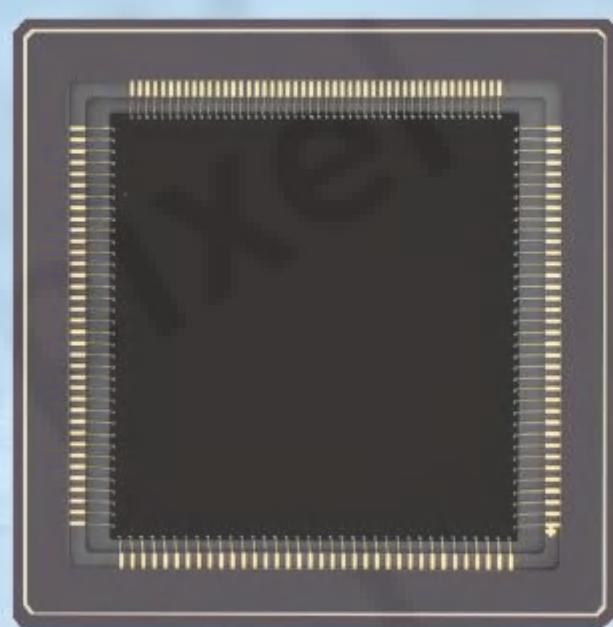
天文成像、空间态势感知 (SSA)、物理科学研究

产品指标			
有效分辨率	4116 (H) x 4100 (V)	感光面积	61.74 mm x 61.50 mm
像素尺寸	15 μm x 15 μm	暗电流	< 0.008 e ⁻ /pixel/s (-70 °C)
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	92% (450 nm)
动态范围	95.3 dB (12 bit, HDR)、76.1 dB (14 bit, LG) 79.6 dB (14 bit, HG)、81.5 dB (16 bit, LG)	读出噪声	1.2 e ⁻ (12 bit, HDR)、10.9 e ⁻ (14 bit, LG) 1.5 e ⁻ (14 bit, HG)、5.8 e ⁻ (16 bit LG)
满阱容量	70 ke ⁻ (12 bit HDR ,14 bit & 16 bit LG)、14.4 ke ⁻ (14 bit, HG)	ADC	16 bit
最高帧频	4 fps (12 bit, HDR &14 bit)、1.1 fps (16 bit)	输出接口	10对LVDS
最大数据率	4.2 Gbps	功耗	<1 W
色彩	黑白	操作温度	-70°C ~ 50°C
供电电压	3.3 V(模拟)、1.55 V(数字)、1.8 V(IO)	封装信息	碳化硅基底144 pins Al ₂ O ₃ IPGA陶瓷封装 (66.2 mm x 72.545 mm)
封装图示			



GSENSE400BSI

4MP 科学级 背照式CMOS图像传感器



GSENSE400BSI是世界上首款科学级、背照式CMOS图像传感器，具备400万像素分辨率及2"光学尺寸。芯片采用4T像素结构、11 μm像素尺寸，具有1.6 e⁻的读出噪声、暗电流仅为0.27 e⁻/pixel/s (-40°C)。由于采用不同的抗反射镀膜技术和衬底厚度，GSENSE400BSI峰值量子效率为95% (570 nm)。GSENSE400BSI分为标准模式(STD)和高动态模式(HDR)，在标准模式下最高帧频为48 fps，在高动态模式下的动态范围可达94 dB。芯片采用了高可靠性的PGA封装，具有良好的散热和抗冲击能力。

产品特性

- 像素尺寸: 11 μm

· 高帧频: 48 fps (STD)

· 动态范围: 94 dB
- 暗电流: 0.27 e⁻/pixel/s (-40°C)

· 读出噪声: 1.6 e⁻

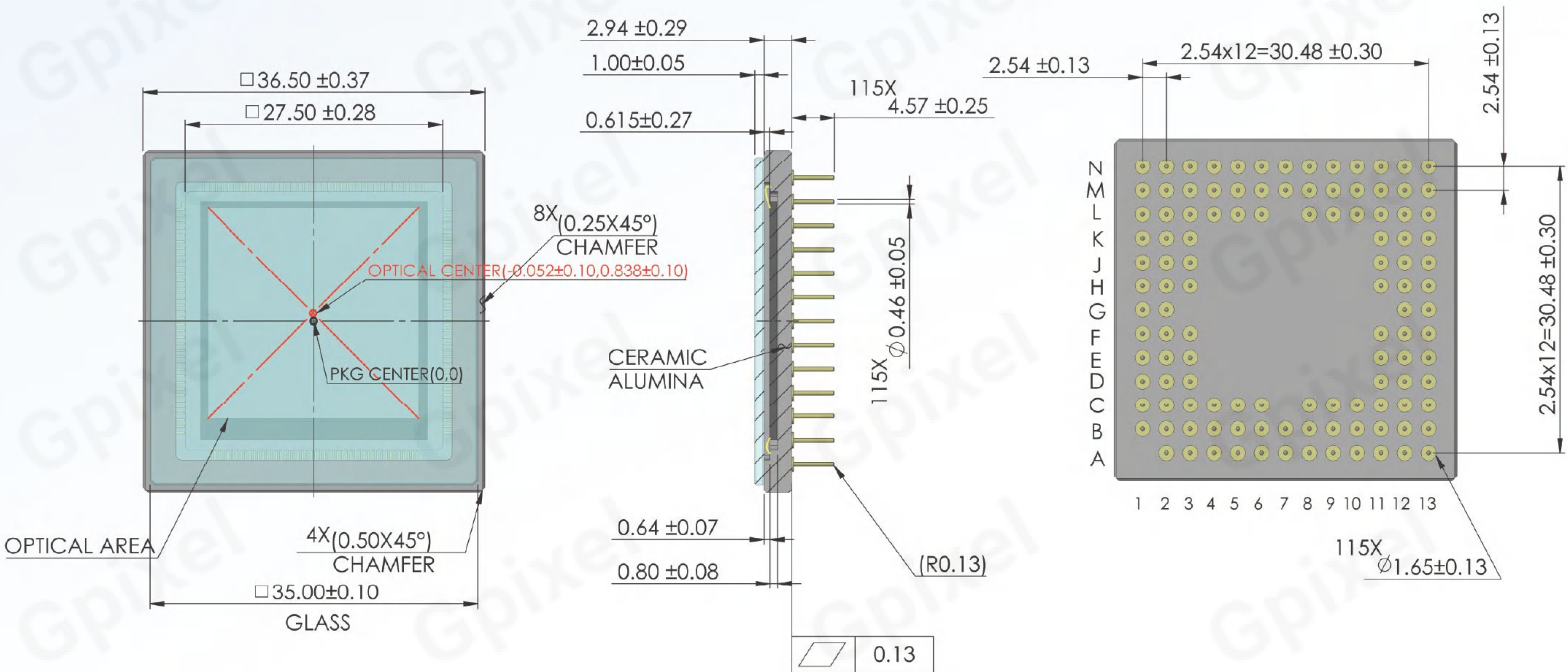
· 高灵敏度
- 功耗 < 650 mW

应用领域

生命科学、显微成像、医疗成像、光谱成像、UV工业检测

产品指标			
有效分辨率	2048(H) x 2048(V)	光学尺寸	2.0"
像素尺寸	11 μm x 11 μm	感光面积	22.52 mm x 22.52 mm
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	95% (570 nm)
满阱容量	91 ke ⁻	读出噪声	1.6 e ⁻
暗电流	0.27 e ⁻ /pixel/s (-40°C)	动态范围	95 dB (HDR)
最高帧频	48 fps (STD)	输出接口	8对LVDS
最大数据率	2.4 Gbps	ADC	12 bit
色彩	黑白	功耗	<650 mW
供电电压	3.3 V(模拟)、1.8 V(数字)	封装信息	115 pins PGA、36.5 mm x 36.5 mm

封装图示





GMAX
GSPRINT
GSENSE
GLUX
GTOF
GCINE
GL
GXS
GIR

面阵CMOS图像传感器

GLUX系列

GLUX系列是长光辰芯推出的背照式sCMOS图像传感器, 该系列产品具备低读出噪声、高灵敏度、高帧频等特性, 主要适用于高端微光监控、科学成像等领域。

GLUX9701BSI

GLUX1605BSI

GLUX系列特点

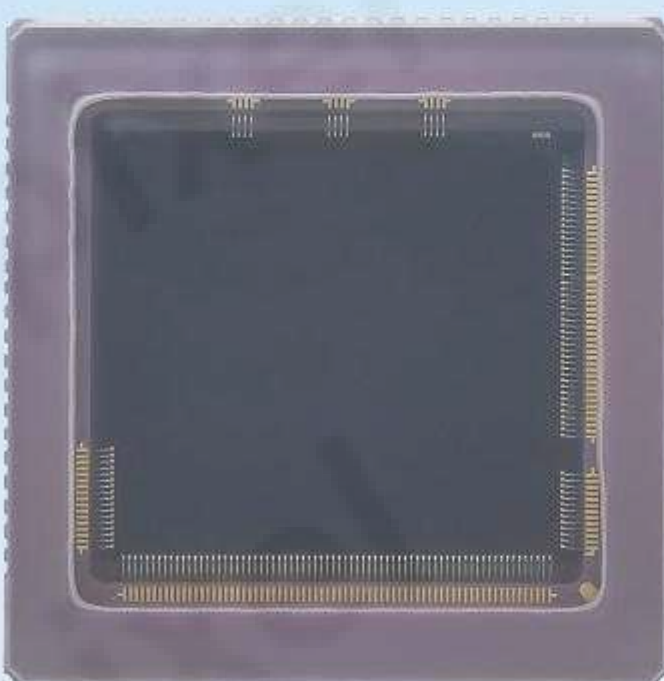
大像素尺寸	亚电子噪声	低功耗
背照式	高灵敏度	

主要应用

高端微光监控、科学成像



GLUX9701BSI1.3MP 背照式 CMOS图像传感器



GLUX9701BSI是一款130万像素分辨率、1"光学尺寸的后照式CMOS图像传感器。该芯片具备超低读出噪声、高灵敏度等特性，结合先进的背照式工艺，使得该产品在星光环境(<10⁻³ lux)下也具备清晰成像的能力。GLUX9701BSI支持双增益HDR和低噪声两种工作模式。在HDR模式下可获得89.5 dB的动态范围。在低噪声模式下读出噪声仅为0.85 e⁻，且功耗仅为160 mW。芯片集成MIPI和Sub-LVDS两种输出接口，可根据实际应用需求选择ISP或FPGA等后端处理芯片。

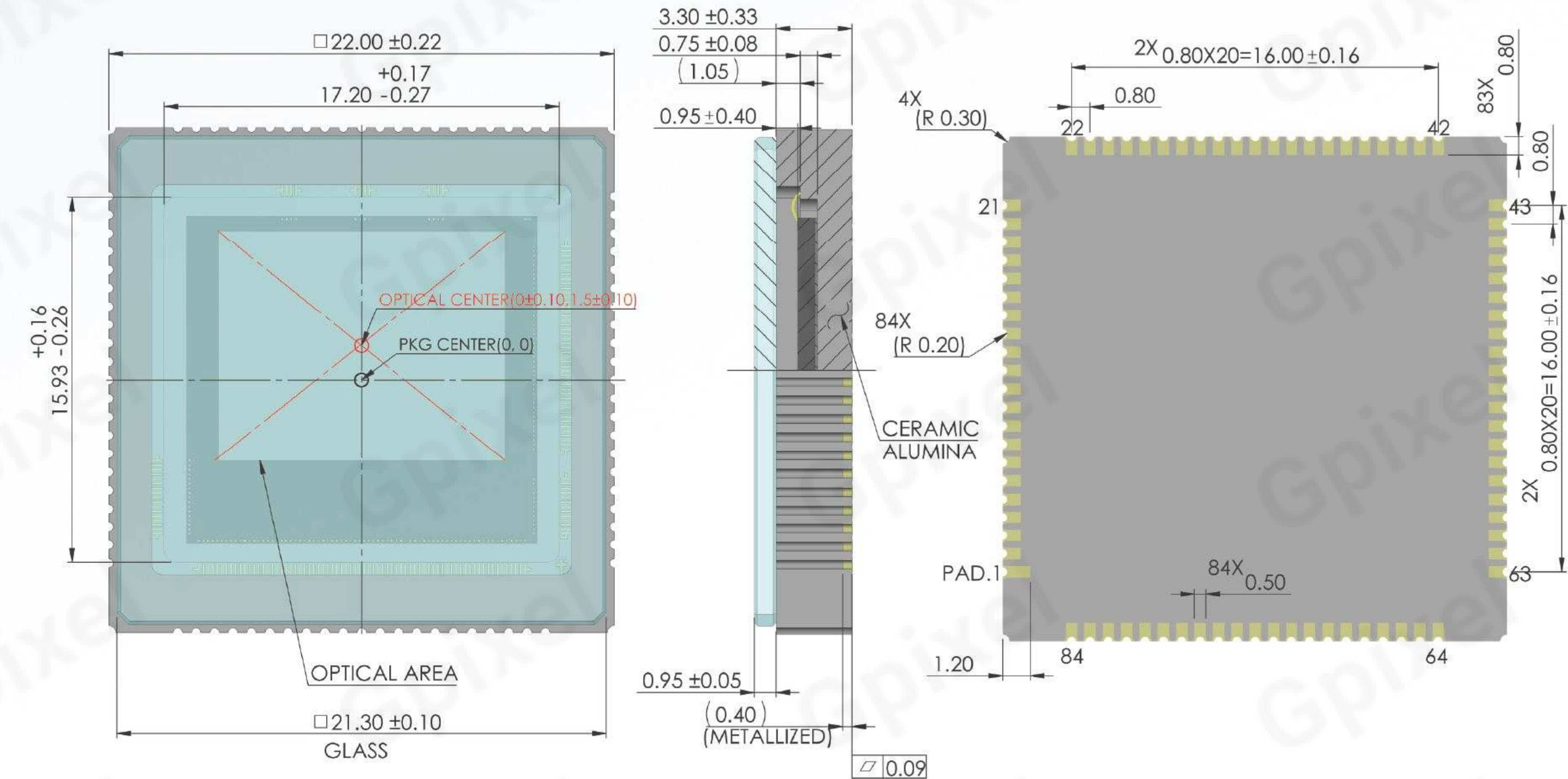
产品特性

- HDR和低噪声模式
- 高灵敏度
- MIPI、Sub-LVDS接口
- 读出噪声0.85 e⁻
- 低功耗

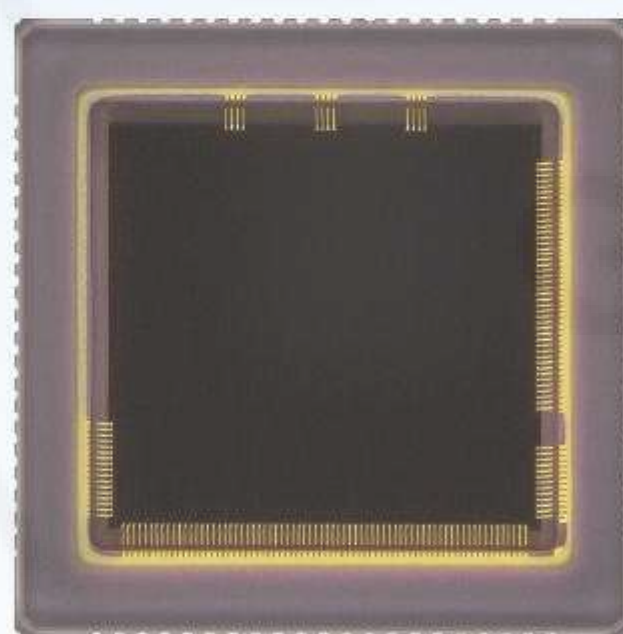
应用领域

高端微光监控、科学成像、UV工业检测

产品指标			
有效分辨率	1280(H) x 1024(V)	光学尺寸	1"
像素尺寸	9.76 μm x 9.76 μm	感光面积	12.493 mm x 9.994 mm
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	89% (610 nm)
满阱容量	48 ke ⁻	暗电流	0.08 e ⁻ /pixel/s (-28°C)
读出噪声	1.6 e ⁻ (HDR)、0.85 e ⁻ (低噪声)	最高帧频	30 fps
动态范围	89.5 dB (HDR)	最大数据率	1.782 Gbps
输出接口	4对Sub-LVDS、4 lanes MIPI	ADC	12 bit
色彩	黑白	功耗	250 mW (HDR)、122 mW (低噪声)
供电电压	3.3 V(模拟)、1.8 V(数字)	封装信息	84 pins CLCC、22 mm x 22 mm
封装图示			



GLUX1605BSI0.5MP 背照式 CMOS图像传感器



GLUX1605BSI是一款SVGA分辨率(800*600)、1"光学尺寸的后照式CMOS图像传感器。凭借16 μm的大像素设计、亚电子级别的读出噪声以及高达90%的量子效率，使其具备优异的微光探测能力。GLUX1605BSI支持双增益HDR和低噪声工作模式。在HDR模式下的最高帧率为60 fps，动态范围高达93 dB。在低噪声模式下最高帧率为25 fps，读出噪声仅为0.9 e⁻，功耗83 mW。GLUX1605BSI采用4对Sub-LVDS和MIPI接口兼容设计，且与GLUX9701BSI管脚兼容。

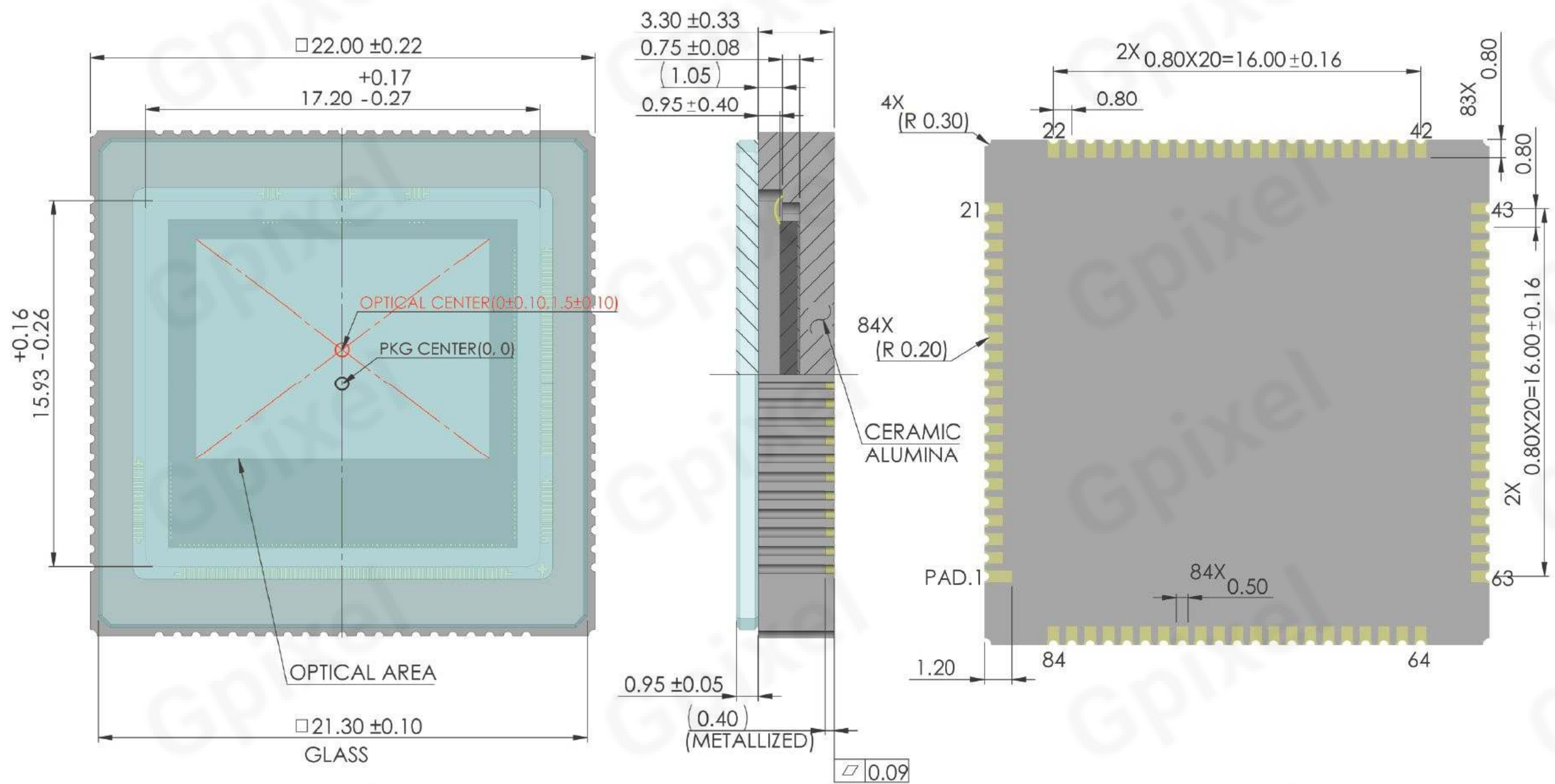
产品特性

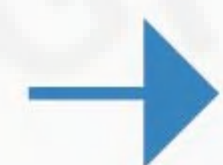
- 像素尺寸:16 μm
- 低功耗
- HDR和低噪声模式
- 高灵敏度
- MIPI、Sub-LVDS接口
- 读出噪声0.9 e⁻

应用领域

高端微光监控、科学成像、UV工业检测

产品指标			
有效分辨率	800(H) x 600(V)	光学尺寸	1"
像素尺寸	16 μm x 16 μm	感光面积	12.8 mm x 9.6 mm
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	90.7% (550 nm)
满阱容量	73.4 ke ⁻	暗电流	0.22 e ⁻ /pixel/s (-33°C)
读出噪声	0.9 e ⁻ (低噪声)	最高帧频	60 fps
动态范围	93 dB (HDR)	最大数据率	1.782 Gbps
输出接口	4对Sub-LVDS、4 lanes MIPI	ADC	12 bit
色彩	黑白	功耗	201 mW (HDR)、83 mW (低噪声)
供电电压	3.3 V(模拟)、1.75 V(数字)	封装信息	84 pins CLCC、22 mm x 22 mm
封装图示			





GMAX
GSPRINT
GSENSE
GLUX
GTOF
GCINE
GL
GXS
GIR

面阵CMOS图像传感器

GTOF系列

GTOF系列产品是长光辰芯推出的iToF图像传感器系列, 采用先进的堆栈、背照式技术, 面向高精度的深度测量及测距等应用领域。

GTOF0503

GTOF系列特点

- | | |
|-------|-------|
| 堆栈背照式 | 高测量精度 |
| 高灵敏度 | 双频模式 |

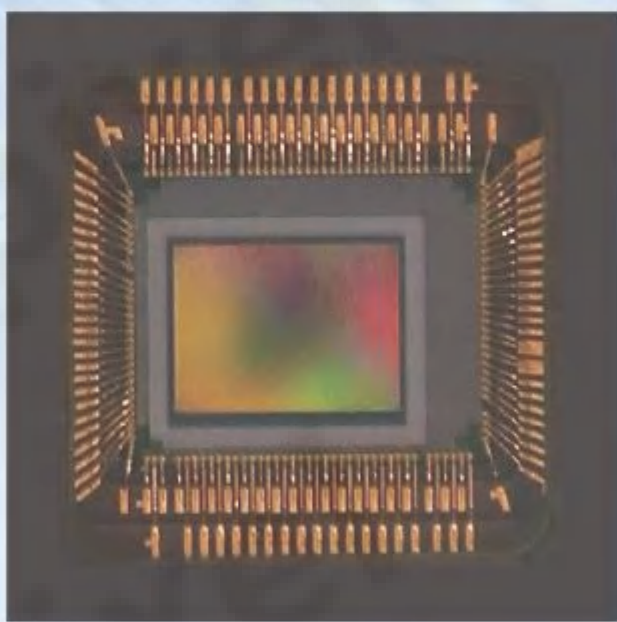
主要应用

视觉引导机器人、无序抓取、工业自动化、物流、安全监控、3D测量



GTOF0503

VGA iTOF CMOS图像传感器



GTOF0503是面向3D成像而设计的分辨率为640 x 480(VGA)、1/4"的3-tap iTOF图像传感器。芯片采用先进的65 nm像素级堆栈、背照式工艺,使其具备极高的测量精度和灵敏度。通过脉冲调制itof技术,在短距离、中远距离和远距离测量中均具有较高的测量精度,即使在复杂环境光条件下,也可以进行精准的深度测量。GTOF0503的调制频率为3 ns脉宽,其解调对比度>80%,同时在单调制频率(SMF)下帧率为60 fps,在双调制频率(DMF)下为30 fps。GTOF0503片上集成了多种功能,包括光源控制、2 x 2/4 x 4像素合并、水平/垂直翻转,多窗口、单/双频率调制模式、低功耗待机模式。GTOF0503封装版本采用了高可靠性,且尺寸紧凑的陶瓷封装,同时提供裸硅片销售选项。

产品特性

- 3-tap iToF全局快门像素

· 高测量精度和灵敏度

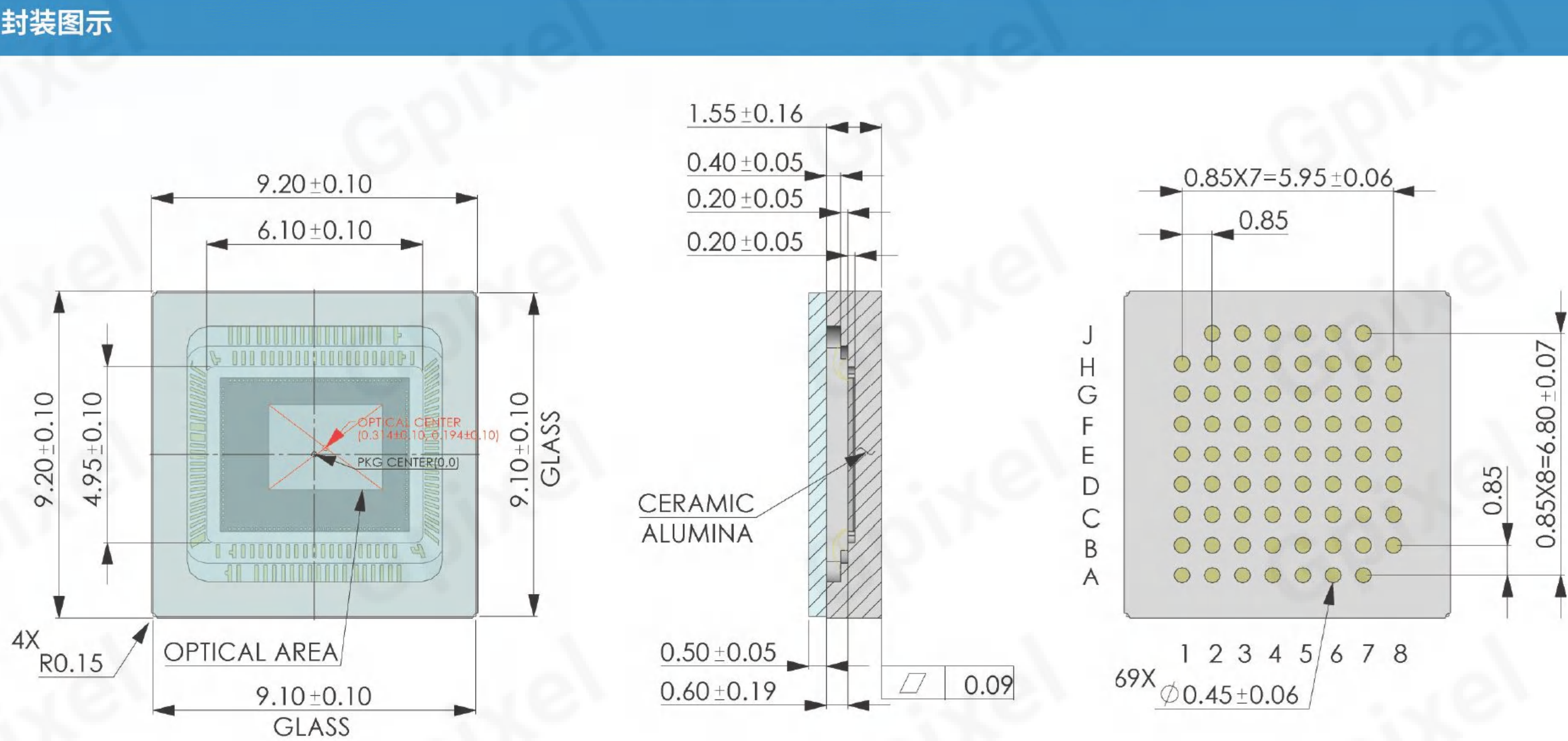
· 高NIR响应
- MIPI CSI-2接口

· 解调对比度>80%

应用领域

视觉引导机器人、无序抓取、工业自动化、物流、安全监控、3D测量

产品指标			
有效分辨率	640(H) x 480(V)	光学尺寸	1/4"
像素尺寸	5 μm x 5 μm	感光面积	3.2 mm x 2.4 mm
快门类型	3-tap iToF 全局快门	峰值量子效率	31.5% (850 nm)、13.8% (940 nm)
满阱容量	9 ke ⁻	ADC位数	11 bit
读出噪声	8.2 e ⁻	解调对比度	>80% (3 ns)
动态范围	60.8 dB	最高帧频	60 fps
输出接口	4 lanes CSI-2 MIPI	图像开窗	垂直方向4个、水平方向1个
色彩	黑白	功耗	<1.2 W
供电电压	2.8 V、1.8 V、1.2 V、1.3 V	封装信息	139 pads (Die)、69 pins LGA、9.2 mm x 9.2 mm



	GMAX
	GSPRINT
	GSENSE
	GLUX
	GTOF
→	GCINE
	GL
	GXS
	GIR

面阵CMOS图像传感器

GCINE系列

GCINE系列是长光辰芯面向专业影像、广电领域而推出的图像传感器系列,产品采用背照式、堆栈技术,具备高分辨率、高帧频、高灵敏度、高动态范围等优异特性。产品可满足8K广播电视、专业摄影、无人机、高端8K视频成像等诸多行业的需求。

GCINE3243

GCINE4349

GCINE系列特点

背照式、堆栈 高灵敏度 低噪声 HDR

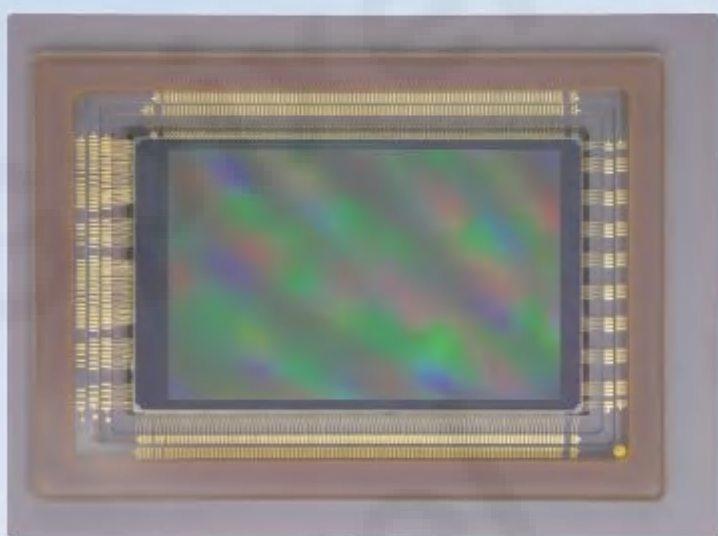
主要应用

专业影像



GCINE3243

8K APS-C画幅背照式堆栈CMOS图像传感器



GCINE3243是一款APS-C画幅、8K制式、4300万像素分辨率的背照式堆栈CMOS图像传感器。具备高灵敏度、高动态范围、高帧率、低噪声等特性,可应用于专业影像,科学仪器,工业检测等行业。GCINE3243采用了先进的混合堆栈背照式(hybrid stacking BSI)工艺,在保证量子效率前提下实现了8K超高分辨率下更快的读出速度。GCINE3243采用32对LVDS通道进行数据传输,其总数据率为33.6 Gbps。在8K模式下,可实现60 fps (14 bit) 的超高清视频拍摄。在4K模式下,通过片上2 x 2像素合并,实现4K 120 fps (14 bit) 的超高清视频拍摄。配合开窗等功能,芯片还支持6K M43, 4K Supper 16等画面尺寸的输出。GCINE3243支持多种高动态范围输出模式,包括双增益HDR模式,片上压缩HDR模式以及多斜率HDR模式等。得益于HDR技术的加持,使得该芯片的最高动态范围达到81 dB。

产品特性

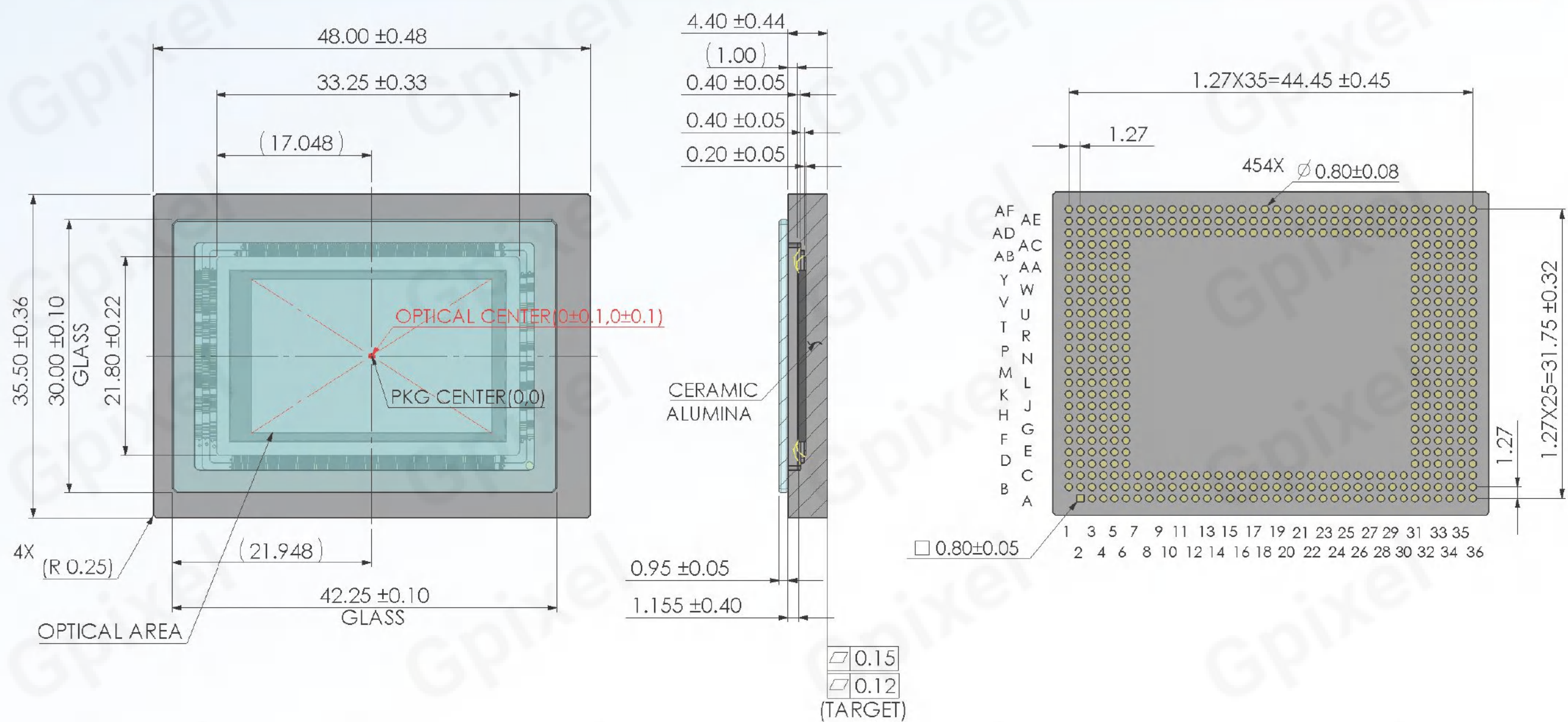
- 堆栈、背照式
- APS-C
- 8K超高清
- 双增益HDR
- 多斜率HDR
- 高动态、低噪声

应用领域

专业影像

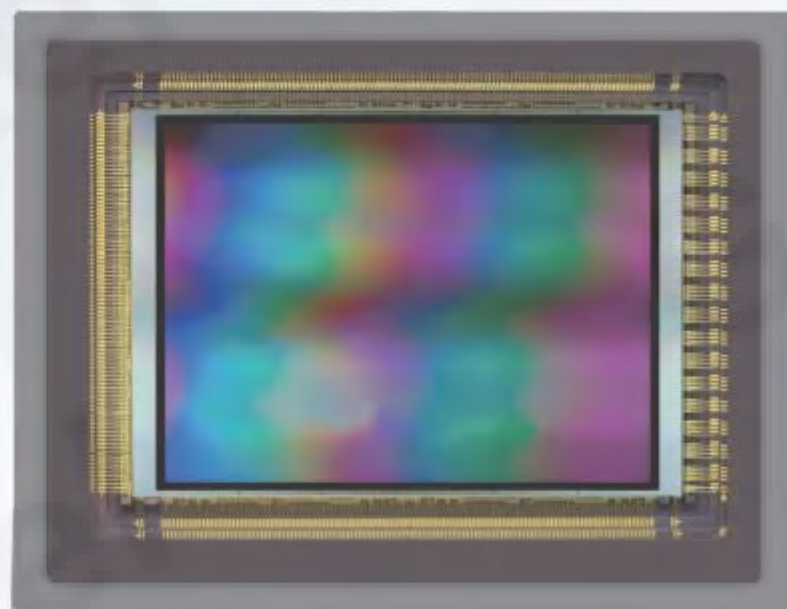
产品指标			
有效分辨率	8192(H) x 5232(V)	光学尺寸	APS-C
像素尺寸	3.2 μm x 3.2 μm	感光面积	26.2 mm x 16.7 mm
快门类型	卷帘快门 & DSC	峰值量子效率	80% (550 nm,黑白)
满阱容量	96 ke ⁻ (4次像素读出模式)	读出噪声	2.5 e ⁻ (DSC,HG)
最大信噪比	50 dB	动态范围	81 dB (8K HDR,4次像素读出模式)
最高帧频	60 fps (8K)、120 fps (4K)	输出接口	32对Sub-LVDS
最大数据率	33.6 Gbps	ADC	14 bit
色彩	彩色&黑白	功耗	2 W-4 W
供电电压	3.3 V、1.8 V、1.25 V、-2.2 V、4.5 V	封装信息	LGA、48 mm x 35.5 mm

封装图示



GCINE4349

8K 全画幅背照式堆栈CMOS图像传感器



GCINE4349是针对专业影像应用而设计的一款4900万像素(8192 x 6000)分辨率、全画幅CMOS图像传感器。芯片采用了先进的堆栈背照式技术,具备高灵敏度和优秀的角度响应,在8K模式下最高帧率可达120 fps,4K模式最高帧率可达240 fps。GCINE4349支持多斜率HDR和双增益HDR模式,最高可实现110 dB(18+档)的超高动态范围。在数码相机(DSC)模式下的读出噪声可低至1.9 e⁻且具备适配于此模式的特定快门控制。GCINE4349采用431针LGA陶瓷封装,并配有双面增透膜玻璃盖。

产品特性

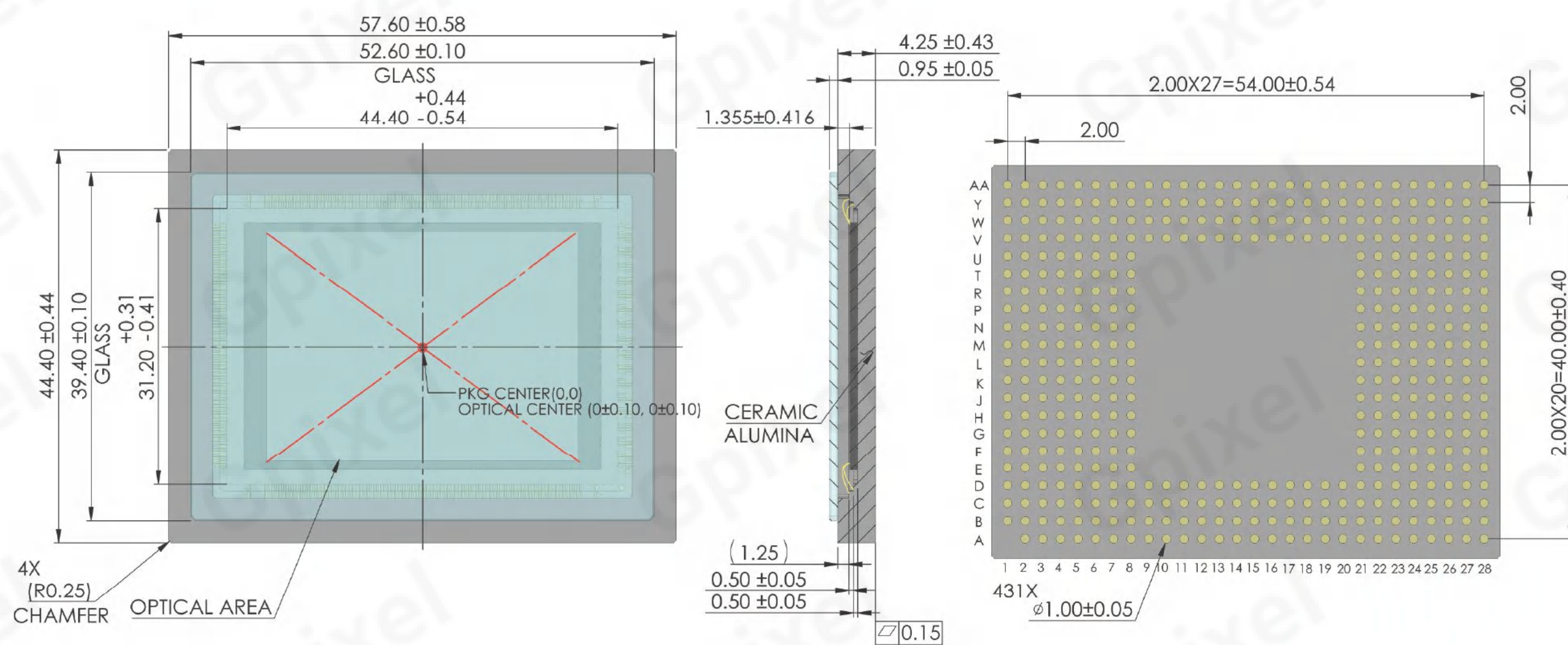
- 堆栈背照式
- 全画幅
- 8K超高清
- 高帧频
- 大满阱、低噪声
- 多斜率HDR、双增益HDR

应用领域

专业影像

产品指标			
有效分辨率	8192(H) x 6000(V)	光学尺寸	35 mm全画幅
像素尺寸	4.3 μm x 4.3 μm	感光面积	35.2 mm x 25.8 mm
快门类型	卷帘快门 & DSC	峰值量子效率	85% (500 nm,黑白)
满阱容量	152 ke ⁻	角度响应	35° (80%)
读出噪声	1.9 e ⁻	最大信噪比	52 dB
动态范围	86.4 dB (8K HDR模式)	最高帧频	120 fps (8K)、240 fps (4K)
输出接口	64对Sub-LVDS	最大数据率	76.8 Gbps
色彩	彩色	功耗	7.6 W (8K HDR)
供电电压	3.3 V、3.1V、1.8 V、1.25 V、-2.2 V	封装信息	431 pins LGA、57.6 mm x 44.4 mm

封装图示



线阵CMOS图像传感器

GL系列

GL系列是长光辰芯面向锂电检测、屏幕检测、印刷检测、自动分拣、轨道检测、光伏检测等推出的线阵CMOS图像传感器产品系列，具备高速、高灵敏度等特性，分辨率涵盖2K、4K、8K、16K。

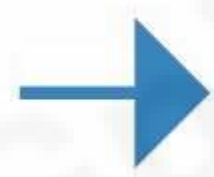
GLR1205BSI-S	GL1402BSI-M	GL1402
GL3504	GL0402	GL7004
GL0816	GLT5009BSI	GLT5008BSI
GLT5016BSI	GL7008	GL3516

GL系列特点

全局快门	高行频
TDI	高灵敏度

主要应用

锂电检测、屏幕检测、印刷检测、自动分拣、轨道检测、半导体检测、PCB检测



GMAX
GSPRINT
GSENSE
GLUX
GTOF
GCINE
GL
GXS
GIR



GLR1205BSI-S

250 μm 大像素、线阵CMOS图像传感器



GLR是长光辰芯线阵芯片GL中的全新子系列,是基于长方形像素尺寸设计的线阵图像传感器。GLR1205BSI-S像素尺寸为12.5 μm (H) x 250 μm (V),分辨率512 (H) x 1 (V)。具备高满阱、高灵敏度、高量子效率、小尺寸等特点。凭借先进的背照式工艺, GLR1205BSI-S在650 nm波长下可提供近50%的量子效率, 以及95%的峰值量子效率, 为点激光位移传感器提供了理想的解决方案。凭借250 μm (V)的大像素尺寸, 不仅为芯片提供了高达2800 ke⁻的满阱容量和71.1 dB的最大信噪比, 也提升了芯片感光灵敏度, 以及便于用户在设备装调时进行光斑对准。得益于创新的像素设计, GLR1205BSI-S具备仅2.5 μs电荷转移时间, 用户无需担心lag性能。芯片采用模拟信号输出, 用户可以基于MCU模块进行图像数据处理。芯片封装采用紧凑的CSP形式, 封装尺寸仅为 7.39 mm x 1.15 mm, 相较于市面同类型产品尺寸更小。

- 产品特性
- 背照式

· 高灵敏度

· 大满阱

· 长方形像素

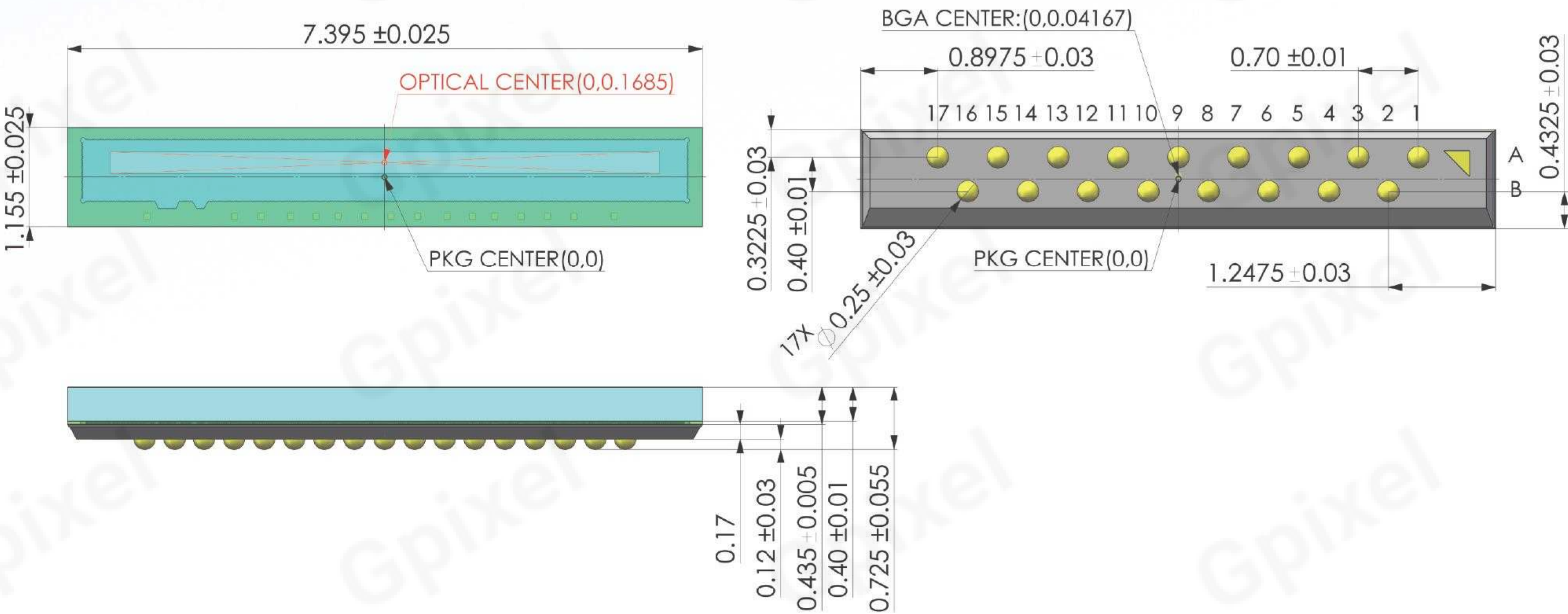
· CSP 封装

应用领域

点激光位移传感器、光谱测量、光学相干断层扫描 (OCT)

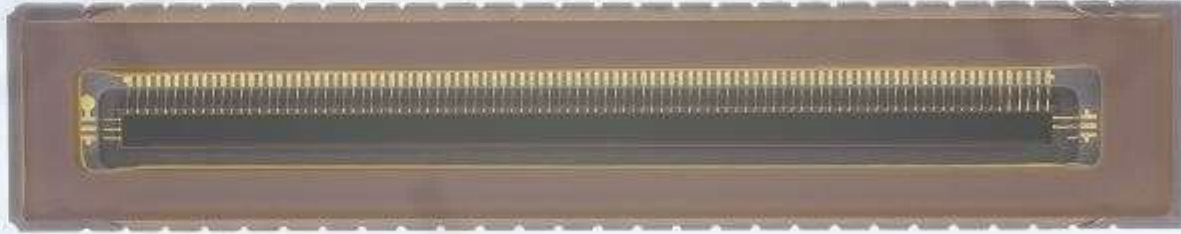
产品指标			
有效分辨率	512(H) x 1(V)	感光面长度	6.4 mm
像素尺寸	12.5 μm x 250 μm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	95%	读出噪声	0.58 mV rms
饱和输出电压	2.45 V	最高行频	9.43 kHz
动态范围	4224: 1	输入时钟频率	5 MHz
输出接口	模拟输出	最大数据率	5 MHz
色彩	黑白	功耗	90 mW
供电电压	3.3 V	封装信息	17 pins CSP、7.39 mm x 1.15 mm

封装图示



GLR1402BSI-M

2K 背照式线阵CMOS图像传感器



GLR1402BSI-M采用350 μm高度的长方形像素,具备低噪声、高动态范围、高行频等特性,适用于各类基于光谱分析的应用领域。GLR1402BSI-M像素尺寸为14 μm (H) x 350 μm (V),分辨率2048 (H) x 1 (V)。依赖于先进的像素和电路设计,该芯片最低读出噪声仅为1.4 e⁻,相较于市场同规格产品降低近10倍,可以有效识别色散后较弱的光信号。同时,该芯片采用了长光辰芯科学级产品中的双增益HDR技术,其单幅动态范围达到50000:1 (94 dB),可以准确记录光强特性和色散特性,具有更高的光谱分辨率。凭借背照式和优化的晶圆抗反射镀膜 (ARC) 工艺,其光谱响应范围覆盖从紫外到近红外。GLR1402BSI-M采用片上12 bit / 14 bit 两种数字输出,可简化用户后端开发。芯片同时支持Sub-LVDS和并行CMOS两种输出接口,用户可根据后端平台和应用需求自由选择。

- 产品特性
- 最高行频: 28 kHz

· 低噪声: 1.4 e⁻

· 双增益HDR

· QE 70.4% (280 nm)

· 12/14 bit ADC

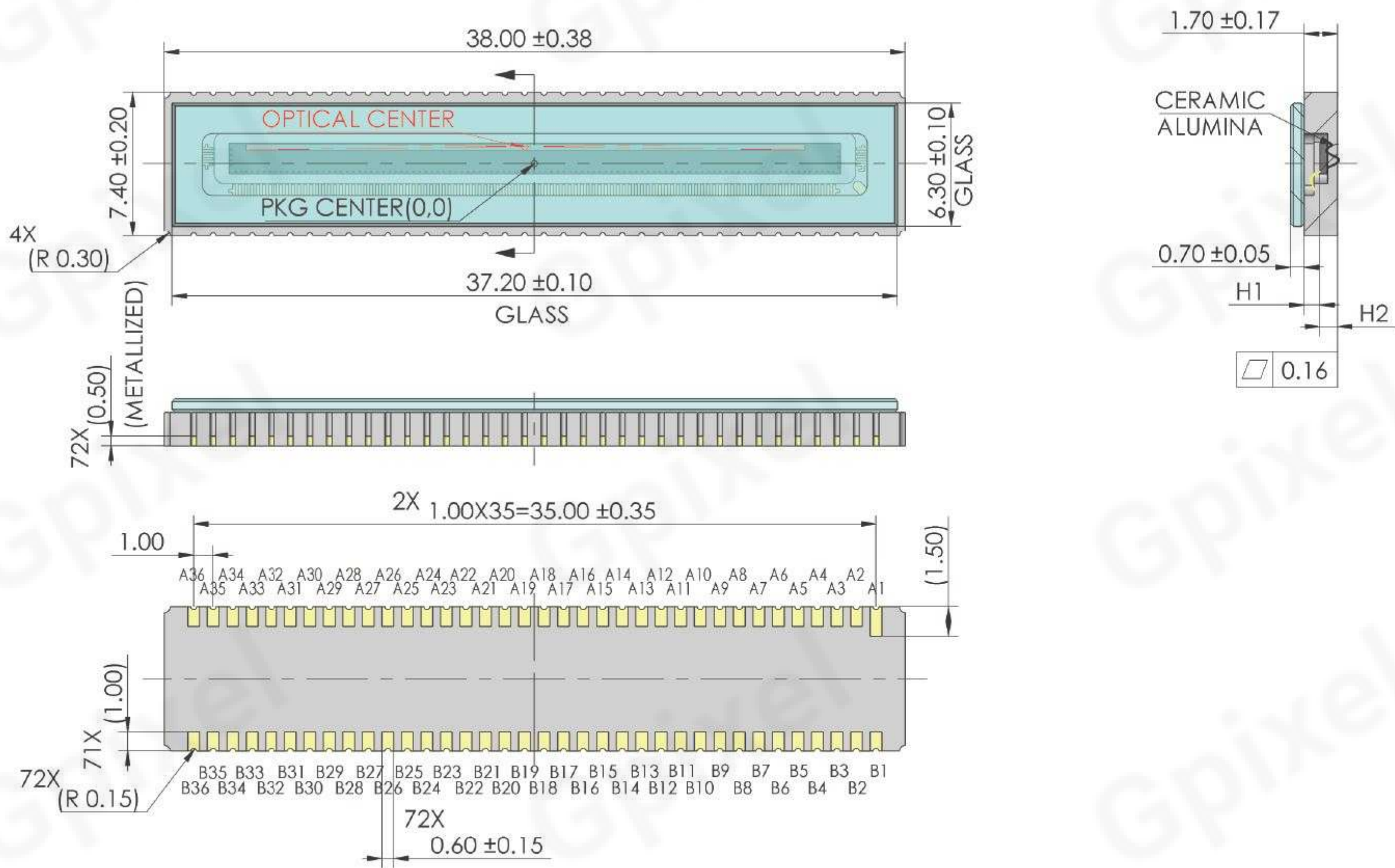
· Sub-LVDS/CMOS接口

应用领域

光谱分析、工业测量、光学相干断层扫描 (OCT)

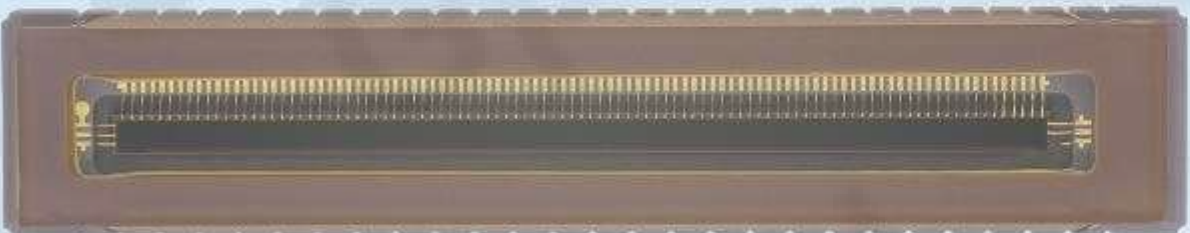
产品指标			
有效分辨率	2048(H) x 1(V)	感光面长度	28.672 mm
像素尺寸	14 μm x 350 μm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	85% (420 nm)	读出噪声	3.4 e ⁻ (HDR HG)、1.4 e ⁻ (STD HG)
满阱容量	180 ke ⁻ (LG)、90 ke ⁻ (MG)、10 ke ⁻ (HG)	角度响应	-
动态范围	94.6 dB	最高行频	29 kHz
输出接口	4 对 Sub-LVDS (600 MHz)、并行CMOS接口 (50 MHz)	通道合并	Sub-LVDS 4/2/1
ADC位数	12/14 bit	最大数据率	2.4 Gbps (Sub-LVDS)、600 M (CMOS)
色彩	黑白	功耗	<350 mW
供电电压	3.6 V(模拟)、1.8 V-3.3 V(IO)、1.5 V(数字)	封装信息	CLCC 72 pins 带石英玻璃盖板、38 mm x 7.4 mm

封装图示



GL1402

2K高灵敏度线阵CMOS图像传感器



GL1402是一款2K、高灵敏度线阵CMOS图像传感器,该传感器采用了14 μm的大像素尺寸,具备高灵敏度、高行频、高色彩分辨力等特点。GL1402为用户提供黑白和彩色两种版本,黑白版本支持单线和三线模式,彩色版本支持三线模式。每条线的间距为14 μm,可最大程度的减少颜色串扰。GL1402采用了12 bit ADC,通过4对Sub-LVDS接口进行数据传输,最大数据率可达2.08 Gbps,单线模式最高行频可达81 kHz,三线模式最高行频可达27 kHz。其每行像素的曝光时间可独立控制,以获得更加优质的成像效果。GL1402在最高行频下的功耗小于420 mW,采用54 pins CLCC封装,封装尺寸为38 mm x 7.4 mm。GL1402与同类型产品相比,具备较为显著的成本优势。在保证检测效率和质量的同时,为用户提供了一种更具性价比的选择方案。

产品特性

- 高灵敏度

· 高色彩分辨力

· 黑白:单线/三线
- 每行像素单独曝光控制

· 彩色:三线
- 外部触发

应用领域

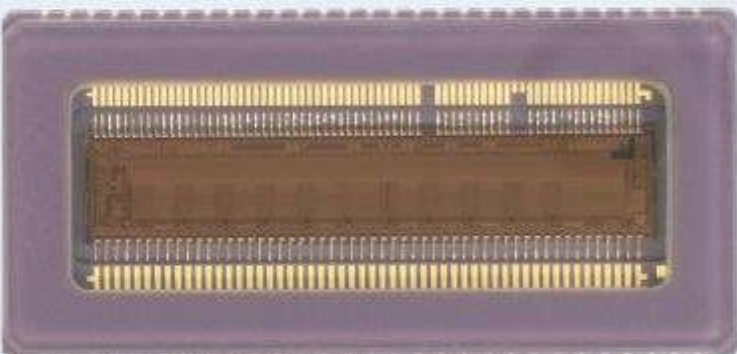
色选、OTC、光伏检测

产品指标			
有效分辨率	2048(H) x 1(V)、2048(H) x 3(V)	感光面长度	28.896 mm
像素尺寸	14 μm x 14 μm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	69.3% (560 nm)	读出噪声	9.1 e ⁻
满阱容量	28.7 ke ⁻	角度响应	20°(85% Response)
动态范围	69.9 dB	最高行频	81 kHz (单线)
输出接口	4对Sub-LVDS	通道合并	4/2/1
ADC位数	12 bit	最大数据率	2.08 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	<0.42 W
供电电压	3.6 V(模拟)、1.8 V-3.3 V(IO)、1.5 V(数字)	封装信息	54 pins CLCC、38.0 mm x 7.4 mm

封装图示	

GL3504

2K/4K 线阵CMOS图像传感器



GL3504是一款全局快门线阵CMOS图像传感器。GL3504具有两组像素阵列,一组为两行3.5 μm像素,另一组为四行7 μm像素。GL3504支持多种模式,包括3.5 μm的单/双线和7 μm的单/双/四线模式,在7 μm单线模式下最高行频可达173 kHz。GL3504采用58针CLCC陶瓷封装,具备散热快且可靠性高的特点。该产品有黑白和彩色两种芯片,彩色芯片中7 μm像素阵列为RGB真彩色,3.5 μm像素阵列为Bayer彩色。

产品特性

- 全局快门

· 工作模式:3.5 μm单线/双线、7 μm单线/双线/四线

· 12/8 bit ADC
- 光学暗像素矫正

· 片上温度传感器、SPI控制、时序

应用领域

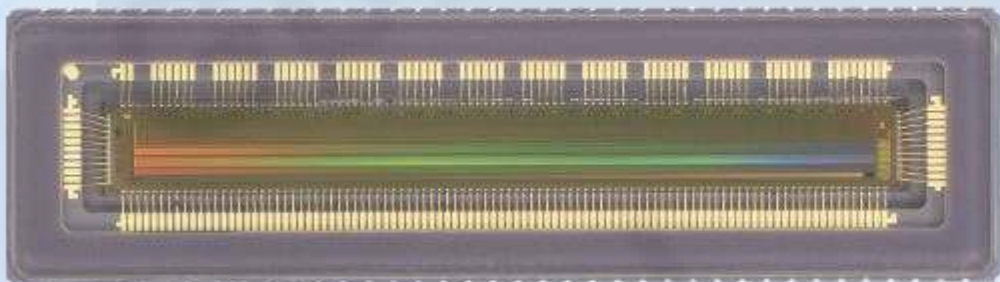
锂电检测、屏幕检测、印刷检测、自动分拣、轨道检测、半导体检测、PCB检测

产品指标			
有效分辨率	4096(H) x 2(V) (3.5 μm)、2048(H) x 4(V) (7 μm)	感光面长度	14.336 mm
像素尺寸	3.5 μm x 3.5 μm、7 μm x 7 μm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	71.9% (570 nm)	读出噪声	4.9 e ⁻ (3.5 μm,12 bit)
满阱容量	9.4 ke ⁻ (3.5 μm, 12 bit)	角度响应	20°(87% Response)
动态范围	65.8 dB (3.5 μm, 12 bit)	最高行频	172.7 kHz (7 μm,12 bit,单线)
输出接口	6对Sub-LVDS	通道合并	6/3/2/1
ADC位数	8/12 bit	最大数据率	5.472 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	<1.0 W
供电电压	3.3 V(模拟)、2.5 V-3.3 V(IO)、2.1 V(数字)	封装信息	CLCC 58 pins、22.3 mm x 10.6 mm

封装图示	

GL0402

4K高速线阵 CMOS图像传感器



GL0402是一款4K高速线阵CMOS图像传感器。芯片分辨率为4096(H) x 2(V),像素尺寸7 μm,具备5.2 e⁻读出噪声和66 dB以上的动态范围。芯片支持片上1 x 2、2 x 2像素合并,可以进一步提升动态范围和灵敏度。GL0402采用12对Sub-LVDS输出,支持两种工作模式。在单线输出模式下,最高行频可达200 kHz,双线输出模式下,最高行频可达到100 kHz,满足工业检测对效率不断提升的需求。芯片支持黑白和彩色版本,彩色芯片采用了低色彩混叠的镀膜技术,可以更加精确的进行色彩还原。芯片具备通道合并功能,使用户的FPGA选型更加灵活。GL0402集成片上时序发生器,使得相机后端设计更加简单。GL0402采用高可靠性、紧凑型的CLCC陶瓷封装,更适合工业批量生产以及小型化的应用需求。

产品特性

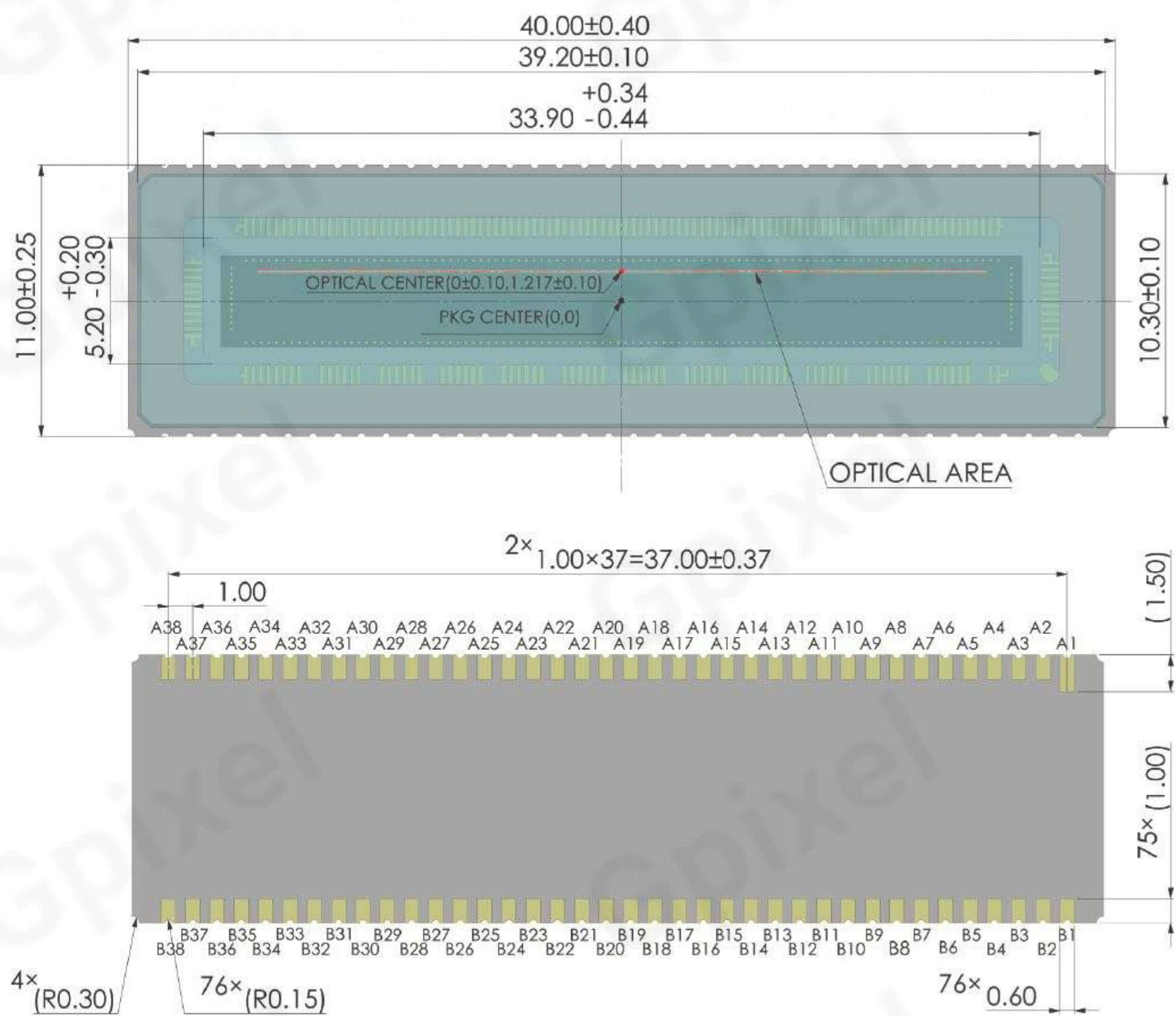
- 像素尺寸: 7 μm
- 全局快门
- 可调像素增益/模拟增益
- 1 x 2、2 x 2 像素合并
- 光学暗像素矫正
- 片上温度传感器、SPI控制、时序

应用领域

印刷包装检测、光伏检测、自动分拣、锂电检测、色选、轨道交通安全检测

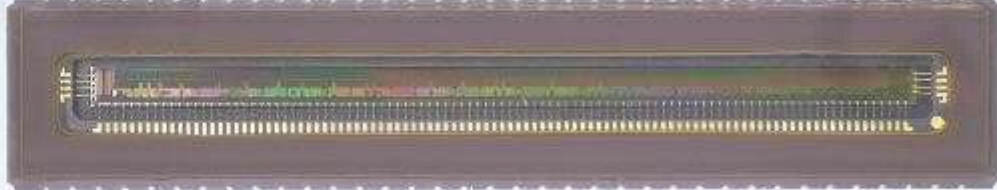
产品指标			
有效分辨率	4096(H) x 2(V)	感光面长度	28.67 mm
像素尺寸	7 μm x 7 μm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	75.57% (570 nm)	读出噪声	5.2 e ⁻ (单线,HG)
满阱容量	25 ke ⁻ (LG)、10 ke ⁻ (HG)	角度响应	20°(85% Response)
动态范围	65.6 dB (HG)	最高行频	100 kHz (双线模式)、200 kHz (单线模式)
输出接口	12对Sub-LVDS	通道合并	12/6
ADC位数	12 bit	最大数据率	10.944 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	<2.25 W
供电电压	3.3 V(模拟)、1.8 V-3.3 V(IO)、2 V(数字)	封装信息	CLCC 76 pins, 40.0 mm x 11.0 mm

封装图示



GL7004

4K真彩色高速线阵CMOS图像传感器



GL7004是一款4096 (H) X4 (V) 分辨率的全局快门线阵CMOS图像传感器,结合7 μm高灵敏度像素、最快200 kHz行频(单线模式)和超高性价比, GL7004是光伏检测、铁路检测、2.5D视觉等工业应用场景的理想解决方案。GL7004有彩色和黑白两种版本, 黑白版本支持单线、双线、三线和四线模式; 彩色版本支持三线真彩模式和四线RGBW模式。GL7004采用紧凑型的LCC陶瓷封装, 仅需3路外供电源, 功耗仅为1.05 W, 更方便客户进行硬件设计和系统集成。

产品特性

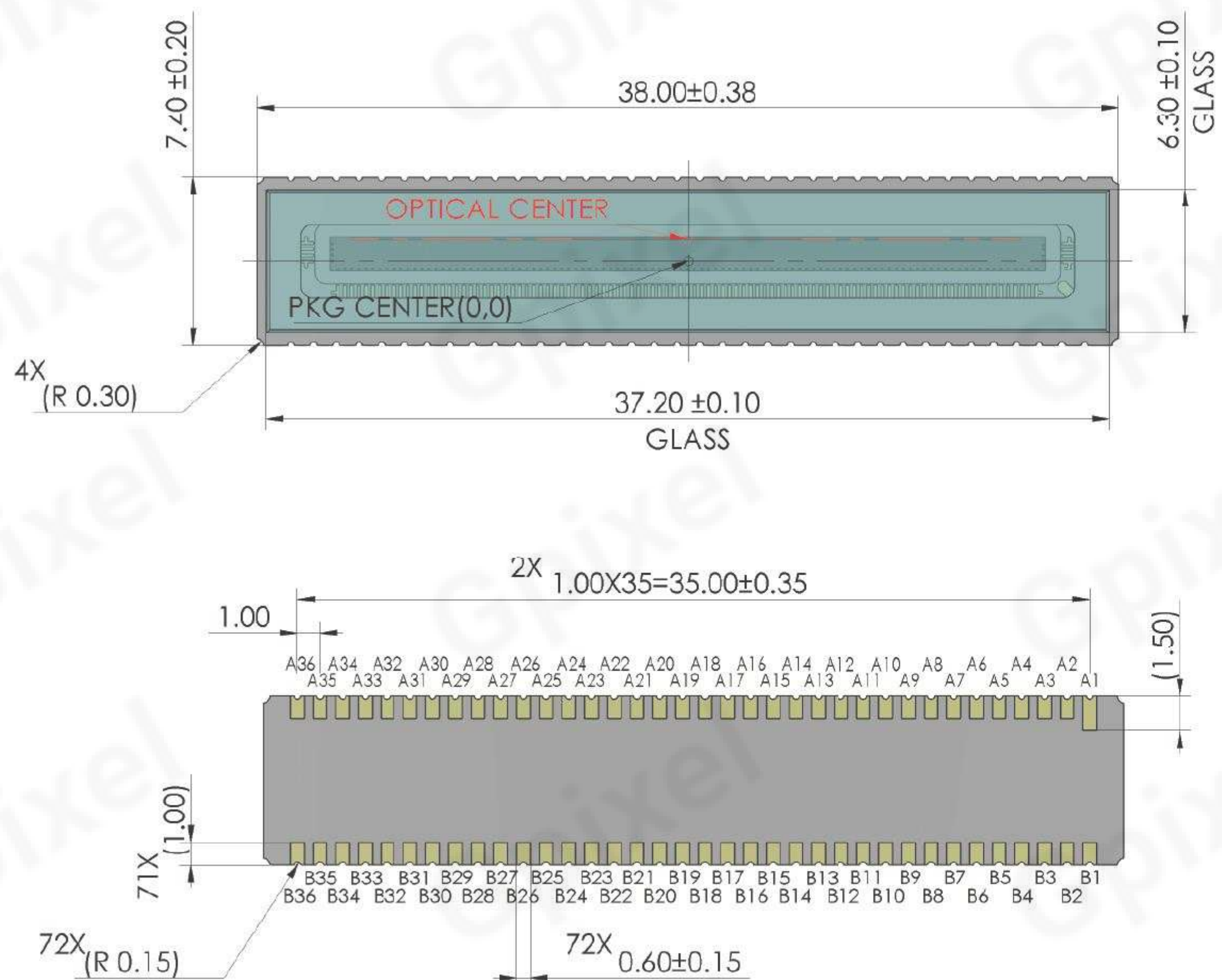
- RGB/RGBW真彩
- 高行频
- 低功耗
- 每行像素单独曝光控制
- 高性价比

应用领域

光伏检测、铁路检测、2.5D视觉

产品指标			
有效分辨率	4096(H) x 4(V)	感光面长度	28.67 mm
像素尺寸	7 μm x 7 μm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	74.5% (560 nm)	读出噪声	4.3 e ⁻ (10 bit, analog gain 4x)
满阱容量	10.5 ke ⁻ (10 bit, analog gain 1x)	动态范围	61.5 dB
输出接口	12对Sub-LVDS	最高行频	250 kHz (单线模式)
ADC	10 bit	最大数据率	14.4 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	1.05 W
供电电压	3.6 V(模拟)、1.8 V-3.3 V(IO)、1.5 V(数字)	封装信息	72 pins CLCC、38.0 mm x 7.4 mm

封装图示



GL0816

8322 x 16高速线阵CMOS图像传感器



GL0816是一款针对高速工业检测应用而设计的8K高速线阵CMOS图像传感器,像素尺寸5 μm,包含16条线,线间隔为5 μm。芯片支持标准四线模式以及片上2级TDI模式,最高行频可达200 kHz,满足工业检测对检测效率不断提升的需求。为获得更高的灵敏度,芯片可读出16条线,使其在相机内进行TDI运算成为可能。GL0816采用了特殊定制的彩色镀膜,以降低色彩混叠,可以更加精确的进行色彩还原。

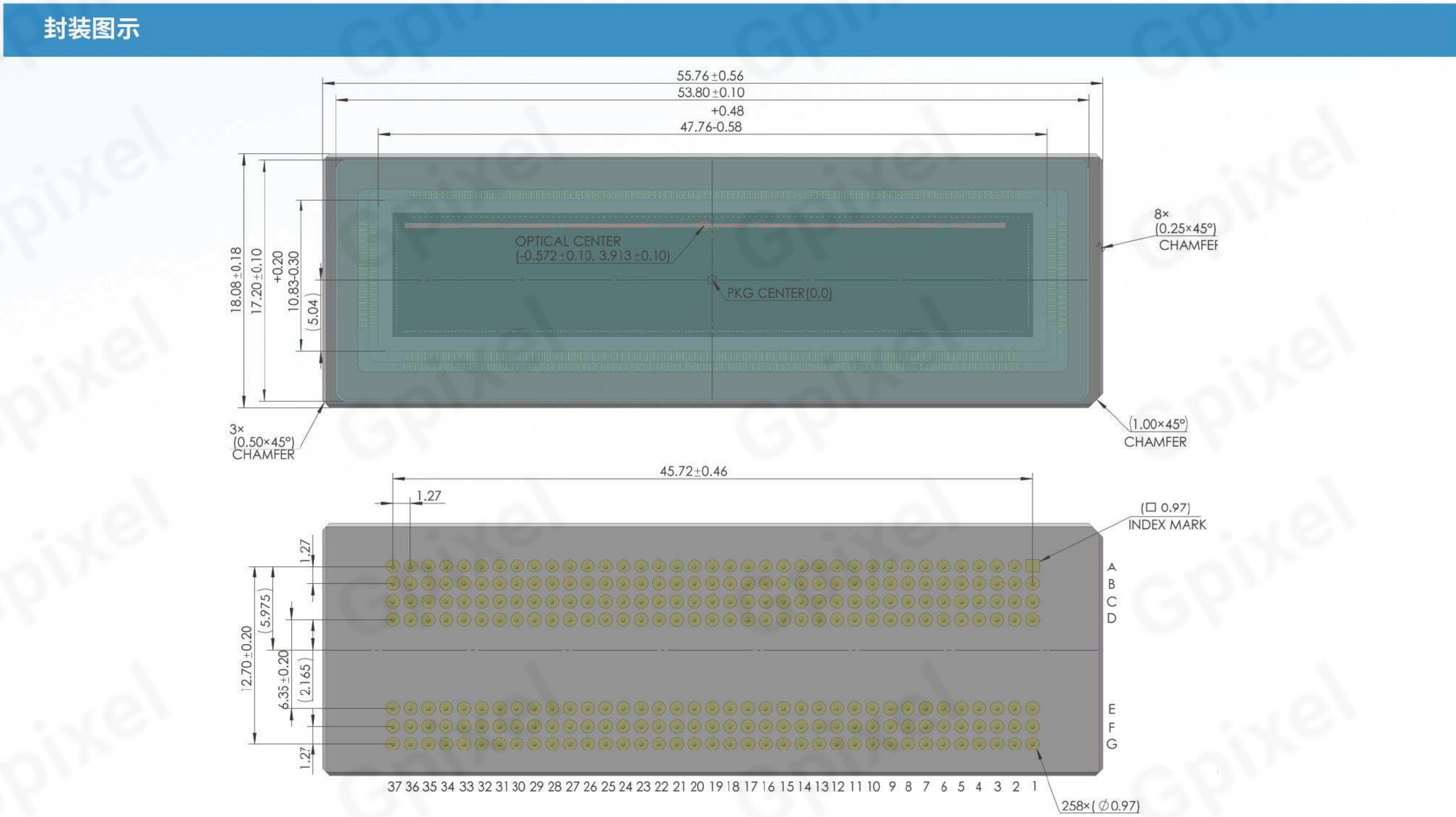
产品特性

- 像素尺寸: 5 μm
- 5 μm 16线
- 行独立曝光控制
- 可调增益
- 10/11 bit ADC
- 电子暗像素矫正
- 全局快门
- 片上温度传感器
- 支持片上2级TDI

应用领域

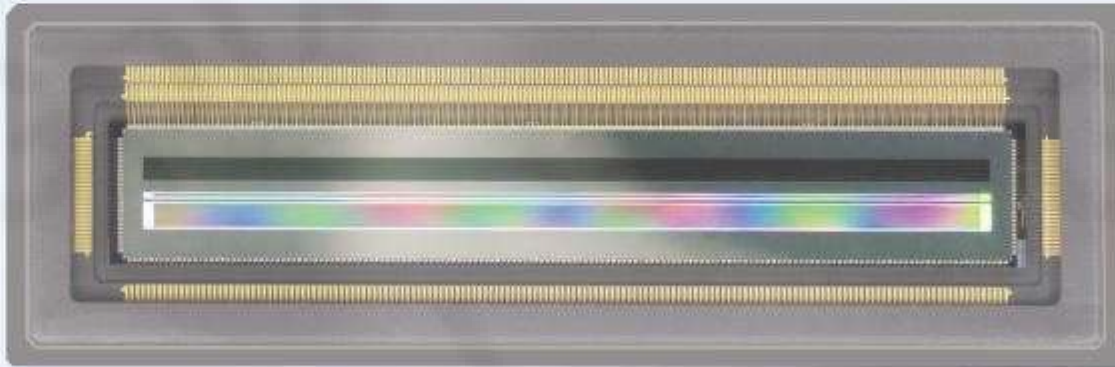
锂电检测、屏幕检测、印刷检测、自动分拣、轨道检测、读码应用

产品指标			
有效分辨率	8322(H) x 16(V)	感光面长度	41.61 mm
像素尺寸	5 μm x 5 μm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	>70% (600 nm)	读出噪声	13 e ⁻ (11 bit, 双线)
满阱容量	17 ke ⁻ (11 bit,双线), 15 ke ⁻ (10 bit,4线)	角度响应	>15° (85% Response)
动态范围	62 dB (11 bit, 双线)	最高行频	200 kHz (11 bit,双线)、100kHz (10 bit,4线)
输出接口	66对Sub-LVDS	ADC	10/11 bit
色彩	黑白 & 彩色	功耗	<4 W
供电电压	3.3 V(模拟)、2.2 V(ADC)、2 V(数字/LVDS)	封装信息	258 pins μPGA、55.8 mm x 18.1 mm



GLT5009BSI

9K 背照式CMOS TDI 图像传感器



GLT5009BSI是一款背照式电荷域时间延时积分(TDI)CMOS图像传感器。GLT5009BSI像素尺寸为5 μm,横向分辨率为9072,级数达到256级。结合先进的背照式工艺,使其具有极高的灵敏度,以满足在高速、弱光环境下的检测需求。GLT5009BSI具有16 ke⁻的满阱容量以及小于8 e⁻的读出噪声,动态范围可达68.7 dB。芯片集成两个谱段,分别为256级和32级,在双谱段工作模式下,可进行HDR合成,动态范围可达77.5 dB。该芯片采用84对Sub-LVDS输出,最大数据速度可达74.304 Gbps。芯片支持多种工作模式,10 bit输出时最高行频可达608 kHz,12 bit输出时最高行频为300 kHz。GLT5009BSI采用了269 pins μPGA陶瓷封装,同时片上集成时序生成器、LVDS通道合并、双向扫描等功能,使得用户的相机设计更加简单。GLT5009提供标准版本和深紫外增强版本。

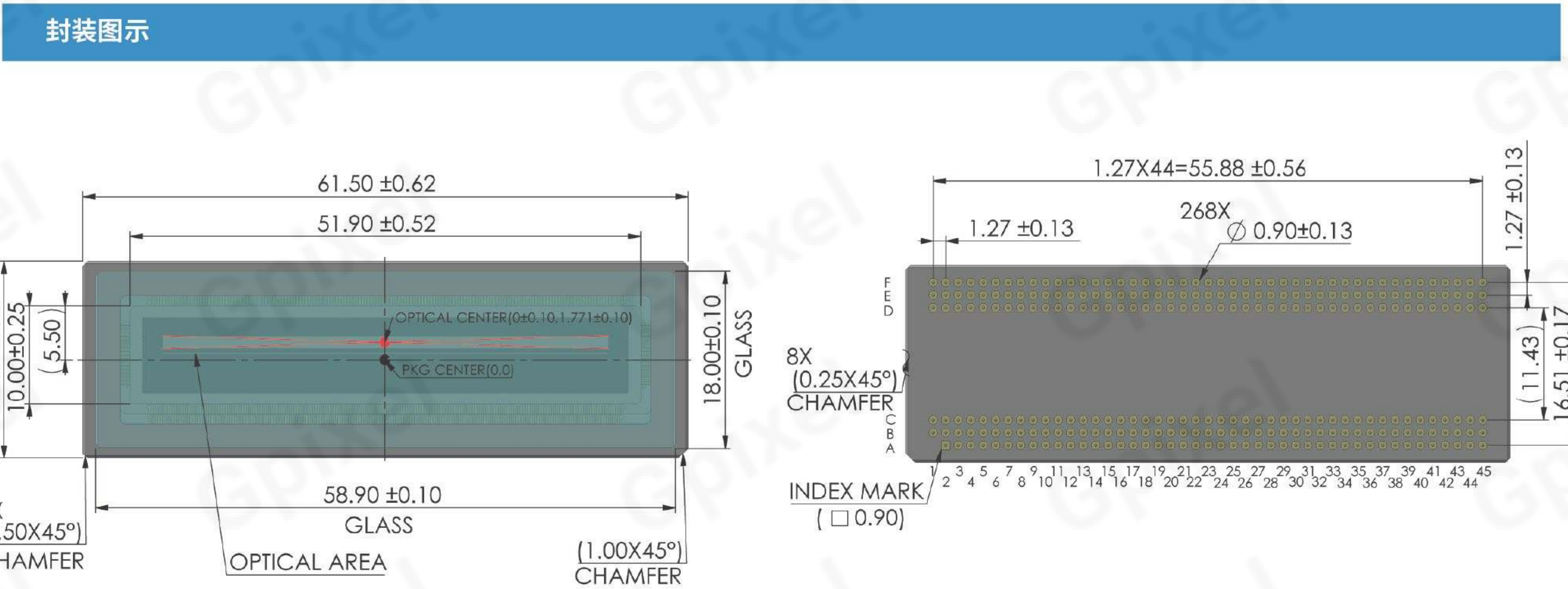
产品特性

- 背照式
- 最高行频: 608 kHz (10 bit)
- TDI
- 双谱段HDR
- 高灵敏度
- QE ≥ 50% (266 nm)

应用领域

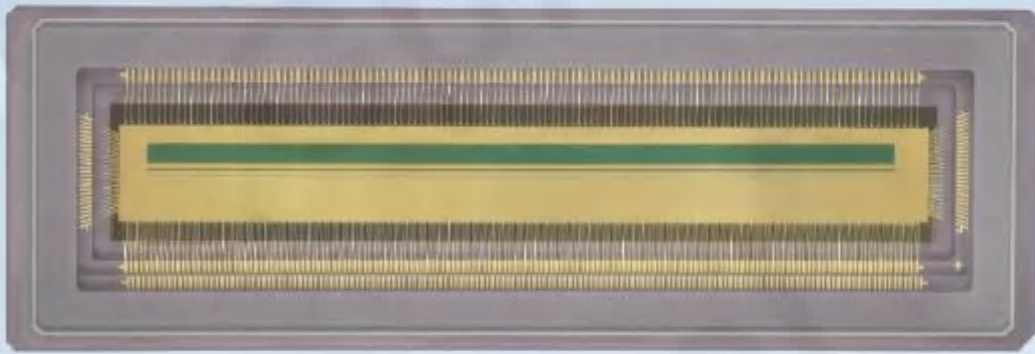
工业检测、半导体检测、荧光成像、医疗成像

产品指标			
有效分辨率	P1:9072(H) pixels x 256(V) stages P2:9072(H) pixels x 32(V) stages	感光面长度	45.36 mm
像素尺寸	5 μm x 5 μm	满阱容量	16.3 ke ⁻ (10 bit,single band) 19.2 ke ⁻ (12 bit,single band)
读出噪声	10.6 e ⁻ (10 bit,single band) 7.0 e ⁻ (12 bit,single band)	动态范围	63.7 dB (10 bit,single band) 68.7 dB (12 bit,single band)
暗电流	~4 ke ⁻ /s/pixel (30°C)	峰值量子效率	82.4% (550 nm)
ADC	10/12 bit	最高行频	608 kHz (10 bit,single band) 300 kHz (12 bit,single band)
输出接口	84对Sub-LVDS	电荷转移效率(CTE)	≥ 0.99993
通道合并	84/42/21/12/6/3	最大数据率	74.304 Gbps
色彩	黑白,黑白(UV)	功耗	<5.8 W (300 kHz line rate)
供电电压	5 V(模拟)、1.8 V(ADC)、1.8 V(数字)	封装形式	μPGA 269 pins、61.5 mm x 20.0 mm



GLT5008BSI

8K背照式CMOS TDI图像传感器



GLT5008BSI是一款背照式(BSI)、时延积分 (TDI)、电荷域CMOS图像传感器, 水平方向有效分辨率为8208, 像素尺寸为5 μm, 最高满阱 17 ke⁻, 具有优异的anti-blooming能力以及大于0.99993的电荷转移效率(CTE), 峰值量子效率为93.4% (440 nm), 得益于先进的背照式工艺和紫外量子效率优化工艺, 在266 nm处的量子效率大于63.9%。同时, GLT5008BSI片上集成双谱段, 级数分别为256级和32级, 可通过HDR合成进一步提升动态范围。GLT5008BSI支持10 bit和12 bit ADC输出, 对应的最大行频分别为1 MHz和500 kHz, 10 bit最高行频下功耗<4.2 W, 为确保高可靠性和良好的散热性能, 其采用231引脚的μPGA陶瓷封装。GLT5008BSI具备高分辨率、高灵敏度、高帧频、低功耗等优异性能, 同时片上集成了时序控制模块和电源管理模块, 支持通道合并、可选扫描方向等功能, 为基因测序、半导体检测、屏幕检测等应用带来更加准确、简单、高效的解决方案。

- 产品特性
- 双感光谱段

· 双谱段HDR

· 像素尺寸: 5 μm

· 峰值量子效率: 63.9% (266 nm) ,93.4% (440 nm)

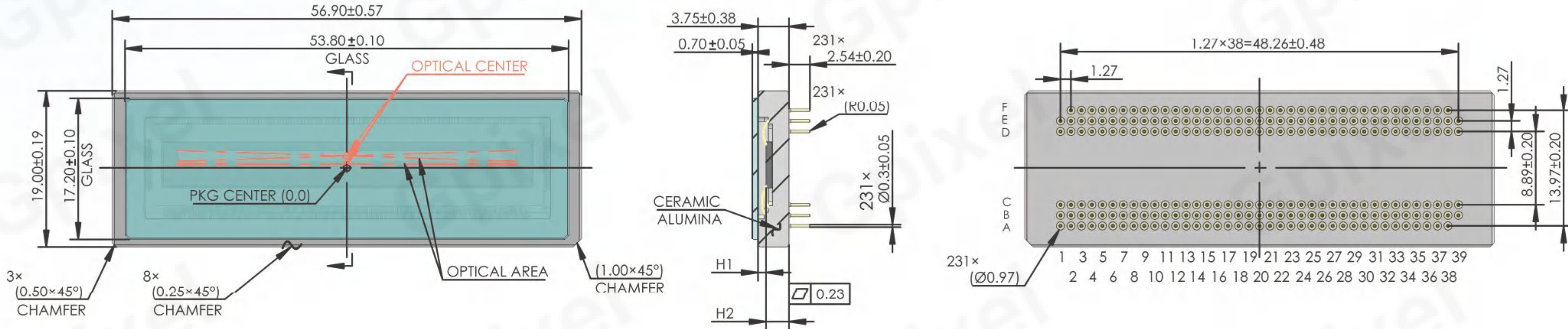
· 背照式、TDI

· 高灵敏度

应用领域

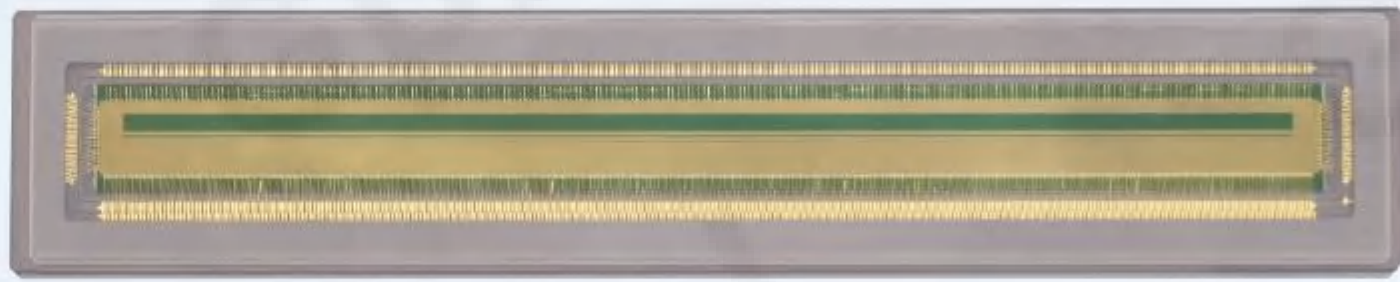
自动化检测、生命科学、显微成像、微光成像

产品指标			
有效分辨率	P1: 8208(H) pixels x 256(V) stages P2: 8208(H) pixels x 32(V) stages	感光面长度	41.04 mm
像素尺寸	5 μm x 5 μm	满阱容量	16.8 ke ⁻ (P1,10 bit,single band) 17.8 ke ⁻ (P1,12 bit,single band)
读出噪声	12.1 e ⁻ (P1,10 bit,single band) 7.4 e ⁻ (P1,12 bit,single band)	动态范围	62.8 dB (P1,10 bit,single band) 67.6 dB (P1,12 bit,single band)
暗电流	1 ke ⁻ /pixel/s (P1 10/12 bit,single band,15 °C)	量子效率	63.9% (266 nm)、93.4% (440 nm)
ADC	10/12 bit	可选TDI级数	P1: 256/252/224/192/128/64/32/4 P2: 32/30/28/24/16/8/4/2
最高行频	1M Hz (10 bit)、500k Hz (12 bit)	Anti-blooming	x50
输出接口	72 对 Sub-LVDS	电荷转移效率(CTE)	≥ 0.99993
通道合并	72/54/48/36/24/18/12/6 (10 bit)	最大数据率	86.4 Gbps (10 bit)
色彩	黑白	功耗	≤ 4.1 W (P1,10 bit,1 MHz line rate) ≤ 3.2 W (P1,12 bit,500 kHz line rate)
供电电压	3.3 V (模拟)、1.6 V (ADC)、1.6 V (数字)	封装形式	μPGA 231 pins、56.90 mm x 19.00 mm
封装图示			



GLT5016BSI

16K背照式CMOS TDI图像传感器



GLT5016BSI是一款背照式(BSI)、时延积分(TDI)、电荷域CMOS图像传感器, 水平方向有效分辨率为16416, 像素尺寸为5 μm, 最高满阱 15 ke⁻, 具有优异的anti-blooming能力以及大于0.99996的电荷转移效率(CTE), 最高级数支持256级, 最高行频可达500 kHz, 在最高行频情况下功耗小于6.4 W, 为确保高可靠性和良好的散热性能, 其采用415引脚的μPGA陶瓷封装。GLT5016BSI具备高分辨率、高灵敏度、高帧频、低功耗等优异性能, 同时片上集成了时序控制模块和电源管理模块, 支持通道合并、可选扫描方向等功能, 为基因测序、半导体检测、屏幕检测等应用带来更加准确、简单、高效的解决方案。GLT5016BSI 支持两种版本: 一种是UV版本(可拆玻璃盖), 着重提升300 nm以下的量子效率, 在266 nm的量子效率>70%;另外一种为VIS版本(不可拆玻璃盖), 着重优化可见光谱段量子效率, 410 nm – 660 nm区间内, 量子效率均>80%。

- 产品特性
- 双感光谱段

· 高灵敏度

· 像素尺寸: 5 μm

· 双谱段HDR

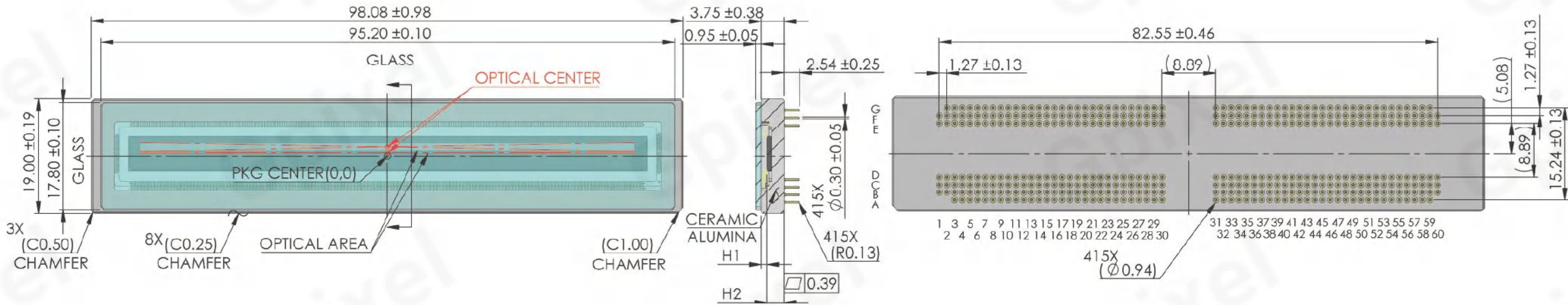
· 背照式、TDI

· 峰值量子效率: 92% (436 nm)

应用领域

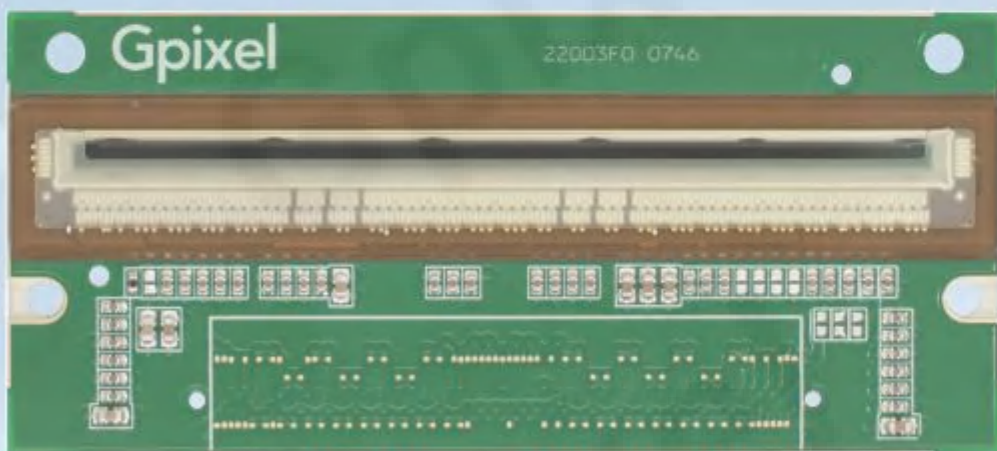
自动化检测、生命科学、显微成像、微光成像

产品指标			
有效分辨率	P1: 16416(H) pixels x 256(V) stages P2: 16416(H) pixels x 32(V) stages	感光面长度	82.08 mm
像素尺寸	5 μm x 5 μm	满阱容量	16.3 ke ⁻ (P1,10 bit,single band) 15.2 ke ⁻ (P1,12 bit,single band)
读出噪声	7.5 e ⁻ (P1,12 bit,single band) 15.3 e ⁻ (P1,10 bit,single band)	动态范围	60.5 dB (P1,10 bit,single band) 66.1 dB (P1,12 bit,single band)
暗电流	0.97 ke ⁻ /pixel/s (P1 10/12 bit,single band,15 °C)	ADC	12 bit
量子效率	UV版本 70.7% (266 nm) ,87.8% (420 nm) VIS版本 92.4% (436 nm) ,87.0% (590 nm)	可选TDI级数	P1: 256/252/224/192/128/64/32/4 P2: 32/30/28/24/16/8/4/2
最高行频	500 kHz	Anti-blooming	x50
输出接口	108 对 Sub-LVDS	电荷转移效率(CTE)	≥ 0.99996
通道合并	108/96/72/48/36/24/12	最大数据率	103.68 Gbps
色彩	黑白	功耗	≤ 6.3 W (P1,10 bit,500 kHz line rate) ≤ 6.6 W (P1,12 bit,500 kHz line rate)
供电电压	3.3 V (模拟)、1.65 V (ADC)、1.6 V (数字)	封装形式	μPGA 415 pins、98.08 mm x 19.00 mm
封装图示			



GL7008

8K高速线阵CMOS图像传感器



GL7008是一款8K高速线阵CMOS图像传感器。芯片采用7 μm像素设计,通过25对Sub-LVDS进行数据传输,其最高行频可达200 kHz。芯片支持黑白和彩色两个版本,黑白芯片支持单线和双线模式,在实现高行频的同时,满足更高灵敏度的需求。彩色芯片支持RGB三线真彩色和RGBW四线多光谱输出,每条线可根据外部触发信号,单独调整曝光时间,使其更好进行色彩还原,同时该芯片的线间距为单个像素尺寸,以满足行频匹配的要求。GL7008在全速输出下功耗约为4.4 W,为了更好的解决芯片在高行频工作下的散热问题,该芯片采用了热导率更好的钨铜金属+COB的封装,通过连接器将片上信号引出,直接连接相机板连接器,无需焊接和插座,使组装过程更简洁。

产品特性

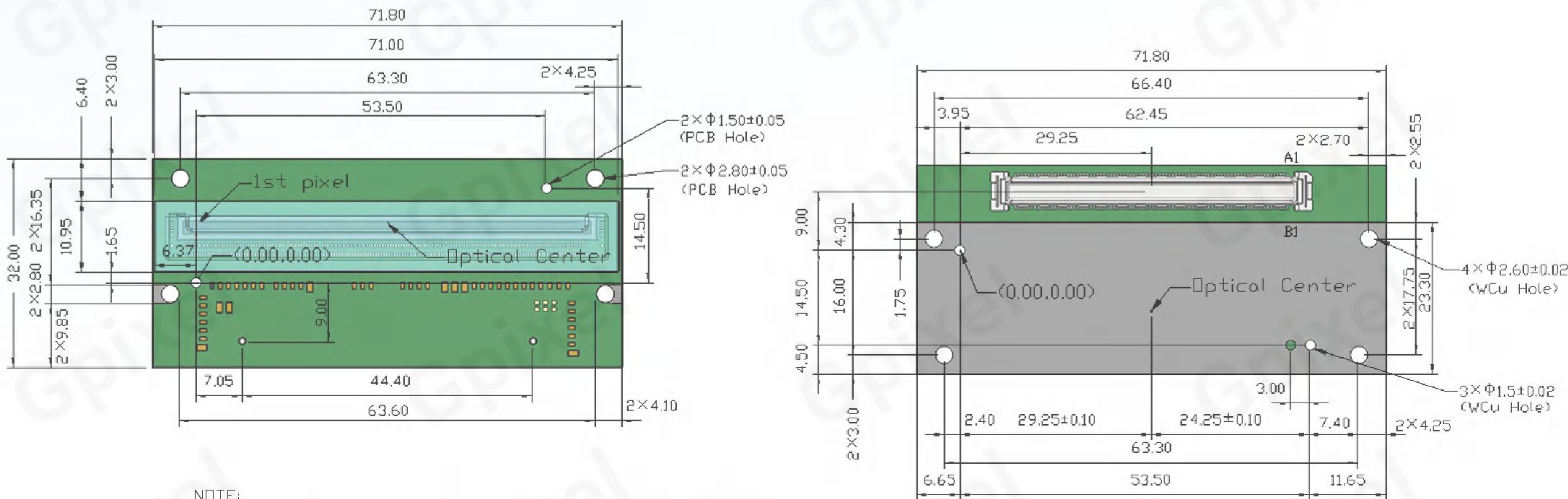
- 全局快门
- 光学暗像素
- 高行频
- 片上温度传感器、SPI控制、PLL、时序

应用领域

PCB检测、印刷检测、读码应用、3C检测、平板类检测、锂电检测

产品指标			
有效分辨率	8192(H) x 4(V)黑白、8192(H) x 4(V)彩色	感光面长度	57.344 mm
像素尺寸	7 μm × 7 μm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	73.2% (530 nm)	读出噪声	6.8 e ⁻
满阱容量	10 ke ⁻	角度响应	20° (85% Response)
动态范围	63.3 dB	最高行频	200 kHz (单线)、100 kHz (双线)
输出接口	25对Sub-LVDS	通道合并	25/13/7/4
ADC位数	12 bit	最大数据率	24 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	4.4 W
供电电压	3.3 V(模拟)、1.8 V-3.3 V(IO)、1.8 V(数字)	封装信息	168 Pins COB、71.8 mm x 32.0 mm

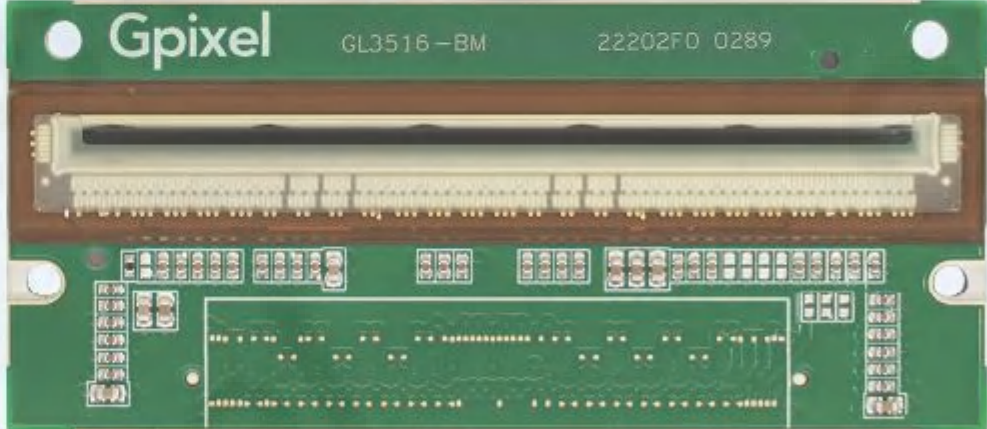
封装图示



- NOTE:
1. GL7008 COLOR 4 lines, Optical Center1(29.25±0.10,9.333±0.10)
GL7008 MONO 2 lines, Optical Center2(29.25±0.10,9.305±0.10)
 2. All tolerances +/-0.1mm unless otherwise noticed

GL3516

16K高速线阵CMOS图像传感器



GL3516是一款16K高速线阵CMOS图像传感器。芯片采用3.5 μm全局快门像素,通过25对Sub-LVDS通道进行数据传输,最高行频可达120 kHz。GL3516可提供黑白和彩色两种版本,黑白版本支持单线和双线模式,彩色版本支持双线模式。每种颜色的像素可根据外部触发信号单独调整曝光时间,使彩色像素线可以更好的进行色彩还原。GL3516在全速运行时的功耗仅为3.2 W,结合热导率更好的钨铜金属+COB封装,即使长时间在高行频工作状态下也能保持良好的散热状态。GL3516与GL7008硬件整体兼容,可极大降低用户的设计开发成本。芯片通过连接器将信号引出,可直接与相机板连接,使组装过程更加方便快捷。

产品特性

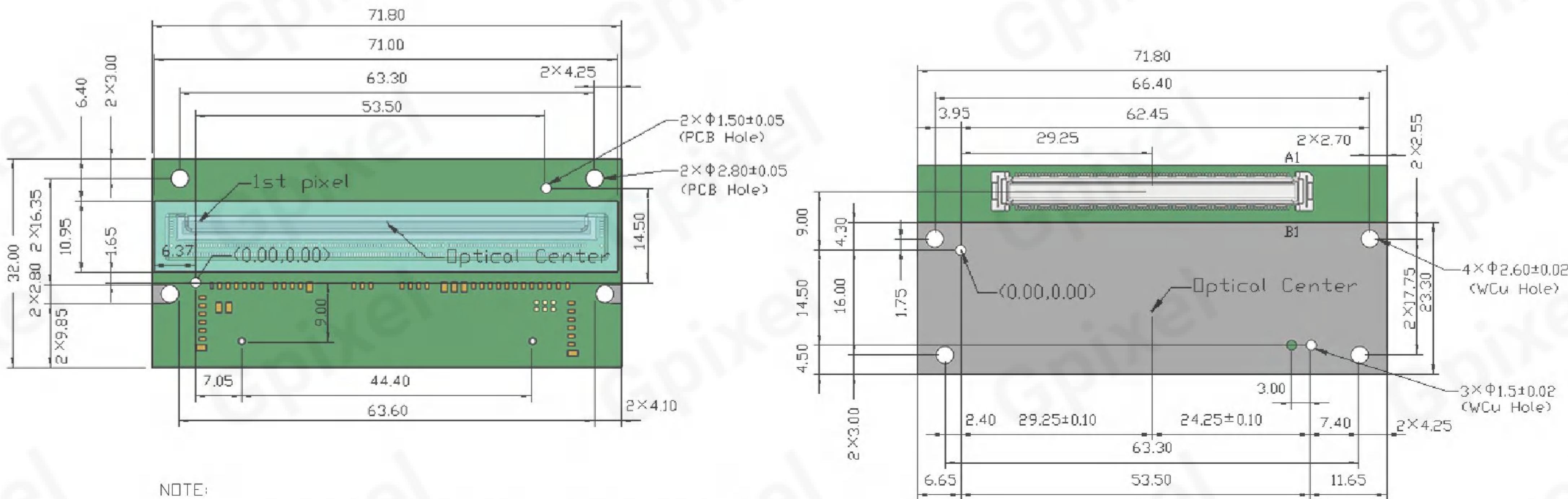
- 分辨率:16384(H) x 2(V)
- 黑白:单线、双线
- 全局快门
- 彩色:双线
- 每行像素单独曝光控制
- 光学暗像素
- 外部触发

应用领域

锂电检测、屏幕检测、印刷品检测、自动分拣、轨道安全检测

产品指标			
有效分辨率	16384(H) x 2(V)	感光面长度	57.344 mm
像素尺寸	3.5 μm × 3.5 μm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	56.7% (560 nm)	读出噪声	8.2 e ⁻
满阱容量	8.4 ke ⁻	角度响应	20° (85% Response)
动态范围	60.2 dB	最高行频	120 kHz (单线)
输出接口	25对Sub-LVDS	通道合并	25/13/7/4
ADC 位数	10 bit	最大数据率	24 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	3.2 W
供电电压	3.3 V(模拟)、1.8 V(数字)、1.8 V-3.3 V(IO)	封装信息	168 Pins COB、71.8 mm x 32.0 mm

封装图示



- NOTE:
1. GL3516 COLOR 2 lines, Optical Center1(29.25±0.10,9.246±0.10)
GL3516 MONO 2 lines, Optical Center2(29.25±0.10,9.204±0.10)
 2. All tolerances +/-0.1mm unless otherwise noticed

	GMAX
	GSPRINT
	GSENSE
	GLUX
	GTOF
	GCINE
→	GXS
	GIR

面阵CMOS图像传感器

GXS系列

GXS 系列是长光辰芯推出的基于晶圆级芯片封装技术封装的图像传感器，其紧凑的外形适用于各类空间受限应用，例如内窥镜, 可穿戴设备, 虚拟现实以及增强现实设备等。

GXS1508/GXSM1508

GXS系列特点

- 背照式
- 高灵敏度
- 紧凑型CSP封装

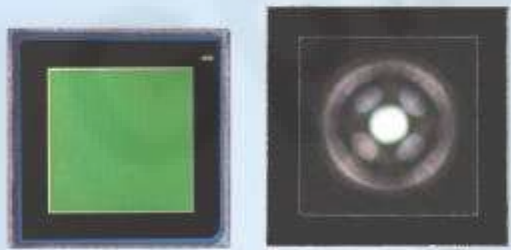
主要应用

一次性内窥镜



GXS1508/GXSM1508

小尺寸CMOS图像传感器/光学模组



GXS1508是一款紧凑型4 针CSP格式传感器,采用 400 x 400 分辨率和 1.5 μm 卷帘快门像素设计。芯片使用的BSI像素,并通过特殊的CSP 封装的设计增加了传感器灵敏度。它具有 30 fps 帧速率的模拟信号输出,可与主流 ISP 兼容以进行模数转换。传感器尺寸为 0.961 x 0.961 x 0.55 mm。GXSM1508为GXS1508集成晶圆级光学镜头构成的模组,尺寸为 1.04 x 1.04 x 2.082 mm。晶圆级光学镜头 (WLO) 采用3片镜头结构,且 F# 光圈值为5.0, 此设计平衡了镜头的透光量以及图像质量。镜头对角视场角为120°,即使在狭窄的空间内也能保证观察范围。GXS1508 和 GXSM1508 可以满足一次性内窥镜、位置传感、智能家电和玩具等应用需求。

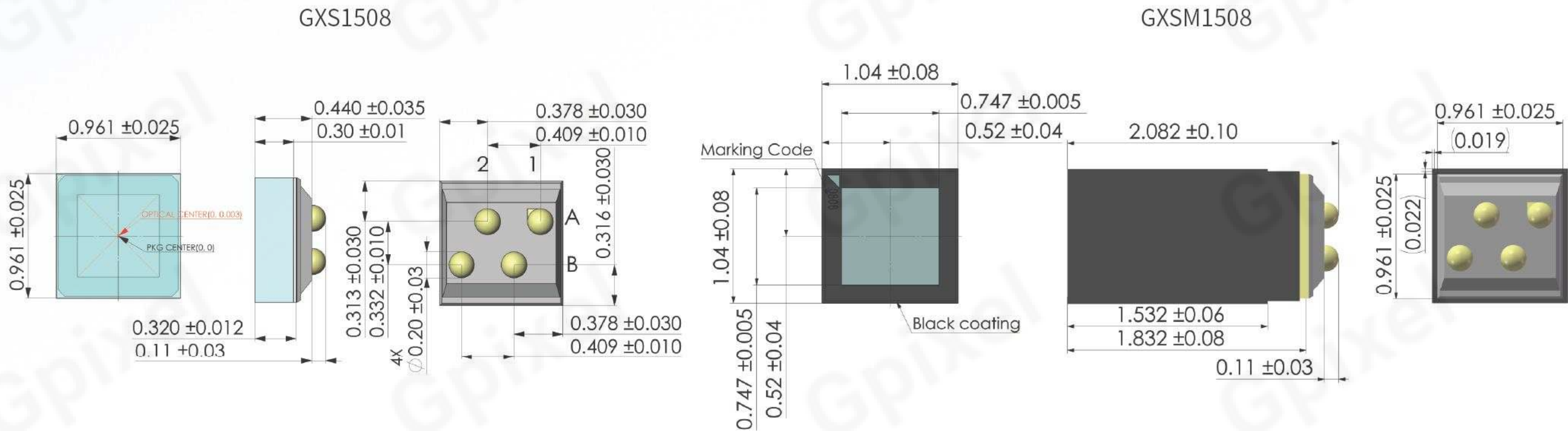
- 产品特性

 - 背照式
 - 紧凑型CSP封装
- 高灵敏度

· 集成WLO镜头

应用领域
一次性内窥镜

产品指标			
有效分辨率	400 (H) x 400 (V)	光学尺寸	1/19"
像素尺寸	1.5 μm x 1.5 μm	感光面积	0.6 mm x 0.6 mm
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	T.B.C
满阱容量	5 ke ⁻	最高帧频	30 fps
动态范围	57 dB	CRA	28°±3°
输出接口	模拟输出	读出噪声	7.19 e ⁻
色彩	彩色	功耗	17.3 mW
供电电压	3.3 V	封装信息	4 pins CSP, 0.961 mm x 0.961 mm x 0.55 mm
光学指标			
视场角	水平视场角 83°、对角视场角 120°	光圈F#	5.0
焦距	0.417 mm	镜头构型	3面镜头
TV畸变	<16% (90% 像高)	对焦范围	最佳对焦范围 4-50 mm
红外滤波片	665 nm ± 10 nm		
封装图示			



	GMAX
	GSPRINT
	GSENSE
	GLUX
	GTOF
	GCINE
	GL
	GXS
➔	GIR

SWIR图像传感器

GIR系列

GIR系列是长光辰芯全新推出的InGaAs短波红外 (SWIR) 图像传感器, 具有高灵敏度、高动态范围、数字输出等优势, 采用InGaAs感光材料, 感光谱段范围覆盖900-1700 nm, 在1550 nm波长处, 其量子效率高达75%, 同时集成片上ADC, 直接数字信号输出, 不仅极大缩短了相机产品的开发周期, 同时也进一步提升了工业检测的生产效率, 将为半导体检测、工业检测、智能分拣、光谱分析等领域提供全新的解决方案。

GIR1201

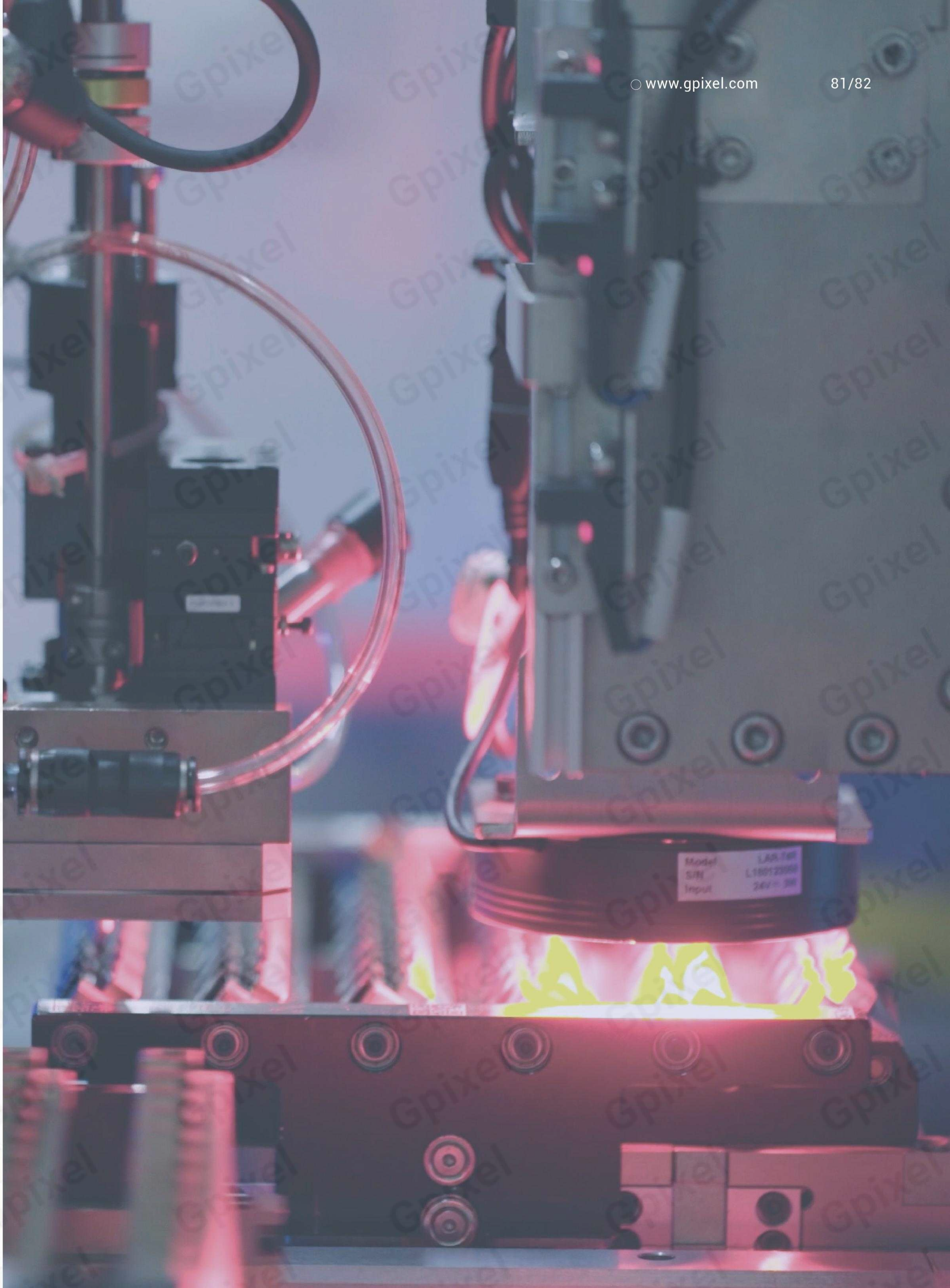
GIR2505

GIR系列特点

高灵敏度	高动态范围
数字输出	高速

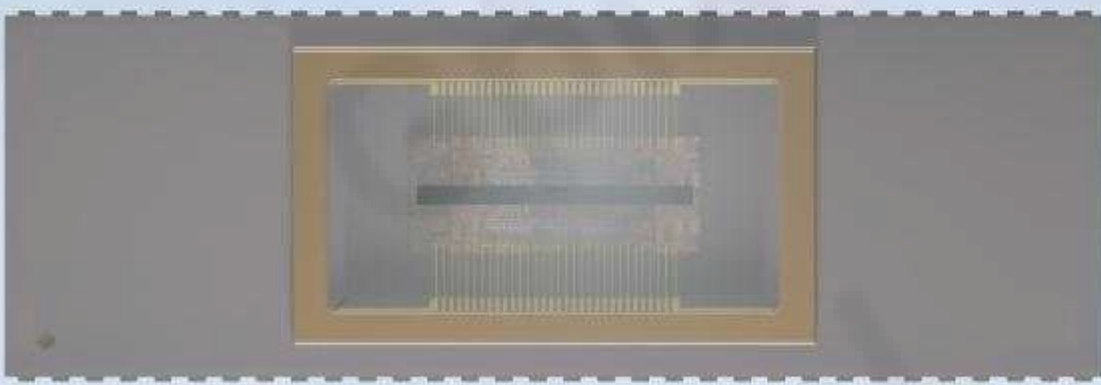
主要应用

半导体检测、工业检测、智能分拣、光谱分析



GIR1201

1024 x 1 InGaAs 线阵图像传感器



GIR1201像素尺寸为12.5 μm x 12.5 μm，分辨率为1024(H) x 1(V)，采用InGaAs感光材料，使其在1550 nm波长处，其量子效率高达75%。通过优化的电路设计来降低读出噪声，芯片在高增益(HG)模式下的满阱为120 ke⁻。在低增益(LG)模式下的最高满阱可达1.6 Me⁻，动态范围高达72 dB。片上集成12 bit ADC，直接数字信号输出，同时采用2对Sub-LVDS接口进行数据传输，最高行频可达71.9 kHz，并且在全速输出下其功耗仅为450 mW。具有极高的片上集成度，以及数字化输出，不仅极大缩短了相机产品的开发周期，同时也进一步提升了工业检测的生产效率，为半导体、光伏检测提供理想解决方案。

产品特性

- Sub-LVDS数字输出

· 片上12 bit ADC
- 动态范围:72 dB

· 最高行频:71.9 kHz

应用领域

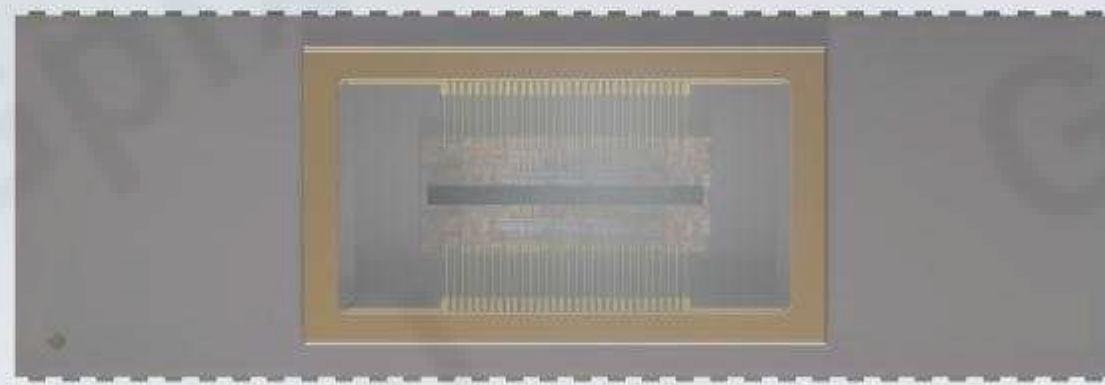
半导体检测、工业检测、智能分拣、光谱分析

产品指标			
有效分辨率	1024(H) x 1(V)	感光面长度	12.8 mm
像素尺寸	12.5 μm × 12.5 μm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	75% (1550 nm)	读出噪声	88 e ⁻ (12 bit,HG)、400 e ⁻ (12 bit,LG)
满阱容量	120 ke ⁻ (12 bit,HG)、1.6 Me ⁻ (12 bit,LG)	PRNU	< 2%
动态范围	62 dB (12 bit,HG)、72 dB (12 bit,LG)	最高行频	71.9 kHz
输出接口	2 对 Sub-LVDS	通道合并	2 to 1
ADC	12 bit	最大数据率	1.68 Gbps
色彩	-	功耗	0.45 W
供电电压	3.3 V (模拟)、1.5 V (数字)、1.8 V (IO)	封装信息	64 pins DIP、57.4mm x 18.9 mm

封装图示	

GIR2505

512 x 2 InGaAs 线阵图像传感器



GIR2505像素尺寸为25 μm x 25 μm，分辨率为512(H) x 2(V)，采用InGaAs感光材料，使其在1550 nm波长处，其量子效率高达75%。通过优化的电路设计来降低读出噪声，芯片在高增益(HG)模式下的满阱为85 ke⁻。在低增益(LG)模式下的最高满阱可达1.6 Me⁻，动态范围高达70 dB。片上集成12 bit ADC，直接数字信号输出，同时采用2对Sub-LVDS接口进行数据传输，最高行频可达40.4 kHz，并且在全速输出下其功耗仅为450 mW。具有极高的片上集成度，以及数字化输出，不仅极大缩短了相机产品的开发周期，同时也进一步提升了工业检测的生产效率，为半导体、光伏检测提供理想解决方案。

产品特性

- Sub-LVDS数字输出

· 片上12 bit ADC
- 动态范围:70 dB

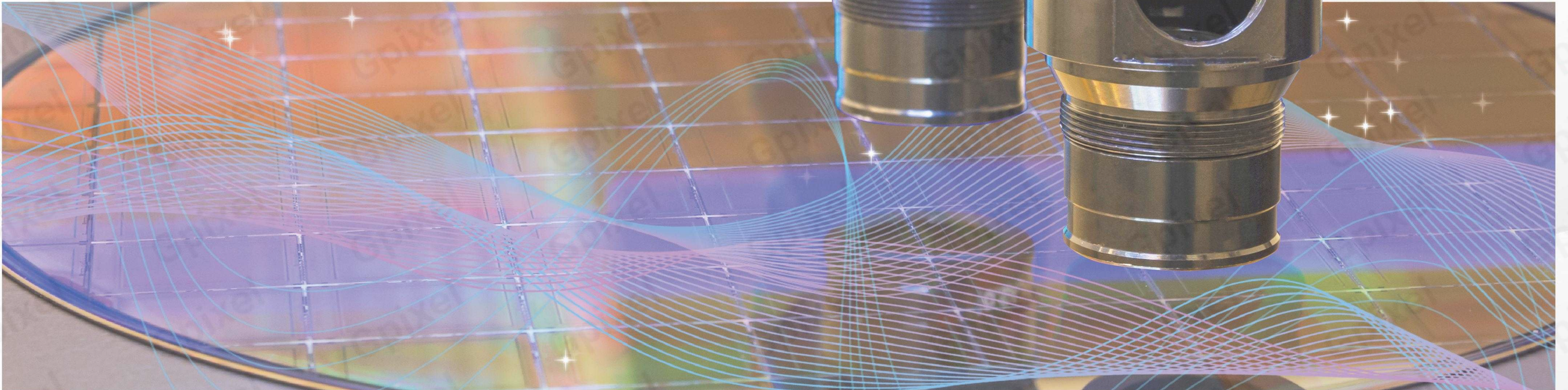
· 最高行频:40.4 kHz

应用领域

半导体检测、工业检测、智能分拣、光谱分析

产品指标			
有效分辨率	512(H) x 2(V)	感光面长度	12.8 mm
像素尺寸	25 μm × 25 μm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	75% (1550 nm)	读出噪声	116 e ⁻ (12 bit,HG)、450 e ⁻ (12 bit,LG)
满阱容量	85 ke ⁻ (12 bit,HG)、1.6 Me ⁻ (12 bit,LG)	PRNU	< 2%
动态范围	58 dB (12 bit,HG)、70 dB (12 bit,LG)	最高行频	40.4 kHz
输出接口	2 对 Sub-LVDS	通道合并	2 to 1
ADC	12 bit	最大数据率	1.68 Gbps
色彩	-	功耗	0.45 W
供电电压	3.3 V (模拟)、1.5 V (数字)、1.8 V (IO)	封装信息	64 pins DIP、57.4mm x 18.9 mm

封装图示	



定制化产品

全定制

- 根据客户的规格定制IC、封装和玻璃盖板
- 芯片架构和详细设计、产品测试和可靠性实验
- 提供一站式服务

半定制

- 根据现有的设计, 对其进行定制
- 彩色滤光片、微透镜
- 封装类型
- 玻璃盖板镀膜
- 芯片终测标准